



Escuela
Politécnica
Superior

Estudio de estructuras con retardo de grupo negativo en tecnología microstrip



Máster Universitario en Ingeniería de
Telecomunicación

Trabajo Fin de Máster

Autora:

Margarita Martínez Coves

Tutores:

Miguel Ángel Sánchez Soriano

Stephan Marini

Septiembre 2020



Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

Estudio de estructuras con retardo de grupo negativo en tecnología microstrip

Autora

Margarita Martínez Coves

Tutores

Miguel Ángel Sánchez Soriano

Stephan Marini

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal



Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación



Escuela
Politécnica
Superior



Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

ALICANTE, Septiembre 2020

Resumen

Los sistemas de telecomunicación que operan en frecuencias de microondas han proliferado mucho en los últimos años. Desde los sistemas de navegación por satélite, pasando por aquellas comunicaciones inalámbricas como WLAN o WMAX o incluso algunas de las bandas reservadas para la telefonía móvil trabajan a dichas frecuencias.

Por todo ello es de gran interés para el avance de las telecomunicaciones disponer de métodos y dispositivos que permitan una comunicación eficiente a frecuencias de microondas. Una de las propuestas que actualmente se baraja para aumentar la eficiencia de los amplificadores, minimizar el estrabismo del haz en sistemas de arrays de antenas, reducir el retardo de las líneas o mejorar el ancho de banda son los dispositivos con retardo de grupo negativo.

En concreto, en este trabajo se estudia una estructura concreta capaz de producir una respuesta con retardo de grupo negativo. Sin embargo, el análisis paramétrico de ciertas estructuras no siempre es trivial, por lo que para poder llevar a cabo el estudio se desarrolla e implementa un sistema de cómputo para obtener un análisis paramétrico por fuerza bruta.

Mediante dicho sistema se analiza la topología propuesta y se caracteriza para obtener respuestas con dos y tres bandas con retardo de grupo negativo, permitiendo así también diseñar dispositivos muy interesantes de cara a sistemas de comunicación que utilicen dos bandas de frecuencia distinta, pues aunaríamos en un solo dispositivo el filtro de ambas.

En conclusión, el presente Trabajo Final de Máster (TFM) expone los principios de la ingeniería de microondas y los aplica al desarrollo de un sistema de procesado y análisis de topologías o estructuras complejas.

Agradecimientos

Este trabajo no habría sido posible sin la inestimable ayuda de mis tutores: Miguel Ángel y Stephan. En concreto, me gustaría agradecer personalmente a Miguel Ángel, que no sólo ha sido un apoyo académico para la realización de este trabajo, sino también una gran inspiración como profesional. Gracias por todo el tiempo invertido durante la elaboración de este TFM, las ideas, las correcciones y los mensajes de ánimo. Gracias a los dos por estos últimos días, pero sobre todo muchísimas gracias por darme la oportunidad de aprender con vosotros de este ámbito de la ingeniería.

*Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty.
Anyone who keeps learning stays young.*

Henry Ford (1843-1947)

Índice general

1. Introducción y motivación	1
1.1. Estado del Arte	2
1.1.1. Dispositivos activos	2
1.1.2. Dispositivos pasivos	3
1.1.3. Dispositivos multibanda	4
2. Marco Teórico	7
2.1. Ingeniería de Microondas	7
2.1.1. Teoría de Líneas de Transmisión	7
2.1.2. Líneas Microstrip	9
2.1.3. Análisis de Redes de Microondas	11
2.1.3.1. Matriz de Scattering	12
2.1.3.2. Matriz de transmisión ABCD	13
3. Topología bajo estudio y objetivos	17
4. Desarrollo	19
4.1. Estudio Paramétrico	19
4.1.1. Cálculo de la respuesta de la topología	19
4.1.2. Análisis de la respuesta de la topología	22
4.1.3. Análisis paramétrico	28
4.1.4. Curvas de diseño	30
4.2. Diseño de Prototipos	32
4.2.1. Síntesis de los parámetros eléctricos	32
4.2.2. Simulación Microstrip (ADS)	34
4.2.3. Simulación de onda completa (Sonnet)	38
5. Resultados	41
5.1. Análisis paramétrico	41
5.1.1. Modelo 1 - Doble Banda	41
5.1.2. Modelo 1 - Triple Banda	53
5.1.3. Modelo 1 - Banda Central	69
6. Conclusiones y líneas futuras	71
Bibliografía	73

A. Equivalencias entre parámetros para redes de dos puertos	79
B. Tutorial ADS	81
B.1. Creación de un circuito con ADS	81
B.1.1. Componentes genéricos	82
B.1.1.1. Term	82
B.1.1.2. Resistencia	83
B.1.1.3. Variable	84
B.1.1.4. Línea de transmisión ideal	85
B.1.1.5. Línea de transmisión Microstrip	86
B.1.1.6. Conexión microstrip en 'T'	87
B.1.1.7. Substrato de componentes Microstrip	88
B.1.2. Componentes para Simulación	89
B.1.2.1. Parámetros S	89
B.1.2.2. Optimización	90
B.1.2.3. Objetivo	91
B.1.3. Simulación y Visualización	92
C. Tutorial Sonnet	95
C.1. Interfaz de Sonnet	95
C.2. Creación de un prototipo con Sonnet	96
C.2.1. Configuración del prototipo	96
C.2.1.1. Units	96
C.2.1.2. Box	97
C.2.1.3. Dielectric Layers	98
C.2.1.4. Metal Types	99
C.2.2. Diseño geométrico del prototipo	99
C.2.2.1. Añadir una tira microstrip	99
C.2.2.2. Parametrizar las dimensiones de las tiras	100
C.2.2.3. Añadir los Puertos	104
C.2.2.4. Añadir Resistencias	105
C.2.2.5. Añadir Planos de Referencia	105
C.2.3. Configuración de la simulación	106
C.2.4. Simulación y Visualización	106
D. Códigos Matlab	109
E. Códigos Python	141

Índice de figuras

1.1. El espectro electromagnético (Traducción de la Figura 1.1 de [1]) . . .	1
1.2. Diagrama de un filtro transversal.	3
1.3. Diagrama general de un filtro interferencial.	4
2.1. Equivalente eléctrico por elementos concentrados de una línea de transmisión	8
2.2. Representación de una línea Microstrip. (a) Geometría y especificación. (b) Líneas de campo magnético (H) y eléctrico (E)	9
2.3. Representación general de una red de dos puertos	12
2.4. Representación general de una red de dos puertos	14
3.1. Topología propuesta: Modelo 1	17
4.1. Circuito simulado en (ADS) (Modelo 1)	19
4.2. Respuesta del Modelo 1 con la configuración de la Tabla 4.1	20
4.3. Análisis de redes de microondas aplicado al Modelo 1	21
4.4. Respuesta del Modelo 1 con la configuración de la Tabla 4.1 simulada en MATLAB ®Mathworks (MATLAB ®)	23
4.5. Esquema del multiprocesado por casos del Modelo 1	25
4.6. Búsqueda de mínimos de interés	27
4.7. Aplicación desarrollada para analizar paramétricamente el sistema . . .	29
4.8. Histogramas de las variables para el Modelo 1 - Doble Banda	30
4.9. Aplicación desarrollada para generar curvas de diseño	31
4.10. Herramienta LineCalc de Advanced Design System ®Keysight (ADS) .	32
4.11. Esquema genérico de implementación del Modelo 1	33
4.12. Circuito simulado en ADS con líneas microstrip (Modelo 1)	34
4.13. Diagrama de la relación entre los anchos del conector en 'T' y sus puertos. (a) Símbolo en ADS. (b) Esquema físico	35
4.14. Respuesta con el conector 'T' mal configurado (Modelo 1)	36
4.15. Respuesta con el conector 'T' correctamente configurado (Modelo 1) .	37
4.16. Prototipo en Sonnet (Modelo 1)	38
4.17. Respuesta de la simulación en Sonnet	39
5.1. Negative Group Delay (NGD) frente a atenuación y ancho de banda (Análisis Modelo 1 - Doble Banda)	43

5.2. NGD frente a atenuación y relación entre bandas (Análisis Modelo 1 - Doble Banda)	44
5.3. Histogramas de las variables para el Modelo 1 - Doble Banda	44
5.4. Curva de diseño en función de NGD	45
5.5. Curva de diseño en función del parámetro $S(2, 1)$	45
5.6. Curva de diseño en función del ancho de banda	46
5.7. Curva de diseño en función de la relación entre bandas laterales	46
5.8. Curva de diseño en función del parámetro $S(1, 1)$	47
5.9. Curva de diseño en función del parámetro $S(2, 2)$	47
5.10. Respuesta ideal para la configuración seleccionada	48
5.11. Diseño del prototipo en Sonnet (Rogers 4003)	49
5.12. Respuesta del prototipo en Sonnet (Rogers 4003)	50
5.13. Diseño del prototipo en Sonnet (TLX-8)	51
5.14. Respuesta del prototipo en Sonnet (TLX-8)	52
5.15. Análisis Modelo 1 - Triple Banda para las bandas laterales	56
5.16. Análisis Modelo 1 - Triple Banda para la banda central	57
5.17. Histogramas de las variables para el Modelo 1 - Triple Banda	58
5.18. Curva de diseño en función de la relación entre bandas laterales	58
5.19. Curva de diseño en función de NGD	59
5.20. Curva de diseño en función de NGD de las bandas laterales	59
5.21. Curva de diseño en función de NGD de la banda central	60
5.22. Curva de diseño en función del parámetro $S(2, 1)$ de las bandas laterales	60
5.23. Curva de diseño en función del parámetro $S(2, 1)$ de la banda central	61
5.24. Curva de diseño en función del ancho de banda de las bandas laterales	61
5.25. Curva de diseño en función del ancho de banda de la banda central	62
5.26. Curva de diseño en función del parámetro $S(1, 1)$ de las bandas laterales	62
5.27. Curva de diseño en función del parámetro $S(1, 1)$ de la banda central	63
5.28. Curva de diseño en función del parámetro $S(2, 2)$ de las bandas laterales	63
5.29. Curva de diseño en función del parámetro $S(2, 2)$ de la banda central	64
5.30. Respuesta ideal para la configuración seleccionada	64
5.31. Diseño del prototipo en Sonnet (Rogers 4003)	65
5.32. Respuesta del prototipo en Sonnet (Rogers 4003)	66
5.33. Diseño del prototipo en Sonnet (TLX-8)	67
5.34. Respuesta del prototipo en Sonnet (TLX-8)	68
5.35. NGD frente a atenuación y ancho de banda (Análisis Modelo 1 - Banda Central)	70
6.1. Variaciones del modelo propuesto. (a) Modelo 2. (b) Modelo 3. (c) Modelo 4.	72
B.1. Componente Term	82
B.2. Componente Resistencia	83
B.3. Componente Variable	84

B.4. Componente Variable	85
B.5. Componente para conexión en 'T'	86
B.6. Componente conexión en 'T'	87
B.7. Componente Substrato Microstrip	88
B.8. Componente Parámetros S	89
B.9. Componente Optimización	90
B.10. Componente Objetivos	91
B.11. Ventana de ajuste	92
B.12. Representación gráfica de las variables	93
B.13. Opciones para la representación	94
C.1. Ventana principal de Sonnet	95
C.2. Editor de Sonnet	96
C.3. Configuración de las unidades	97
C.4. Configuración de la caja	97
C.5. Configuración de las capas dieléctricas	98
C.6. Configuración de los metales conductores	99
C.7. Línea de transmisión generada mediante un rectángulo	100
C.8. Selección de nodos a parametrizar mediante el método de anclado	101
C.9. Diálogo de creación el parámetro	102
C.10. Selección de nodos a parametrizar mediante el método simétrico	103
C.11. Diálogo de creación el parámetro	103
C.12. Creación de tiras para situar los puertos	104
C.13. Diálogo de configuración del puerto	104
C.14. Añadir un componente al prototipo	105
C.15. Añadir un plano de referencia	106
C.16. Configuración del análisis	107
C.17. Entorno de visualización	108
C.18. Entorno de visualización con múltiples respuestas	108

Índice de tablas

1.1. Comparativa entre distintas implementaciones de filtros activos con retardo de grupo negativo.	3
1.2. Comparativa entre distintas implementaciones de filtros pasivos con retardo de grupo negativo.	4
1.3. Comparativa de los filtros dual-band con NGD hasta la fecha.	5
2.1. Parámetros ABCD equivalentes	14
4.1. Valores para el Modelo 1	20
4.2. Variables y posibles valores	24
4.3. Parámetros de interés para la caracterización paramétrica	26
4.4. Parámetros de configuración de LineCalc	33
4.5. Dimensiones físicas para las líneas de transmisión del Modelo 1	35
5.1. Análisis numérico del Modelo 1 - Doble Banda	42
5.2. Valores seleccionados para las pruebas del Modelo 1 - Doble Banda	42
5.3. Valor de los parámetros para el caso elegido del Modelo 1 - Doble Banda	42
5.4. Dimensiones físicas para el caso bajo estudio del Modelo 1 - Doble Banda	42
5.5. Comparación entre la respuesta ideal y la simulada en onda completa	53
5.6. Análisis numérico del Modelo 1 - Triple Banda	54
5.7. Valores seleccionados para las pruebas del Modelo 1 - Triple Banda	54
5.8. Valor de los parámetros para el caso elegido del Modelo 1 - Doble Banda	54
5.9. Dimensiones físicas para el caso bajo estudio del Modelo 1 - Triple Banda	55
5.10. Comparación entre la respuesta ideal y la simulación en onda completa - Triple Banda	69
5.11. Análisis numérico del Modelo 1 - Banda Central	70
A.1. Conversión entre parámetros de redes de dos puertos	80

1. Introducción y motivación

Los sistemas de telecomunicación han proliferado mucho en los últimos siglos. Desde los primeros sistemas telegráficos en 1794 hasta las modernas comunicaciones ópticas a partir de 1973, pasando por todas aquellas comunicaciones *wireless*, sin un medio guiado. La carrera por aumentar la velocidad, fiabilidad y alcance de nuestras comunicaciones nos ha llevado a desarrollar técnicas y tecnologías muy variadas. Una posible clasificación de los sistemas de telecomunicación, se fundamenta en su frecuencia de funcionamiento. Concretamente, este TFM se centra en aquellos que trabajan en frecuencias de microondas, entendiendo como tales aquellas ondas electromagnéticas cuya longitud de onda se ubica entre 1 m y 1 mm (300 y 300000 MHz) [1].

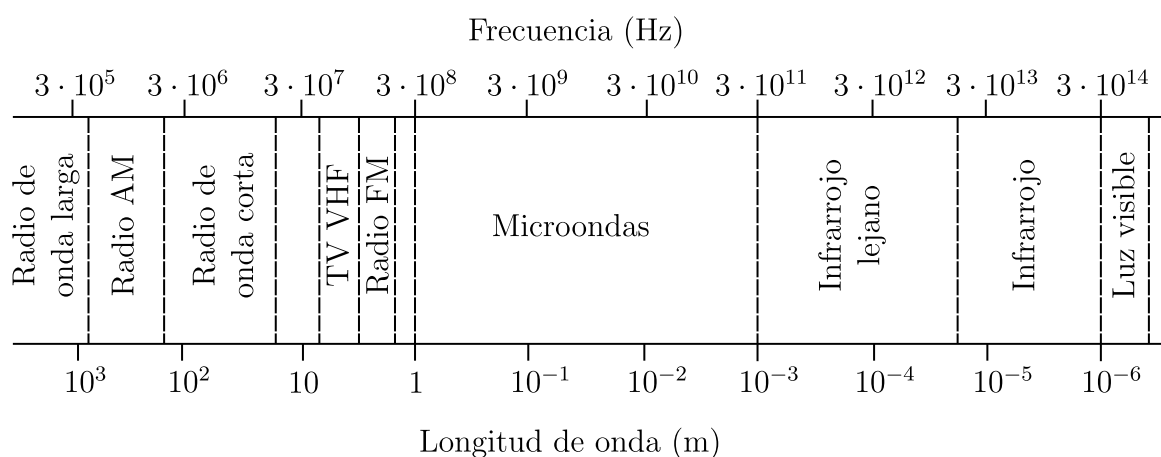


Figura 1.1: El espectro electromagnético (Traducción de la Figura 1.1 de [1])

Dentro de este rango de frecuencias, y concretamente en las bandas situadas entre 1 y 5 GHz, encontramos diversas aplicaciones como sistemas radar para servicios de radiolocalización o localización y navegación por satélite GALILEO [2]. A nivel de conexionado de redes, también se destinan diversas bandas alrededor de los 2,4 y 5 GHz para aplicaciones Wireless Local Area Network (WLAN) [3]; y para telefonía móvil también se reservan y subastan múltiples bandas para diferentes generaciones de comunicaciones móviles.

Teniendo presente estos datos, es de gran interés para la sociedad disponer de métodos y dispositivos que permitan una correcta y eficiente comunicación en frecuencias de microondas. En base a esto, durante los últimos años se han comenzado a desarrollar dispositivos con retardo de grupo negativo (de ahora en adelante NGD). Los objeti-

vos de dichos dispositivos pueden ser: incrementar la eficiencia de los amplificadores de prealimentación lineal, minimizar el estrabismo del haz en sistemas de arrays de antenas, reducir el retardo de la línea o mejorar el ancho de banda [4].

1.1. Estado del Arte

En 1954 Sommerfeld [5] y en 1960 Brillouin [6], publicaron sus trabajos acerca del comportamiento de la luz al propagarse en la región electromagnética de medios dispersivos con índice de refracción n . Teóricamente, en la región donde la línea espectral se define como una línea de absorción, la velocidad de grupo ($v_g(\omega)$ en la Ecuación (1.1)) puede ser superior a la velocidad de la luz en el vacío, c , e incluso negativa [7]. Este fenómeno de velocidad de grupo negativa fue confirmado en 1970 por Garret y McCumber [8], demostrando así la posibilidad de propagar un pulso Gaussiano con un retardo de grupo negativo, donde el retardo de grupo $\tau_g(\omega)$ queda definido mediante la Ecuación (1.2)

$$v_g(\omega) = \frac{c}{\text{Re}[n(\omega)] + \text{Re}[dn(\omega)/d\omega]} \quad (\text{m/s}), \quad (1.1)$$

$$\tau_g(\omega) = -\frac{\partial \phi(\omega)}{\partial \omega} \quad (\text{s}). \quad (1.2)$$

Múltiples investigaciones, tanto teóricas como experimentales, han sido llevadas a cabo desde entonces para concretar e ilustrar este fenómeno: basadas en el análisis de medios con una función de transferencia con doble pico de ganancia (*gain-doublet*) [9, 10]; constatando que los pulsos electromagnéticos pueden propagarse de forma superlumínica en aquellos medios que permiten la propagación sin dispersión [11]; o demostrando la posibilidad de incorporar una velocidad de grupo negativa en líneas de transmisión *left-handed* o con índice de refracción negativo [12, 13].

El fenómeno de retardo de grupo negativo puede parecer en un principio estar contradiciendo el principio de causalidad, sin embargo este principio físico es respetado ya que tanto el transitorio inicial como final de la señal impulso están limitados a la velocidad del frente de ondas, la cual nunca supera la velocidad de la luz [14, 15]. De hecho, aquellos dispositivos que presentan NGD pueden ser considerados como un predictor ya que la señal a la salida del circuito está adelantada con respecto a la entrada [16].

El diseño de estos dispositivos con NGD se aborda desde distintas perspectivas, que de forma global podemos clasificar en dos grupos: circuitos activos o pasivos.

1.1.1. Dispositivos activos

Desde años 90s, se comenzaron a implementar topologías con retardo de grupo negativo basadas en filtros amplificadores [17, 15]. Estos circuitos activos con NGD están

basados esencialmente en el concepto de filtros transversales (Figura 1.2), los cuales se han utilizado normalmente en la ecualización y la conformación de pulsos. Para conseguir NGD con estos diseños, es necesario seleccionar una ganancia adecuada para cada amplificador distribuido del circuito [18].

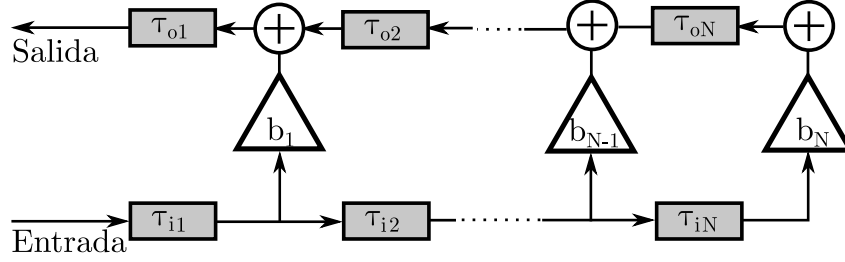


Figura 1.2: Diagrama de un filtro transversal.

En la Tabla 1.1 se exponen los resultados más relevantes hasta la fecha de filtros activos con retardo de grupo negativo.

Ref.	f_0 (GHz)	τ_g (ns)	$BW(f_0)$ (MHz)	S_{21} (dB)
[19]	0,31	-1,52	120	0,29
[20]	1	-10	40	30
[21]	1	-10	40	30
[22]	1	-2,3	150	2,3
[23]	1,03	-2,3	150	1,68
[24]	0,454	-1,52	103	0,069
[18]	1	-1	200	-7,8

Tabla 1.1: Comparativa entre distintas implementaciones de filtros activos con retardo de grupo negativo.

1.1.2. Dispositivos pasivos

Por otro lado, a partir del año 2000 se comienza a estudiar y diseñar dispositivos pasivos capaces de producir NGD. Los circuitos pasivos con retardo de grupo negativo tienen por inconveniente un alto coeficiente de atenuación proporcional al NGD conseguido, es por ello que desde entonces muchos estudios tienen por meta mejorar esta característica.

Una de las propuestas explotadas para conseguir filtros pasivos con retardo de grupo negativo se basa principalmente en técnicas interferenciales. Inicialmente, este diseño

se propuso para obtener filtros banda eliminada (*bandstop*) compactos y con un amplio ancho de banda [25, 26, 27], sin embargo convenientemente ajustados pueden producir retardos de grupo negativos con atenuaciones aceptables. Estos dispositivos interferenciales se basan en la construcción de dos líneas de transmisión paralelas pero desfasadas 180° (Figura 1.3).

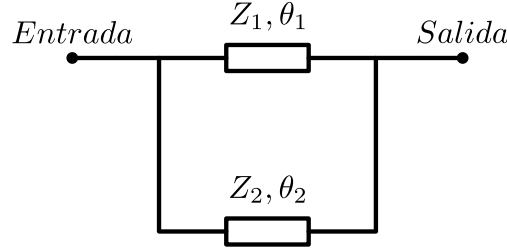


Figura 1.3: Diagrama general de un filtro interferencial.

En la Tabla 1.2 se exponen los resultados más relevantes hasta la fecha de filtros pasivos con retardo de grupo negativo.

Ref.	f_0 (GHz)	τ_g (ns)	BW(f_0) (MHz)	S_{21} (dB)
[28]	2,4	-9	30	-63
[29]	4,5	0,05	3000	-10
[4]	1,962	-7,3	100	-22,65
[4]	1,962	-6,5	200	-35,2
[4]	1,962	-6,5	90	-21,2
[4]	1,962	-6,5	150	-32,94
[30]	2,125	-8,2	40	-37,84
[31]	1,96	-1,1	990	-29,3
[16]	1	-0,8	320	-15

Tabla 1.2: Comparativa entre distintas implementaciones de filtros pasivos con retardo de grupo negativo.

1.1.3. Dispositivos multibanda

Desde 2010 han comenzado a aparecer los primeros estudios sobre dispositivos multibanda, concretamente de dos bandas (*dual-band*) con retardo de grupo negativo. Estos circuitos NGD se basan en los mismos principios que los de una sola banda, sin embargo además de la ya descrita diferencia entre activos y pasivos, podemos diferenciar también aquellos que consiguen dos bandas de funcionamiento debido a una configuración multietapa de aquellos que no. Esta característica otorga mayor independencia entre

las características de una banda y otra, pero también aumenta considerablemente el tamaño del dispositivo final. En la Tabla (1.3) se exponen cronológicamente todos los dispositivos (*dual-band*) hasta la fecha con sus características.

Ref.	f_1 (GHz)	f_2 (GHz)	$\tau_g(f_1)$ (ns)	$\tau_g(f_2)$ (ns)	BW(f_1) (MHz)	BW(f_2) (MHz)	$S_{21}(f_1)$ (dB)	$S_{21}(f_2)$ (dB)
[32] ¹	2, 14	3, 15	-7, 2	-6, 5	—	—	-30	-30
[33] ²	1, 05	2, 05	-1, 16	-0, 92	400	605	> 0	> 0
[34]	2, 14	3, 50	-3	-3, 1	40	80	-34, 2	-34, 9
[35] ³	3, 5	5, 15	-4, 54	-4, 20	120	100	-47, 35	-38, 8
[36] ³	3, 38	4, 7	-3, 86	-3, 26	120	130	-36, 22	-34, 92
[37]	3, 50	5, 20	-5	-5	200	400	-13	-19, 5
[38]	0, 667	1, 377	-1, 19	-1, 19	231	227	-18, 2	-18, 2

¹ No se proporcionan datos sobre el ancho de banda, pero se describe como estrecho

² Circuito activo

³ Circuito de dos etapas

Tabla 1.3: Comparativa de los filtros dual-band con NGD hasta la fecha.

El auge de tecnologías *dual-band* como Worldwide Interoperability for Microwave ACcess (WiMAX) o la transmisión WLAN en 2,4 GHz y 5 GHz desde un mismo dispositivo, hacen de los circuitos con retardo de grupo negativo multibanda una línea de investigación más que interesante. Éstos permitirían abaratar costes de producción en dichas tecnologías, mejorar sus prestaciones y facilitar la miniaturización.

2. Marco Teórico

Actualmente las herramientas de computación nos permiten realizar estudios y simulaciones multifísicas exhaustivas. En este sentido, es posible generar modelos que anticipen la respuesta del dispositivo a nivel ideal o bajo condiciones similares a las reales. En este capítulo abordaremos las bases científicas y técnicas de las herramientas y conceptos necesarios para realizar un estudio de estructuras con retardo de grupo negativo en tecnología microstrip.

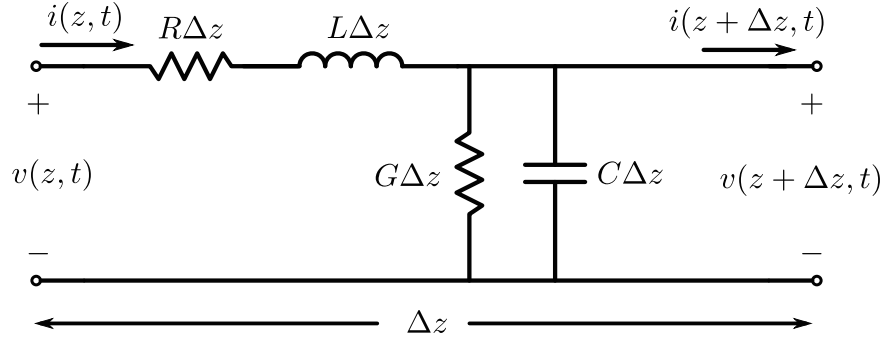
2.1. Ingeniería de Microondas

El diseño y el estudio de dispositivos de Radiofrecuencia (RF) y microondas se asienta sobre las bases de la teoría electromagnética y, por ende, de las ecuaciones de Maxwell. Mientras que para frecuencias bajas es posible modelar el sistema mediante elementos concentrados siguiendo así la teoría de circuitos; para frecuencias altas es necesario optar por un modelo de elementos distribuidos propio de la teoría de líneas de transmisión o, directamente, por la solución teórica del campo electromagnético mediante las ecuaciones de Maxwell [1].

Este requerimiento propio de la alta frecuencia se debe a la relación entre la longitud física (l) y la longitud de onda (λ). Puesto que $\lambda = c/f$, para frecuencias bajas, como los 50 o 60 Hz de la red eléctrica, tenemos longitudes de onda equivalentes al radio de la tierra. Ante tales órdenes de magnitud, podemos asumir que los cambios de la longitud física no afectan en exceso a la fase de la señal a transmitir. Sin embargo, tal y como hemos comentado en el capítulo 1, para las frecuencia de microondas esta longitud de onda va desde 10 cm a 1 mm, por lo que pequeñas variaciones en la longitud física ocasionan cambios significativos en la fase.

2.1.1. Teoría de Líneas de Transmisión

Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, la teoría de circuitos no es aplicable para el estudio de redes de microondas. Una posible solución sería el estudio de los campos eléctrico y magnético mediante la resolución de las ecuaciones de Maxwell, sin embargo es una opción costosa y poco eficiente ya que aporta información, en muchas ocasiones, no necesaria. La teoría de líneas de transmisión tiende un puente entre ambas opciones, pudiendo estudiarse como una extensión de la teoría de circuitos o como una particularización de las ecuaciones de Maxwell [39]. Para definir los conceptos generales necesarios para este TFM partiremos de la teoría de circuitos.



R = Resistencia por unidad de longitud (Ω/m)
 L = Inductancia por unidad de longitud (H/m)
 G = Conductancia por unidad de longitud (S/m)
 C = Capacitancia por unidad de longitud (F/m)

Figura 2.1: Equivalente eléctrico por elementos concentrados de una línea de transmisión

Es posible definir una línea de transmisión mediante el equivalente circuitual de la Figura 2.1, que modela una línea de dos conductores, que es el mínimo necesario para que se dé el modo de propagación Transversal Electromagnético (TEM). A partir de los parámetros electromagnéticos (R , L , G y C) podemos determinar la propagación de las ondas en dicha línea. La constante de propagación (γ) queda definida en función de la frecuencia (ω):

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} \quad (\text{Np/m}), \quad (2.1)$$

donde (α) se corresponde con el coeficiente de atenuación y (β) al coeficiente de fase. Además, la impedancia característica de la línea (Z_0) queda definida por:

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} \quad (\Omega). \quad (2.2)$$

Por otro lado, puesto que la longitud de onda λ se define como la distancia dos puntos consecutivos que mantengan la misma fase, ésta se puede definir para una línea de transmisión como:

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} \quad (\text{m}). \quad (2.3)$$

Y, ya que la velocidad de fase o propagación (v_p) es la velocidad a la que un punto de fase constante se propaga, se obtiene la relación:

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} = \lambda f \quad (\text{m/s}). \quad (2.4)$$

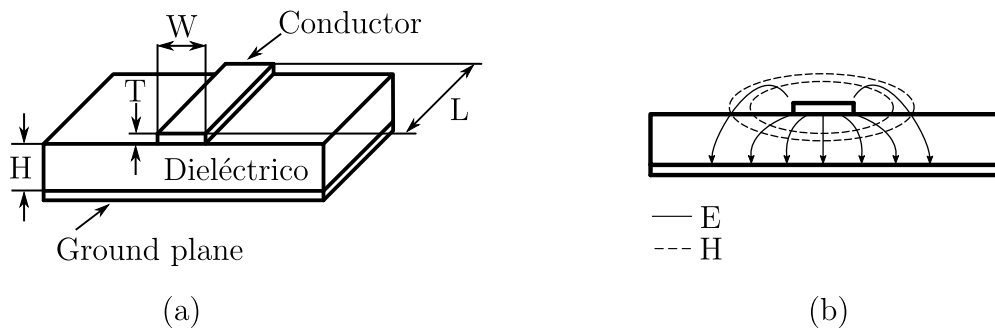
De la Ecuación 2.1 se intuye que en medios sin pérdidas ($\alpha = 0$) es posible simplificar

las ecuaciones. También, la posibilidad obtener los valores de voltaje y corriente a la entrada y la salida del circuito de la Figura 2.1 aplicando las leyes de Kirchhoff para el análisis de circuitos.

2.1.2. Líneas Microstrip

La tecnología Microstrip nace en 1952 de la mano de Grieg y Engelmann en los laboratorios de *ITT Federal Telecommunications* [40]. Esta tecnología nace de la evolución de los sistemas de transmisión coaxial planar y de líneas paralelas durante la Segunda Guerra Mundial [41]. En la actualidad, las líneas Microstrip son una de las tecnologías de líneas de transmisión planar más utilizadas ya que permite optimizar el tamaño del dispositivo y la integración con dispositivos activos y pasivos es sencilla [42].

En la Figura 2.2 se representa esquemáticamente una línea microstrip, indicando en (a) su composición así como las medidas geométricas relevantes y en (b) el comportamiento de las líneas de campo.



W: Ancho del conductor (mm)
 L: Longitud del conductor (mm)
 T: Espesor del conductor (mm)
 H: Espesor del substrato dieléctrico (mm)

Figura 2.2: Representación de una línea Microstrip. (a) Geometría y especificación. (b) Líneas de campo magnético (H) y eléctrico (E)

El análisis de una línea microstrip es algo más complejo que el de la línea de transmisión estudiada en el apartado 2.1.2. Esto se debe a que, a diferencia de otras tecnologías, el medio dieléctrico en el que está sumergido el conductor no es homogéneo: está rodeado por un substrato dieléctrico (de permitividad relativa $\epsilon_r > 1$) y el aire ($\epsilon_r = 1$). Si este dieléctrico no estuviese presente, el dispositivo sería una línea de dos conductores compuesta por una tira (*strip*) conductora sobre el plano de tierra (*ground plane*). En ese hipotético caso sería una línea de transmisión TEM simple como la del apartado anterior [42].

Sin embargo, en las líneas microstrip, este doble material dieléctrico provoca que

no todos los campos electromagnéticos estén contenidos en el substrato dieléctrico. Aunque la mayoría de líneas de campo se encuentran en dicha región (Figura 2.2 (b)), algunas de ellas se propagan por el aire, impidiendo así una transmisión TEM pura. La velocidad de fase en el dieléctrico sería $v_p = c/\sqrt{\epsilon_r}$ mientras que en el aire sería igual a la velocidad de la luz c .

El análisis exacto del campo electromagnético en una línea microstrip es complicado. Por suerte, a bajas frecuencias el régimen es quasi-TEM (el comportamiento es prácticamente el mismo que en corriente continua [42]), lo cual nos permite expresar la velocidad de fase y constante de propagación como:

$$v_p = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_{r,eff}}} \quad (\text{m/s}), \quad (2.5a)$$

$$\beta = k_0 \sqrt{\epsilon_{r,eff}} \quad (\text{Np/m}), \quad (2.5b)$$

donde $k_0 = 2\pi f/c$ y $\epsilon_{r,eff}$ es la permitividad efectiva del dieléctrico se puede calcular a partir de la siguiente aproximación:

$$\epsilon_{r,eff} \approx \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} \sqrt{1 + \frac{12H}{W}}, \quad (2.6)$$

El cálculo de la frecuencia de corte a partir de la cual efectos parásitos aparecen no es objeto de este TFM. A modo de aproximación, se puede estimar que para $H \ll \lambda$ (H inferior al 10% de λ) el régimen de propagación es quasi-TEM y es posible definir la impedancia característica de la línea mediante la siguiente expresión:

$$Z_0 \approx \begin{cases} \frac{60}{\sqrt{\epsilon_{r,eff}}} \ln \left(\frac{8H}{W} + \frac{W}{4H} \right) & \text{si } W/H \leq 1 \\ \frac{120\pi}{\sqrt{\epsilon_{r,eff}}} \left[\frac{W}{H} + 1,393 + 0,667 \ln \left(\frac{W}{H} + 1,444 \right) \right]^{-1} & \text{si } W/H \geq 1 \end{cases} \quad (\Omega) \quad (2.7)$$

Donde para obtener el ratio W/H es necesario aplicar las siguientes expresiones:

$$\frac{W}{H} \approx \begin{cases} \frac{8e^A}{e^{2A} - 2} & \text{si } W/H \leq 2 \\ \frac{2}{\pi} \left[B - 1 - \ln(2B - 1) + \frac{\epsilon_r - 1}{2\epsilon_r} \left(\ln(B - 1) + 0,39 - \frac{0,61}{\epsilon_r} \right) \right] & \text{si } W/H \geq 2 \end{cases} \quad (2.8)$$

$$A = \frac{Z_0}{60} \sqrt{\frac{\epsilon_r + 1}{2}} + \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 1} \left(0,23 + \frac{0,11}{\epsilon_r} \right) \quad (2.9a)$$

$$B = \frac{377\pi}{2Z_0\sqrt{\epsilon_r}} \quad (2.9b)$$

Para conocer la longitud de la línea (L) se aplica la siguiente relación:

$$\ell = \frac{\theta}{\beta} \quad (\text{m}) \quad (2.10)$$

donde θ es el desfase en radianes producido por la línea.

Por otro lado, para calcular la atenuación de la línea microstrip es necesario tener en cuenta la atenuación debida al sustrato dieléctrico (α_d) y la atenuación debida al conductor (α_c) [43]:

$$\alpha = \alpha_d + \alpha_c \quad (\text{Np/m}). \quad (2.11)$$

Aunque en muchos casos las pérdidas del dieléctrico son menos relevantes que las debidas al conductor (especialmente si se trabaja a baja frecuencia) ambas pueden ser calculadas mediante las siguientes aproximaciones [44]:

$$\alpha_d = \frac{\pi\epsilon_r}{\lambda\sqrt{\epsilon_{r,eff}}} \frac{(\epsilon_{r,eff} - 1)}{(\epsilon_r - 1)} \tan(\delta) \quad (\text{Np/m}), \quad (2.12a)$$

$$\alpha_c = \frac{R_s}{Z_0 W} = \frac{\sqrt{\omega\mu_0/2\sigma}}{Z_0 W} \quad (\text{Np/m}), \quad (2.12b)$$

donde σ es la conductividad eléctrica del conductor y μ_0 la permeabilidad magnética del medio.

2.1.3. Análisis de Redes de Microondas

Tal y como se ha ilustrado a lo largo de este capítulo, el análisis de un dispositivo de microondas puede llegar a complicarse en exceso mediante el estudio del campo electromagnético. Ante esto, existe la posibilidad de analizar estos dispositivos mediante lo que se conoce como Red de Microondas. En la Figura 2.3 se muestra el esquema de una red de microondas de dos puertos, que se corresponde con las analizadas en este TFM, aunque una red puede constar de N-puertos.

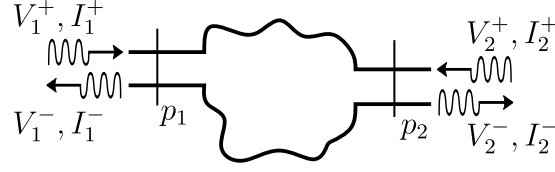


Figura 2.3: Representación general de una red de dos puertos

La ventaja de éste análisis reside en la visión de todo el dispositivo como una matriz que describe su comportamiento:

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} \quad (2.13)$$

Donde $[Z]$ sería la matriz de impedancia y es igual a la inversa de la admitancia $[Y]$, mediante la cual también podemos describir la red:

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} \quad (2.14)$$

donde cabe destacar que los valores de voltaje y corriente implican a los valores incidentes y reflejados:

$$V_n = V_n^+ + V_n^- \quad (\text{V}) \quad (2.15a)$$

$$I_n = I_n^+ - I_n^- \quad (\text{A}) \quad (2.15b)$$

En este sentido, es complicado medir voltajes y corrientes directamente a frecuencia de microondas debido a la influencia de la fase, tal y como hemos comentado al inicio de este capítulo. Por ello existen también otras matrices que describen el sistema, como la matriz de dispersión o *Scattering* o la matriz de transmisión ABCD. Ya que en el presente TFM se hace uso de éstas dos últimas para obtener la respuesta del sistema, se hará hincapié en ellas.

En cualquiera de los casos, para analizar una red de microondas es imprescindible conocer la impedancia característica (Z_0), constante de propagación (β) y/o longitud eléctrica (ℓ) de los elementos que la conforman. Por suerte, en este TFM se analizan redes con elementos conocidos y esto facilita el proceso.

2.1.3.1. Matriz de Scattering

Para una red de dos puertos donde V_n^+ es la amplitud de la onda incidente y V_n^- de la reflejada, la matriz de Scattering se define como:

$$\begin{bmatrix} V_1^- \\ V_2^- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1^+ \\ V_2^+ \end{bmatrix} \quad (2.16)$$

De esta forma, si analizamos cada elemento de la matriz $[S]$, se definen como:

$$S_{ij} = \left. \frac{V_i^-}{V_j^+} \right|_{V_k^+=0 \text{ para } k \neq j} \quad (2.17)$$

por lo tanto: S_{11} : Coeficiente de reflexión del puerto de entrada.

S_{21} : Coeficiente de transmisión.

S_{12} : Coeficiente de transmisión inversa.

S_{22} : Coeficiente de reflexión del puerto de salida.

Cabe destacar la condición expresada en la Ecuación 2.17: todo aquel puerto que no sea sujeto del cálculo del parámetro en cuestión debe estar adaptado en impedancia para evitar reflexiones.

Tal y como se detallará en el Capítulo 3, el dispositivo bajo estudio en este TFM es recíproco. Una red de microondas recíproca no la compone ningún elemento activo o no recíproco como ferrita o plasma [45]. Bajo estas condiciones es posible demostrar que las matrices de impedancia $[Z]$, admitancia $[Y]$ y Scattering $[S]$ son simétricas, es decir: $Z_{ij} = Z_{ji}$, $Y_{ij} = Y_{ji}$ y $S_{ij} = S_{ji}$. Por lo que en una red de dos puertos $S_{21} = S_{12}$.

Por otro lado, si la red bajo análisis no tiene pérdidas es posible demostrar que la matriz de Scattering es unitaria y se cumpliría, para una red de dos puertos, que:

$$|S_{11}|^2 + |S_{21}|^2 = 1 \quad (2.18a)$$

$$|S_{22}|^2 + |S_{12}|^2 = 1 \quad (2.18b)$$

En el caso de que sí existan pérdidas, es posible calcularlas añadiendo dicho término:

$$|S_{11}|^2 + |S_{21}|^2 + \text{Loss}_1 = 1 \quad (2.19a)$$

$$|S_{22}|^2 + |S_{12}|^2 + \text{Loss}_2 = 1 \quad (2.19b)$$

Por otro lado, la fase $\phi(\omega)$ de la red, necesaria para calcular el retardo de grupo negativo (Ecuación 1.2), se corresponde con la fase del coeficiente de transmisión:

$$\phi(\omega) = \arg(S_{21}) \quad (\text{rad}). \quad (2.20)$$

2.1.3.2. Matriz de transmisión ABCD

Mientras que la matriz de Scattering permite describir el sistema en función de las relaciones entre sus puertos, la matriz de transmisión ABCD facilita la conexión en cascada de redes de dos puertos. Esto resulta altamente interesante a la hora de realizar un análisis de una red compuesta de varios componentes en cascada. La relación de la

matriz ABCD en una red de dos puertos es:

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix} \quad (2.21)$$

Ante una conexión en serie de dos o más redes de dos puertos Figura 2.4, es posible calcular la matriz ABCD equivalente como:

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & D_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_2 & B_2 \\ C_2 & D_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_N & B_N \\ C_N & D_N \end{bmatrix} \quad (2.22)$$

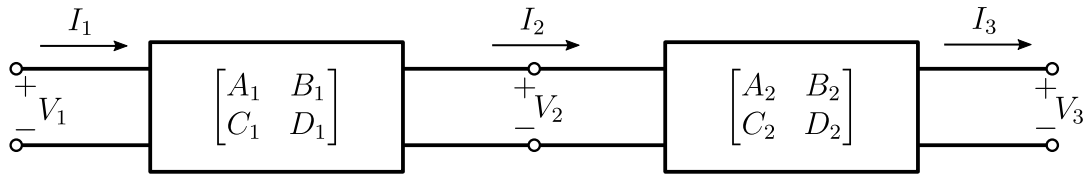


Figura 2.4: Representación general de una red de dos puertos

En la literatura podemos encontrar equivalentes de la matriz ABCD para circuitos de dos puertos comunes [45]. Sin embargo, ya que en este TFM la red de microondas bajo análisis está compuesta únicamente por resistencias y tramos de líneas de transmisión (como se verá más adelante en el Capítulo 3), en la Tabla 2.1 se expresan estos dos únicamente:

Circuito	Parámetros ABCD
	$A = 1 \quad B = Z$ $C = 0 \quad D = 1$
	$A = \cos(\beta\ell) \quad B = jZ_0 \sin(\beta\ell)$ $C = jY_0 \sin(\beta\ell) \quad D = \cos(\beta\ell)$

Tabla 2.1: Parámetros ABCD equivalentes

donde $\theta = \beta\ell$ (rad) es la longitud eléctrica.

Por otro lado, si la red bajo análisis se compone de dos ramas en paralelo, siguiendo la segunda regla de la descomposición de diagramas de flujo, el equivalente es la suma [45].

Siguiendo esta regla, para realizar el análisis de este TFM, obtendremos el equivalente de las ramas en paralelo mediante la matriz de admitancia:

$$\begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11_1} & Y_{12_1} \\ Y_{21_1} & Y_{22_1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Y_{11_2} & Y_{12_2} \\ Y_{21_2} & Y_{22_2} \end{bmatrix} \quad (2.23)$$

Ya solo resta definir cómo se relacionan entre sí los parámetros de todas las matrices repasadas en este capítulo. Para ello y a modo de resumen, se adjunta la Tabla A.1 [45] en el Anexo A.

3. Topología bajo estudio y objetivos

El objetivo de este TFM, como bien indica su título, es realizar un estudio de estructuras con retardo de grupo negativo en tecnología microstrip. La topología inicialmente propuesta se muestra en la Figura 3.1. A dicha topología nos referiremos como Modelo 1.

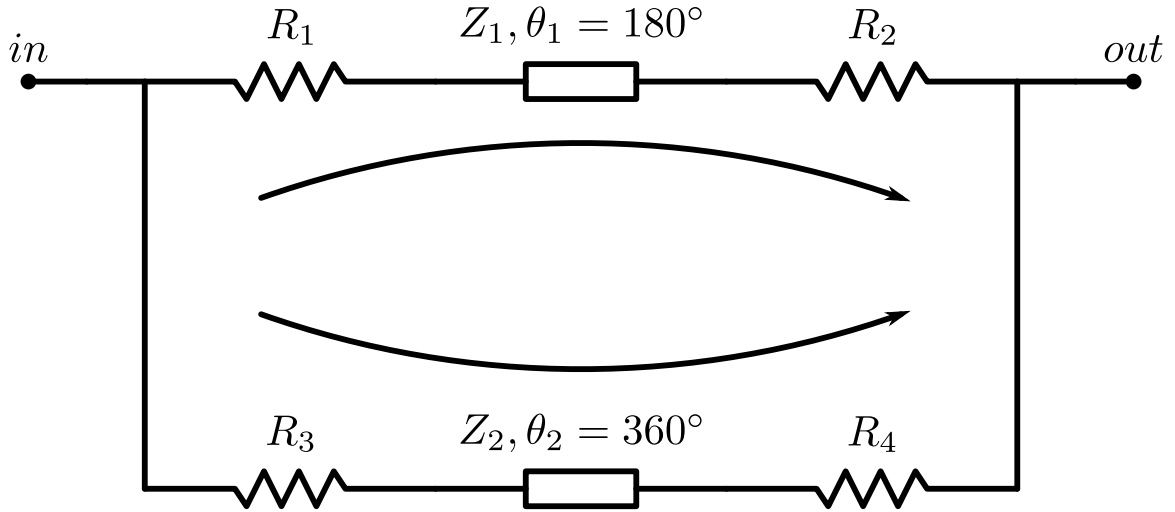


Figura 3.1: Topología propuesta: Modelo 1

En un principio, los resultados que se esperaban obtener eran similares o mejores a los expuestos en el artículo *Signal-Interference-Based Structure with Negative Group Delay Properties* (2018) [16]. La diferencia entre la topología de la Figura 3.1 y la publicada en dicho artículo reside en las longitudes eléctricas de los tramos de línea superior (TL_1) e inferior (TL_2). En ambos casos nos encontramos ante un dispositivo interferencial ya que la señal llega desfasada 180° , sin embargo las longitudes de la topología del artículo son $\theta_1 = 90^\circ$ y $\theta_2 = 270^\circ$. Esta diferencia supone que en la topología propuesta en este TFM existan tres ceros de transmisión. Por lo tanto, el objetivo pasaba por ajustar las pérdidas introducidas por las resistencias para así suavizar la respuesta y conseguir una banda con NGD muy ancha. Por desgracia, no es posible para valores de NGD interesantes y atenuaciones plausibles.

Sin embargo, el sistema tiene varios grados de libertad que merece la pena estudiar ya que para configuraciones concretas es posible obtener dispositivos con retardo de grupo negativo de una, dos o tres bandas.

El análisis de una topología pasiva como la del Modelo 1 es relativamente sencillo gracias a la teoría de análisis de redes de microondas vista en el Capítulo 2. Sin embargo, tal y como se expuso en la Ecuación 1.2, el retardo de grupo negativo se obtiene a partir de la derivada de la fase, y puesto que contamos con tres ceros de transmisión donde sólo el central se mantiene constante en frecuencia, es difícil simplificar la expresión resultante porque no se conoce a priori la frecuencia de las bandas ya que depende de los valores de impedancias y resistencias de la topología. Esta característica lleva a que obtener expresiones que caractericen completamente el dispositivo en cuanto a retardo de grupo negativo no sea factible analíticamente, haciendo muy difícil obtener ecuaciones o curvas de diseño cerradas.

Los métodos tradicionales para realizar estudios paramétricos se basan en fijar una de las variables y modificar el resto. Por desgracia, para esta topología este tipo de estudios deja muchísimas combinaciones potenciales fuera, por lo que si se pretende tener un control más exhaustivo de la topología es necesario llevar a cabo un análisis paramétrico por fuerza bruta. Gracias a la potencia computacional de las máquinas actuales es posible aplicar la teoría de circuitos y de análisis de redes de microondas para obtener, junto con un pequeño procesado de señal, datos que caractericen el sistema.

En los siguientes capítulos veremos más en detalle cómo se ha desarrollado este análisis y los resultados y conclusiones obtenidos.

4. Desarrollo

En este capítulo se presenta el desarrollo del estudio así como las herramientas utilizadas y algunas de sus diferencias más características.

4.1. Estudio Paramétrico

Tal y como ya se ha comentado anteriormente, el estudio paramétrico de la topología propuesta se ha realizado por fuerza bruta mediante herramientas de computación como Python y MATLAB® y otras más específicas del diseño de sistemas como ADS y Sonnet.

4.1.1. Cálculo de la respuesta de la topología

Para obtener la respuesta ideal del circuito podemos optar por herramientas específicas como ADS, que permiten generar el esquema eléctrico de la Figura 3.1 con los valores reales para cada parámetro. En la Figura 4.1 se muestra el circuito creado en ADS. En el Anexo B se detalla el uso de este software.

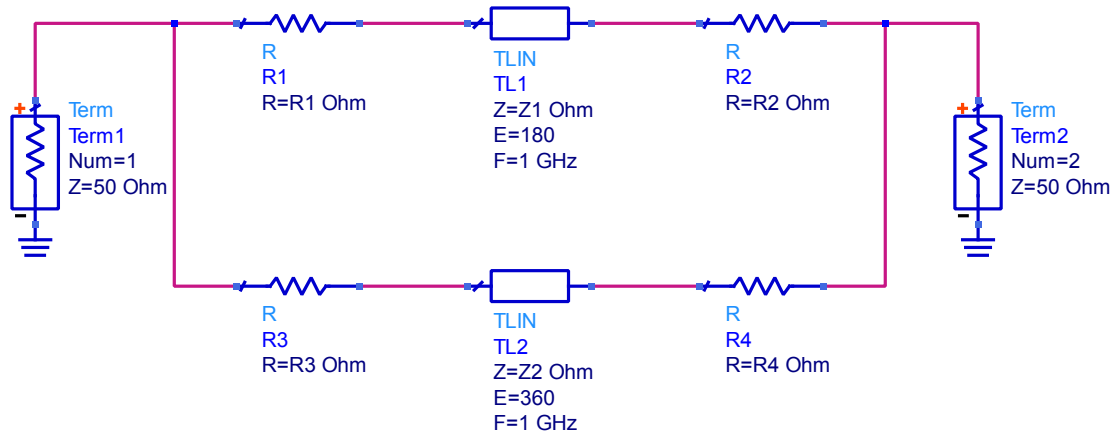


Figura 4.1: Circuito simulado en (ADS) (Modelo 1)

Como puede observarse, a la entrada y la salida del dispositivo se han conectado dos **Term** (Terminales) que simbolizan la impedancia de los puertos ($Z = 50 \Omega$ en todos los casos de este TFM).

Por otro lado, cabe destacar que el dispositivo bajo análisis tiene 6 grados de libertad, es decir tiene 6 variables: 4 resistencias y las 2 impedancias características de las líneas de transmisión. Dichos valores se referencian mediante el objeto **VAR** que permite, entre otras, su variación en tiempo real mediante la opción **Tunning**. Por ejemplo para los valores de Resistencias e Impedancias de la Tabla 4.1, se obtiene la respuesta de la Figura 4.2, donde se muestran el retardo de grupo (en segundos) y los parámetros $S_{2,1}$, $S_{1,1}$ y $S_{2,2}$ (en decibelios), junto con marcadores en las dos frecuencias de interés y la central a 1 GHz.

$R_1(\Omega)$	$Z_1(\Omega)$	$R_2(\Omega)$	$R_3(\Omega)$	$Z_2(\Omega)$	$R_4(\Omega)$
5	55	5	5	40	100

Tabla 4.1: Valores para el Modelo 1

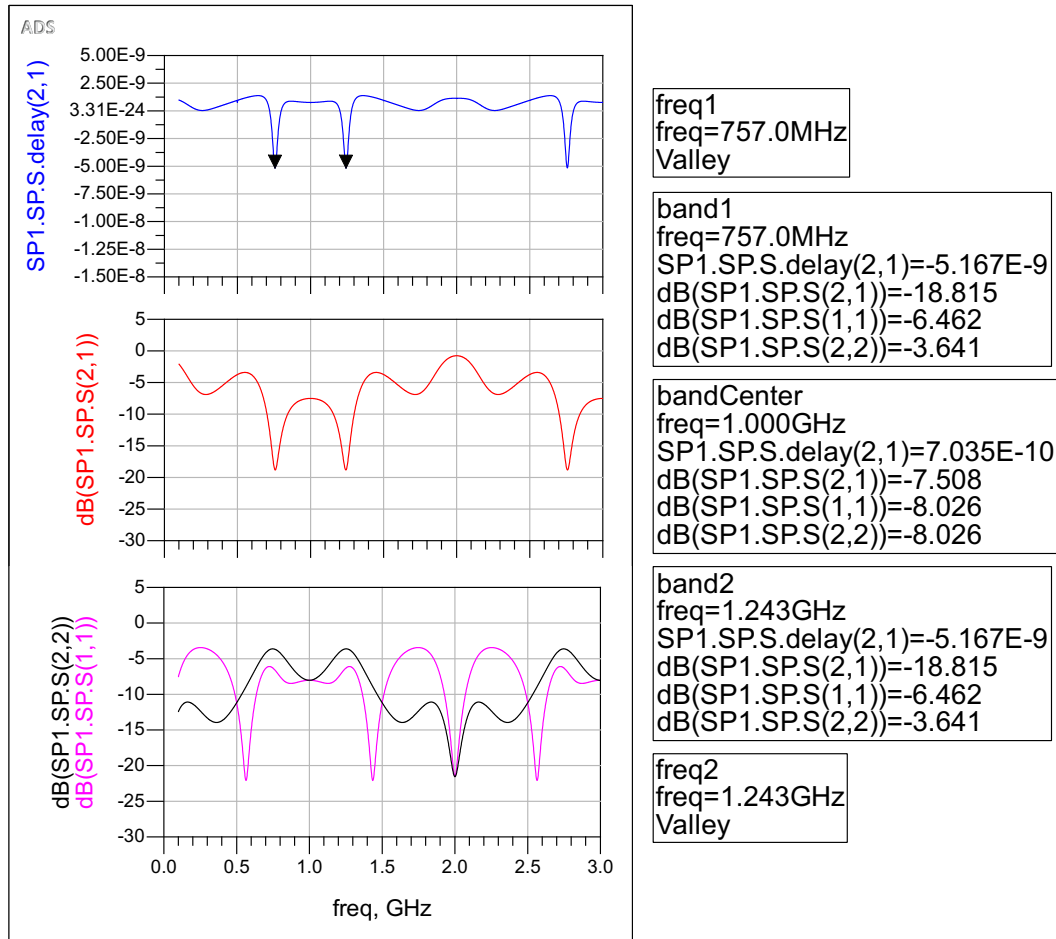
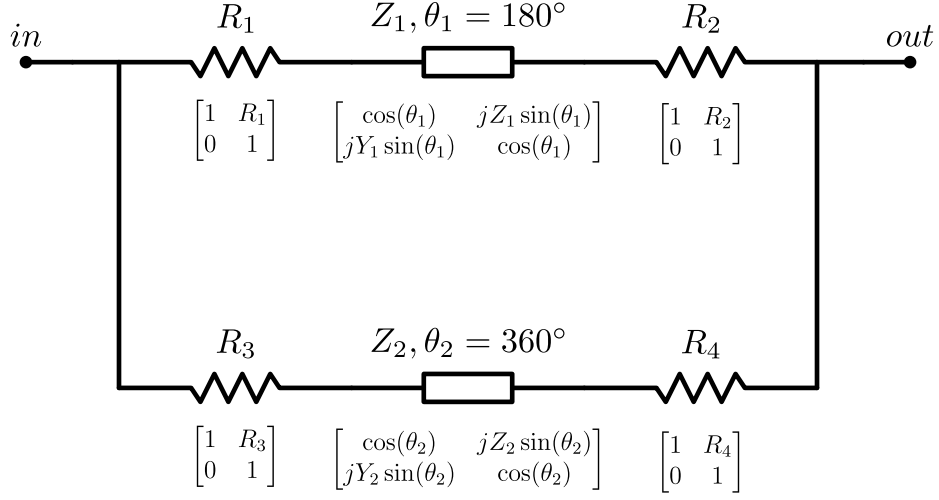
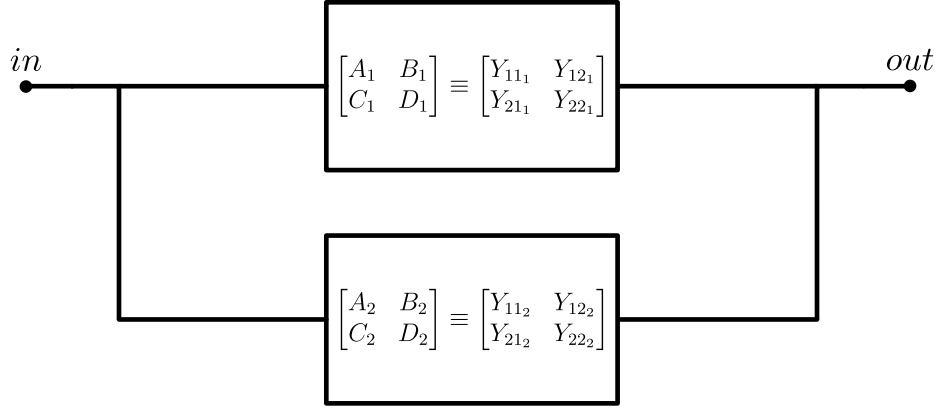


Figura 4.2: Respuesta del Modelo 1 con la configuración de la Tabla 4.1

(a) Modelo 1 en matrices $ABCD$ para cada componente

(b) Modelo 1 analizado como dos ramas en paralelo

Figura 4.3: Análisis de redes de microondas aplicado al Modelo 1

Otra opción para obtener la respuesta del circuito ideal es realizar el cómputo en MATLAB®. Para ello es necesario aplicar el análisis de redes de microondas del Capítulo 2. En la Figura 4.3a se muestra la matriz $ABCD$ para cada uno de los componentes del circuito, de dónde podemos obtener el equivalente para cada rama en serie:

$$\begin{bmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & D_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & R_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(\theta_1) & jZ_1 \sin(\theta_1) \\ jY_1 \sin(\theta_1) & \cos(\theta_1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & R_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.1a)$$

$$\begin{bmatrix} A_2 & B_2 \\ C_2 & D_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & R_3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(\theta_2) & jZ_2 \sin(\theta_2) \\ jY_2 \sin(\theta_2) & \cos(\theta_2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & R_4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.1b)$$

Obteniendo así una red que puede representarse mediante la Figura 4.3b y es posible convertir dichas matrices de transmisión a matrices de admitancias mediante la

Tabla A.1 del Anexo A. De esta forma, tal y como ya se ha comentado, podríamos obtener la matriz de admitancia equivalente mediante la suma de ambas matrices de admitancia de ambas ramas:

$$[Y] = [Y_1] + [Y_2] \quad (4.2)$$

Y, mediante la Tabla A.1 convertirla a la matriz de Scattering, obteniendo así la matriz de dispersión con la que representar la respuesta de la red.

Esta matriz de dispersión $[S]$ sería la respuesta del circuito para unos valores de resistencias e impedancias determinados y una frecuencia concreta. Sin embargo, es posible trabajar con un vector de frecuencias normalizado f_n y, posteriormente, desnormalizar para obtener los valores en función de la frecuencia real:

$$f = f_n f_0 \quad (4.3a)$$

$$\theta = \theta f_n \quad (4.3b)$$

Por lo tanto, todos los parámetros de dispersión obtenidos están en función de la frecuencia normalizada, por lo que para representarlos hemos de tenerlo en cuenta. Sólo restaría calcular el retardo de grupo, que como se expresó en la Ecuación 1.2 se calcula mediante la derivada de la fase del coeficiente de transmisión:

$$\tau_g(\omega) = -\frac{\partial \arg(S_{21}(\omega))}{\partial \omega}, \quad (4.4)$$

Al tratarse de una derivada, es importante *desenrollar* la fase del coeficiente de transmisión para evitar saltos en dos puntos consecutivos. Por lo que para programar dicha función en MATLAB® resultaría la siguiente línea de código:

```
group_delay = -(diff(unwrap(angle(s21),pi))./diff(f))/(2*pi);
```

En el Anexo D se incluyen las funciones pertinentes para realizar la simulación así como el script de prueba para computar casos concretos. El resultado del Modelo 1 con los parámetros de la Tabla 4.1 se muestra en la Figura 4.4.

4.1.2. Análisis de la respuesta de la topología

Aunque la simulación de la topología es útil para obtener su respuesta, los métodos mencionados en el apartado anterior son válidos para unos valores de resistencias e impedancias determinados. Sin embargo, de cara al diseño de dispositivos para sistemas de comunicación específicos, es necesario caracterizar la topología de modo que ante unos requerimientos de **atenuación**, **retardo de grupo negativo** o **ancho de banda**, sea posible elegir los valores adecuados para obtener dicha respuesta. Tal y como se comentó en el Capítulo 3, para la topología propuesta no es posible encontrar expresiones aproximadas a partir del análisis matemático del sistema y por ello se opta por un análisis paramétrico por fuerza bruta.

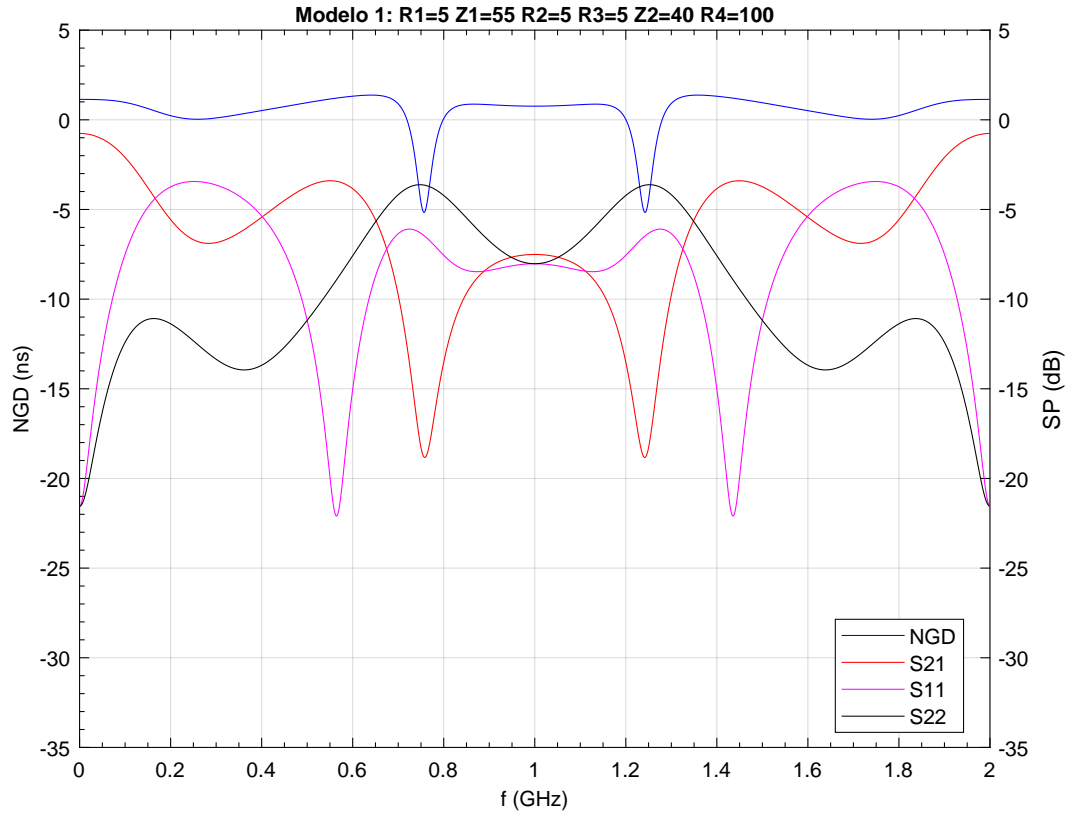


Figura 4.4: Respuesta del Modelo 1 con la configuración de la Tabla 4.1 simulada en MATLAB ®

Para llevar a cabo este análisis por fuerza bruta en un inicio se utilizó un componente de ADS llamado *Parameter Sweep*. Este componente nos permite configurar la simulación de modo que se repita para diversos valores de una misma variable. Por desgracia, aunque preciso y sencillo de utilizar, este método es lento ya que genera datos que no necesitamos y los almacena en memoria.

Siguiendo este mismo principio, se construye un sistema de simulación automática para diversos valores de las variables del circuito. Las resistencias pueden oscilar entre $0\ \Omega$ (circuito cerrado) y $100\ \Omega$, que son valores plausibles para su fabricación y que no supondrían un exceso de atenuación. Mientras que las impedancias varían entre 25 y $125\ \Omega$ para evitar efectos de radiación debidos a las dimensiones de la línea conductora (cota inferior) y no obtener anchuras demasiado estrechas que no sea posible fabricar (cota superior). En ambos casos el incremento es de $5\ \Omega$.

Por sencillez en el modo de programación y posibilidad de escalado, este sistema se implementa en Python. Al tratarse de un lenguaje de programación *open-source* es sencillo instalar el compilador en otras máquina sin depender de licencias. Esto ha

posibilitado que gran parte de los cálculos se realicen en diversas máquinas, no sólo físicas, sino también virtuales mediante entornos como Amazon Web Services o Google Cloud Platform. Estos servicios permiten crear instancias de máquinas virtuales con sistemas operativos Linux donde ejecutar remotamente la simulación y, posteriormente, descargar los datos generados.

La traducción de las funciones generadas en MATLAB® para la simulación de la topología a Python es relativamente sencilla, teniendo que adaptar algunas funciones y la sintaxis. La diferencia principal reside en el script de ejecución. Para realizar el análisis por fuerza bruta es necesario simular el modelo para cada caso, siendo un caso una combinación concreta de los valores de las variables (resistencias e impedancias). Teniendo en cuenta el número de variables y el rango de éstas, el número de casos a computar sería:

Variable	Rango	Incremento	N
Z_1 y Z_2	[25, 125]	5	21
R_1 , R_2 , R_3 y R_4	[0, 100]	5	21
f_n	[0, 2]	0.001	2001

Tabla 4.2: Variables y posibles valores

Para el Modelo 1 existen $21^6 = 85.766.121$ casos diferentes. No se tiene en cuenta el vector de frecuencias ya que el mayor o menor número de puntos en este aumenta o disminuye la precisión de los cálculos, pero no influye en el número de combinaciones posibles. Por supuesto que todos estos casos pueden simularse mediante bucles anidados, sin embargo, existen formas más eficientes.

Debido a las características de los cálculos a realizar, se opta por un procesamiento en paralelo gracias a los procesadores multinúcleo actuales. Sin adentrarnos en detalle en este tema, este tipo de ejecución nos permite simular tantos casos como núcleos lógicos tenga el procesador al mismo tiempo. Implementar esta característica es relativamente sencillo en Python gracias a la librería *multiprocessing*:

```

1 M = list(xRange) # variable 1
2 N = list(xRange) # variable 2
3 contador = list(it.product(M, N)) # combinación de ambas variables
4 # Creación del Pool de procesos a partir del número de núcleos de la cpu
5 p = multiprocessing.Pool(multiprocessing.cpu_count())
6 # Aplica la función calcular en paralelo para todos los valores de contador
7 p.map(calcular, contador)
8 # Cierra y termina el multiprocesado
9 p.close()
10 p.join()

```

Puesto que tras la simulación de cada caso es necesario almacenar en un archivo los resultados, tampoco es conveniente generar 21^6 archivos. El sistema de multiprocesado de Python permite almacenar el resultado en una variable cargada en memoria, sin embargo esta variable también sería demasiado pesada para casi cualquier máquina.

Por lo tanto, la solución más eficiente pasa por fraccionar la simulación y almacenar conjuntos de simulaciones. El sistema reparte a cada núcleo el valor de dos variables, las que se corresponderían con las capas más externas de los bucles anidados, y cada núcleo ejecuta, ahora sí, cuatro bucles anidados que producen una matriz de datos que se almacena en un archivo. En la Figura 4.5 se muestra este mismo concepto en forma de esquema visual.

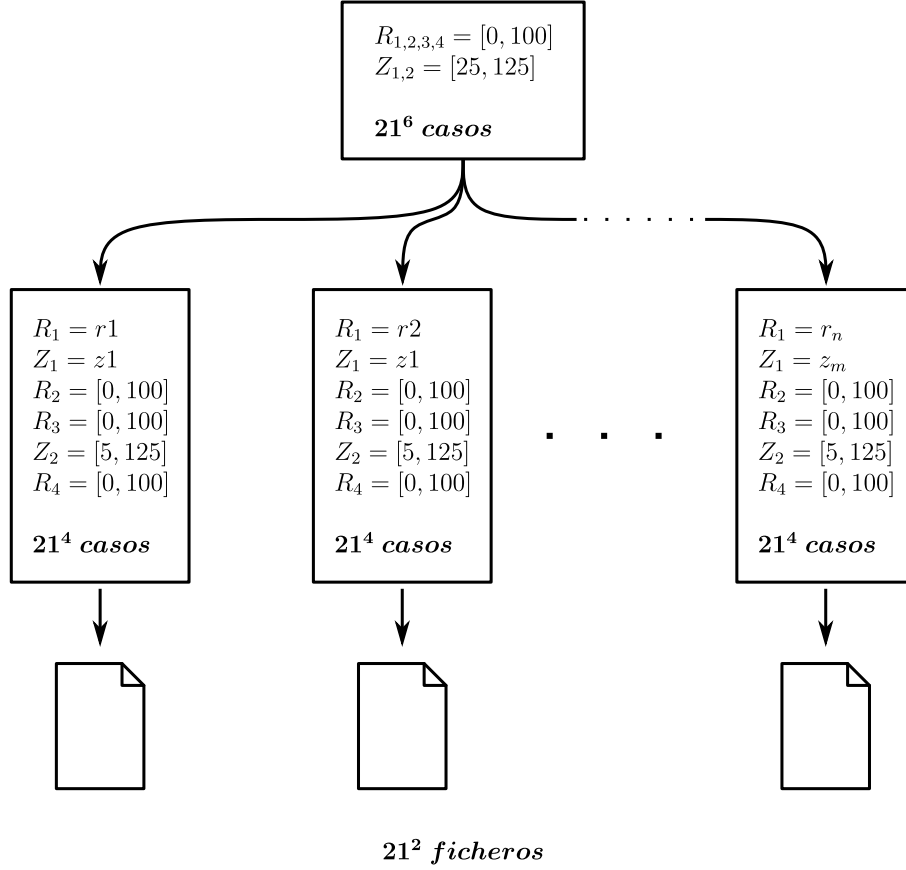


Figura 4.5: Esquema del multiprocesado por casos del Modelo 1

En el Anexo E se adjuntan todas las funciones y scripts necesarios para realizar la simulación.

La simulación de la respuesta de los casos es relativamente rápida gracias al cálculo matricial del análisis de la red, que evita que se tengan que utilizar bucles para evaluar el sistema con cada valor de frecuencia. Sin embargo, la respuesta para cada caso, en forma de vector en función de la frecuencia, no nos permite realizar un análisis paramétrico del sistema. Para ello es necesario introducir un pequeño procesamiento de señal para extraer los valores de interés. En este sentido, se consideran de interés los parámetros de la Tabla 4.3.

Para obtener estos datos es necesario encontrar los mínimos de la señal

Parámetro	Tipo	Descripción
NGD	3x1 (float)	Retardo de grupo negativo para cada banda, incluida la central, si lo hubiera.
$f(NGD)$	3x1 (int)	Índice del vector frecuencia donde se encuentran las bandas.
S_{21}	3x1 (float)	Coeficiente de transmisión para cada banda.
S_{11}	3x1 (float)	Coeficiente de reflexión de entrada para cada banda.
S_{22}	3x1 (float)	Coeficiente de reflexión de salida para cada banda.
$f(BW)$	3x2 (int)	Índice del vector frecuencia donde empieza y acaba el ancho de banda con ngd, medido éste como aquel ancho de banda donde el retardo de grupo es negativo.
$f(BW_{1dB})$	3x2 (int)	Índice del vector frecuencia donde empieza y acaba el ancho de banda con ngd, medido éste como aquel ancho de banda donde la diferencia del parámetro S_{21} es de 1 dB sobre su mínimo.
$f(BW_{3dB})$	3x2 (int)	Índice del vector frecuencia donde empieza y acaba el ancho de banda con ngd, medido éste como aquel ancho de banda donde la diferencia del parámetro S_{21} es de 3 dB sobre su mínimo.

Tabla 4.3: Parámetros de interés para la caracterización paramétrica

y discernir si son los adecuados ya que en el retardo de grupo puede haber diversos mínimos. Es posible acotar la posición de los mínimos, es decir de las bandas de interés. Mientras que la banda central se encuentra siempre para la frecuencia central (1 GHz en este caso); las bandas laterales son siempre simétricas para el Modelo 1 y no se corresponden exactamente con el cero de transmisión del parámetro S_{21} . Por ello matemáticamente no es posible calcular su frecuencia, sino que tenemos que recurrir a la búsqueda de dicho mínimo. Para optimizar la búsqueda se aplican las siguientes condiciones:

- La banda de frecuencia inferior (Banda 1) se encontrará entre 0 y 999 MHz
- El retardo de grupo debe ser negativo
- El ancho de dicho pico mínimo debe ser superior o igual a 2

De estas condiciones, merece la pena destacar el motivo de la última: las singularidades matemáticas. Al tratarse de un cálculo numérico con divisiones, derivadas y números complejos del que finalmente se obtiene un valor real, existen puntos inconsistentes que arrojan valores infinitos que se traducen en picos mínimos o máximos

de retardo de grupo entre dos muestras consecutivas. Al someter a todos los mínimos locales encontrados a dicha condición, descartamos aquellos que se deban a singularidades matemáticas. En la Figura 4.6 se muestran los dos mínimos encontrados con su correspondiente ancho (línea roja horizontal) y la altura de dicho mínimo (línea negra vertical). Cabe destacar que el ancho del mínimo encontrado no se corresponde con el ancho de banda que se menciona en la Tabla 4.3, sino que es el ancho matemático de dicho mínimo local.

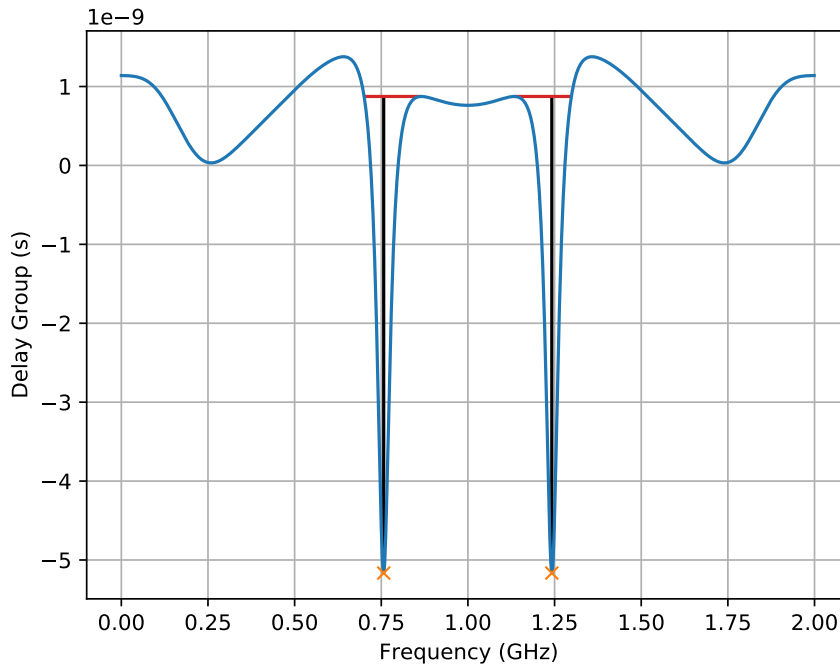


Figura 4.6: Búsqueda de mínimos de interés

Los datos generados se almacenan en un archivo de extensión *.mat* en forma de matriz donde constan los valores de cada variable (resistencias e impedancias) y de los parámetros de interés de la Tabla 4.3. Cabe resaltar que puesto que las bandas laterales son simétricas sólo se procesa y almacena la información relativa a la inferior.

El tiempo de cómputo para un equipo con un procesador Intel Core i7-10710U con 6 núcleos físicos a 1,10 GHz, 16 GB de memoria RAM y la versión 3.8.1 de Python es de 10,5 horas al 100% de su capacidad de cómputo.

Posteriormente se realiza un pre-procesado en MATLAB® donde se cargan los datos y se convierten a un formato propio denominado DataStore que permite cargarlos fraccionadamente en memoria. Además se convierte la matriz en una tabla, lo que facilita el acceso a los datos mediante el identificador de cada columna (D.4).

Llegados a este punto, la tabla de datos generados tiene unas dimensiones de 85.776.121

filas y 28 columnas (variables y parámetros de interés). Sin embargo, no todos los casos dan respuestas de interés: algunas combinaciones generan circuitos con retardos de grupo positivos, con atenuaciones muy altas o con NGD cercanos a cero. Por lo tanto, se analizan los datos para obtener tres DataStore más concretos (Código D.5):

- Doble Banda: Únicamente las bandas laterales tienen NGD, inferior a -1 ns y con atenuación inferior a 20 dB.
- Banda Central: Únicamente la banda central cumple dichas condiciones.
- Triple Banda: Las tres bandas cumplen dichas condiciones.

El análisis paramétrico se realiza a partir de dichos DataStore.

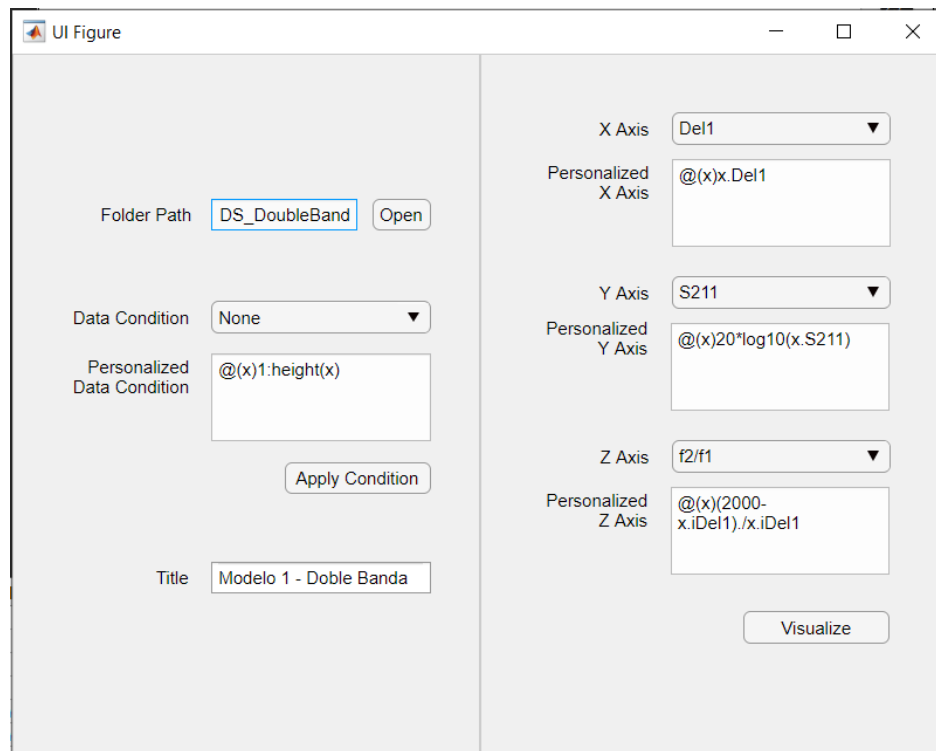
4.1.3. Análisis paramétrico

El análisis de datos con dependencia de múltiples variables puede ser complejo e incluso inabordable ante la cantidad de datos del modelo bajo estudio. Para arrojar algo de luz sobre las variables de interés y el comportamiento de la red, se ha implementado una interfaz gráfica en MATLAB® (Figura 4.7a) que carga los DataStore y permite seleccionar qué variables o parámetros queremos representar unos frente a otros como una nube de puntos.

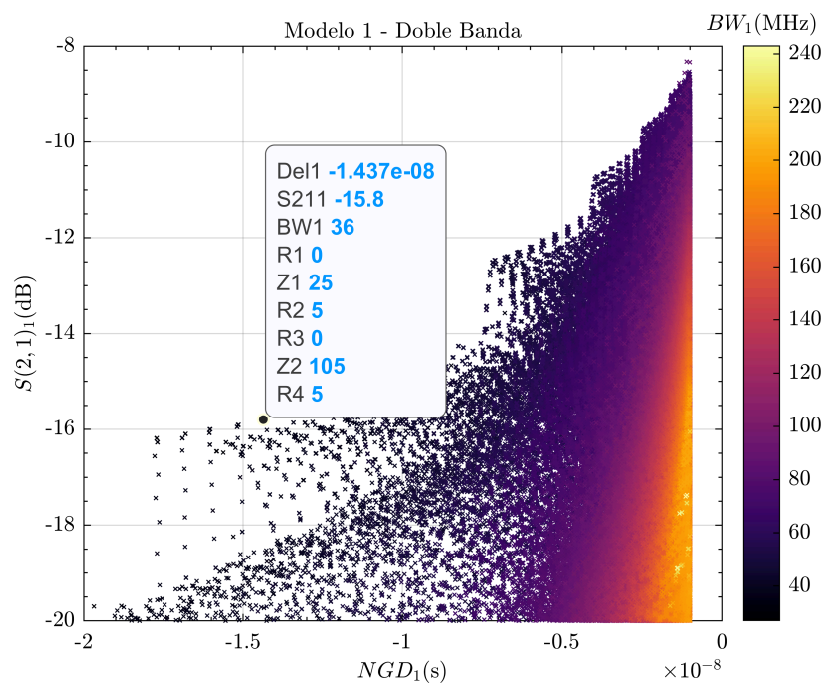
Es posible aplicar condiciones personalizadas a los datos o representar en función de la relación entre varias variables gracias a la flexibilidad que otorga trabajar con datos estructurados en tablas en MATLAB®. También es posible representar en 2 o 3 dimensiones, aunque la tercera dimensión es más interesante en modo gradiente de color. Por otro lado, se ha implementado una funcionalidad que añade a cada *Data Point* (desplegable de MATLAB® que da información sobre un punto de la gráfica) los valores de las resistencias e impedancias, haciendo esta forma muy sencillo localizar a qué caso corresponde la respuesta de interés (Figura 4.7b).

La aplicación se diseña y programa en AppDesigner (MATLAB®) y el código completo se encuentra en el Apartado D.6 del Anexo D.

En ocasiones también puede resultar interesante analizar la distribución de los valores que toman las variables con mayor o menor frecuencia para condiciones determinadas. En este sentido se han implementado una función para calcular el histograma (en paralelo) y representarlo (Figura 4.8). El código de la función y el script se adjunta en los Apartados D.7 y D.8.



(a) Entorno gráfico de la aplicación



(b) Ejemplo de representación de análisis del Modelo 1

Figura 4.7: Aplicación desarrollada para analizar paramétricamente el sistema

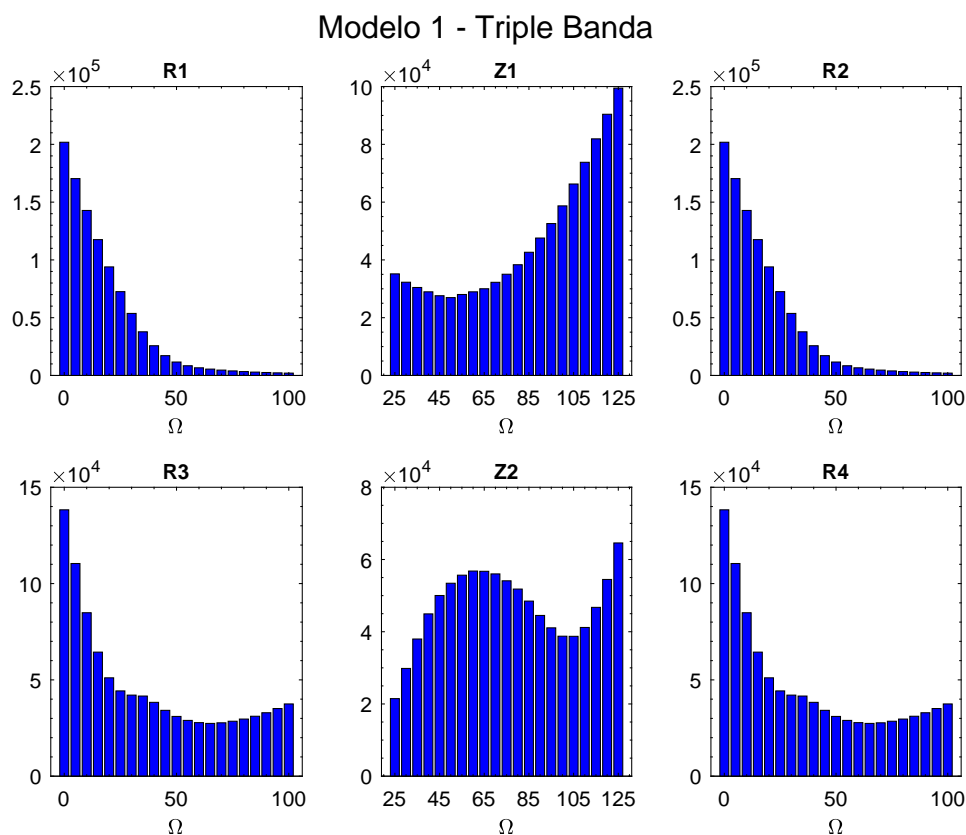


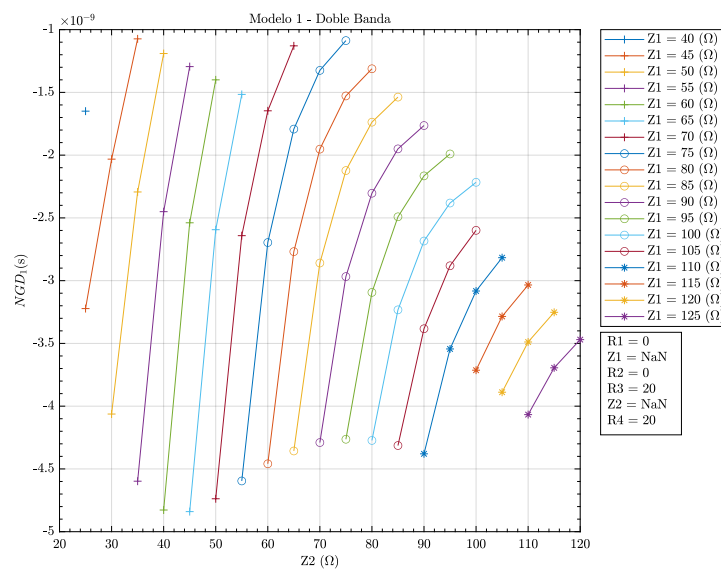
Figura 4.8: Histogramas de las variables para el Modelo 1 - Doble Banda

4.1.4. Curvas de diseño

El objetivo final del análisis paramétrico es la obtención de curvas de diseño que nos permitan, en base a unas especificaciones concretas, conocer con rapidez el valor que debemos utilizar para cada variable. En este sentido se ha implementado un entorno gráfico que permite generar gráficas de un parámetro frente a dos variables, una de ellas a modo de leyenda.

La interfaz es relativamente similar a la anterior y se puede ver, junto con un ejemplo de curva de diseño, en la Figura 4.9. El código completo se incluye en el Apartado D.9 del Anexo D.

(a) Entorno gráfico de la aplicación



(b) Ejemplo de una curva de diseño del Modelo 1

Figura 4.9: Aplicación desarrollada para generar curvas de diseño

4.2. Diseño de Prototipos

En apartado Líneas Microstrip del capítulo 2 se ha ilustrado la relación entre los parámetros eléctricos y físicos de una línea microstrip. En este sentido, es posible realizar un análisis, para calcular los parámetros eléctricos de unas dimensiones conocidas, o sintetizar dichas dimensiones a partir de los parámetros eléctricos deseados. En este apartado se expone cómo se ha llevado a cabo dicha síntesis, los cálculos adicionales para adecuar las dimensiones al circuito y la posterior simulación tanto en ADS como en un simulador de onda completa como es Sonnet.

4.2.1. Síntesis de los parámetros eléctricos

A partir de las ecuaciones 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10 es posible analizar o sintetizar el dispositivo. Por suerte, multitud de software e incluso páginas web permiten realizar estos cálculos de forma automática. En este TFM se ha utilizado la herramienta adicional de ADS LineCalc. En la Figura 4.10 se muestra la interfaz de esta aplicación.

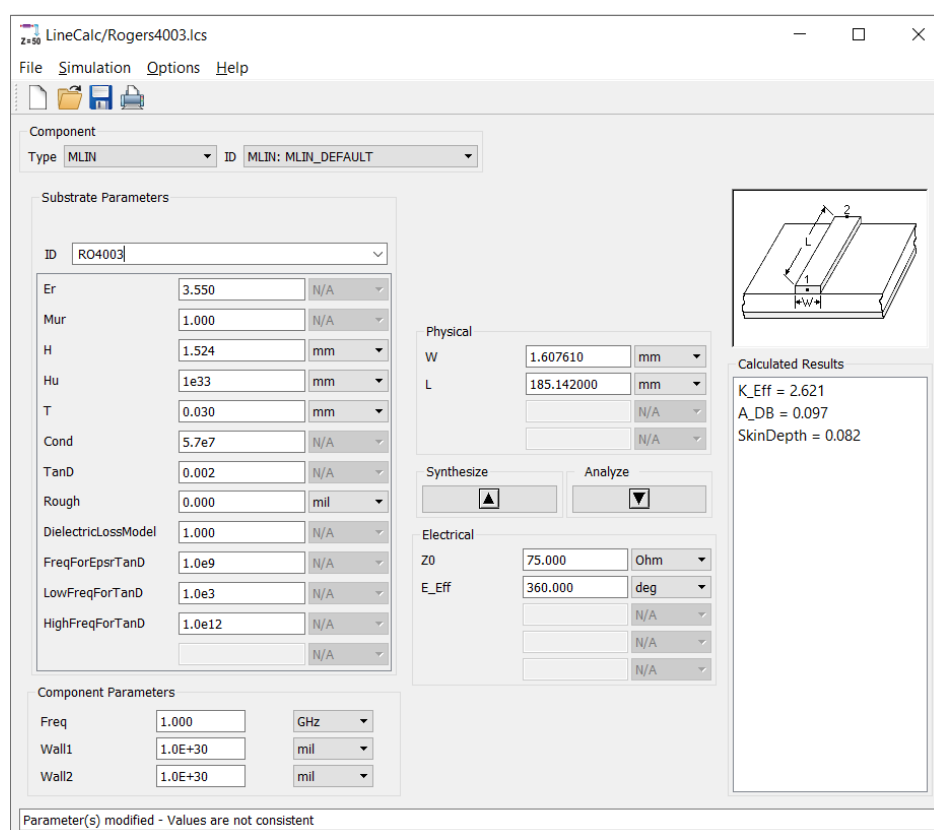


Figura 4.10: Herramienta LineCalc de ADS

En la Tabla 4.4 se describen los parámetros de relevancia y se especifican para dos substratos comerciales: Rogers 4003 y TLX-8.

ID	Unidad	Ro4003	TLX-8	Descripción
Er	Adim.	3,550	2,550	Permitividad efectiva relativa ($\epsilon_{r,eff}$) del dieléctrico.
H	mm	1,524	0,790	Espesor del substrato.
Hu	mm	1e33		Posición de la tapa. Si no la hay se configura con un valor muy grande.
T	mm	0,030		Espesor del conductor (cobre).
Cond	Adim.	5,7e7		Conductividad del conductor (cobre).
TanD	Adim.	0,0027	0,0017	Tangente de pérdidas.

Tabla 4.4: Parámetros de configuración de LineCalc

Por otro lado, el diseño físico del Modelo 1 precisa de curvar o doblar alguna de las líneas de transmisión para poder unirlos en el mismo nodo. Concretamente, ya que la línea de transmisión inferior tiene una longitud eléctrica de 360° frente a los 180° de la superior, será la de mayor longitud. Esto se traduce en un diseño con las características del esquema de la Figura 4.11.

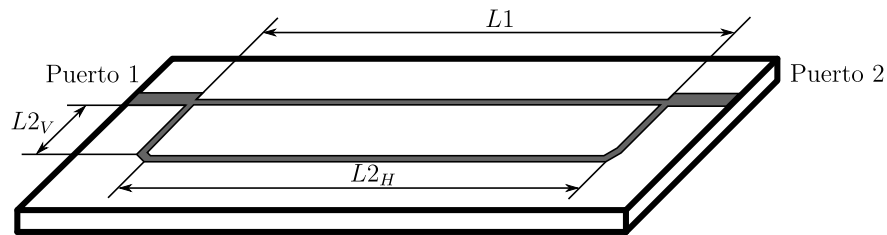


Figura 4.11: Esquema genérico de implementación del Modelo 1

Por lo que habrá que dividir la línea de transmisión inferior en tres secciones unidas mediante un ángulo. Para calcular estos tramos hay que tener en cuenta el espacio que ocupan las resistencias superiores, si las hubiera. Las resistencias comerciales son del tipo SMD 0603, por lo que precisan de 0,5 mm entre líneas, por lo que, como se muestra en el código 4.1, es necesario indicar también el número de las mismas.

Código 4.1: Script para el cálculo de los tramos de la línea inferior

```

1 % Width and Length for TL1 and TL2
2 W1 = 0.5;
3 L1 = 95.4;
4 W2 = 1.6;
5 L2 = 185.2;
6 % Number of resistences
7 num_r = 2;

```

```

8 % Calc.
9 r_space = 0.5;
10 L2_h = L1 + num_r*r_space;
11 L2_v = (L2 - L2_h - 2*W2)/2;

```

4.2.2. Simulación Microstrip (ADS)

Al igual que en el apartado 4.1.1 Cálculo de la respuesta de la topología, es posible simular la respuesta del dispositivo mediante su equivalente con líneas de transmisión microstrip en ADS. En la Figura 4.12 se muestra dicho circuito, el cual es muy parecido a su equivalente ideal, pero con la diferencia de que es necesario añadir las conexiones en 'T' que supone conectar dos líneas de transmisión con el puerto de entrada o salida en un mismo nodo. Puesto que estos puntos son críticos en cuanto a efectos parásitos y comportamientos indeseados, es importante tenerlos en cuenta a la hora de simular.

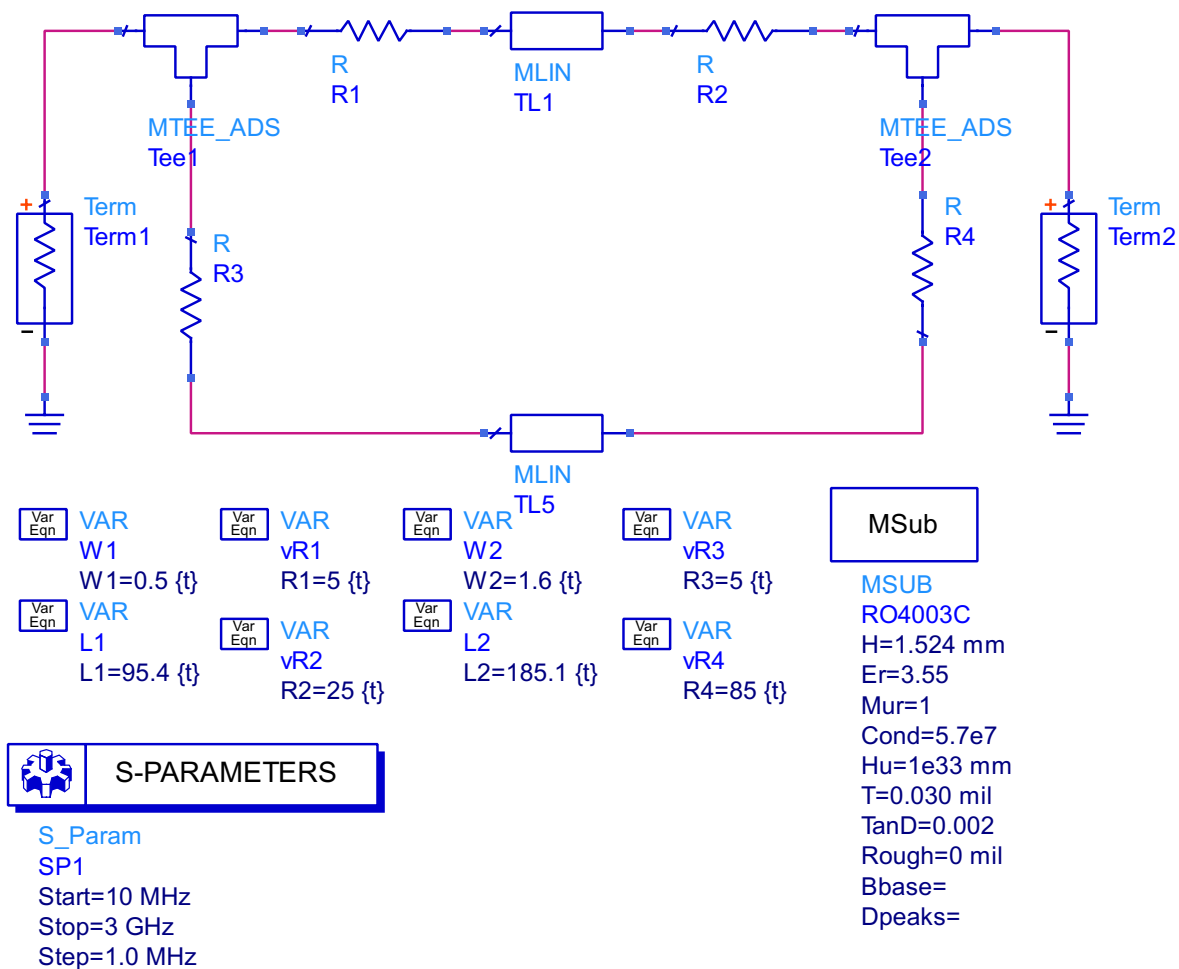


Figura 4.12: Circuito simulado en ADS con líneas microstrip (Modelo 1)

Para hacer mostrar el resultado de la simulación, se sintetizan los valores de la Tabla 4.1, obteniéndose las medidas de longitud y ancho para cada línea de la Tabla 4.5.

Línea de Transmisión	$Z_0(\Omega)$	$\theta_0(\Omega)$	$W(\text{mm})$	$L(\text{mm})$
Superior (TL1)	55	180°	2,87	90,53
Inferior (TL2)	40	360°	4,75	177,17

Tabla 4.5: Dimensiones físicas para las líneas de transmisión del Modelo 1

Tal y como se ha comentado, las conexiones en 'T' son un punto crítico y un mal diseño puede ocasionar grandes variaciones en la respuesta del circuito. En este sentido, la documentación de ADS indica cómo se configuran los puertos de la 'T' en función de su anchura. En la Figura 4.13 se muestra la nomenclatura para cada puerto y su relación con las anchuras del resto de puertos.

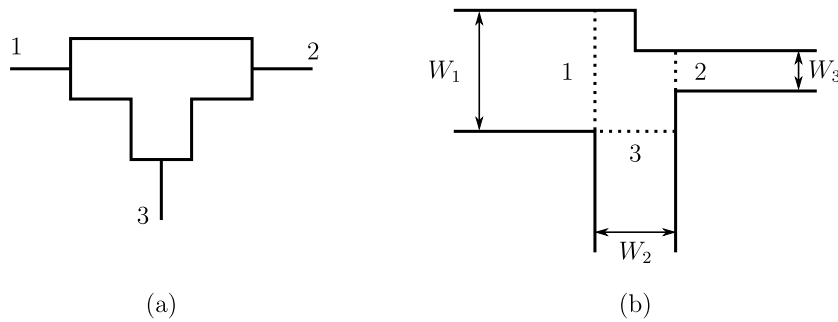


Figura 4.13: Diagrama de la relación entre los anchos del conector en 'T' y sus puertos. (a) Símbolo en ADS. (b) Esquema físico

Para ilustrar la importancia del diseño del conector en 'T' se ha simulado el mismo circuito sin tener en cuenta la relación $W_1 > W_3 > W_2$ en la Figura 4.14 y teniéndolo en cuenta en la Figura 4.15. Como puede apreciarse, para aquella simulación donde sí que se ha tenido en cuenta la relación que establece ADS, la diferencia entre las bandas es menor.

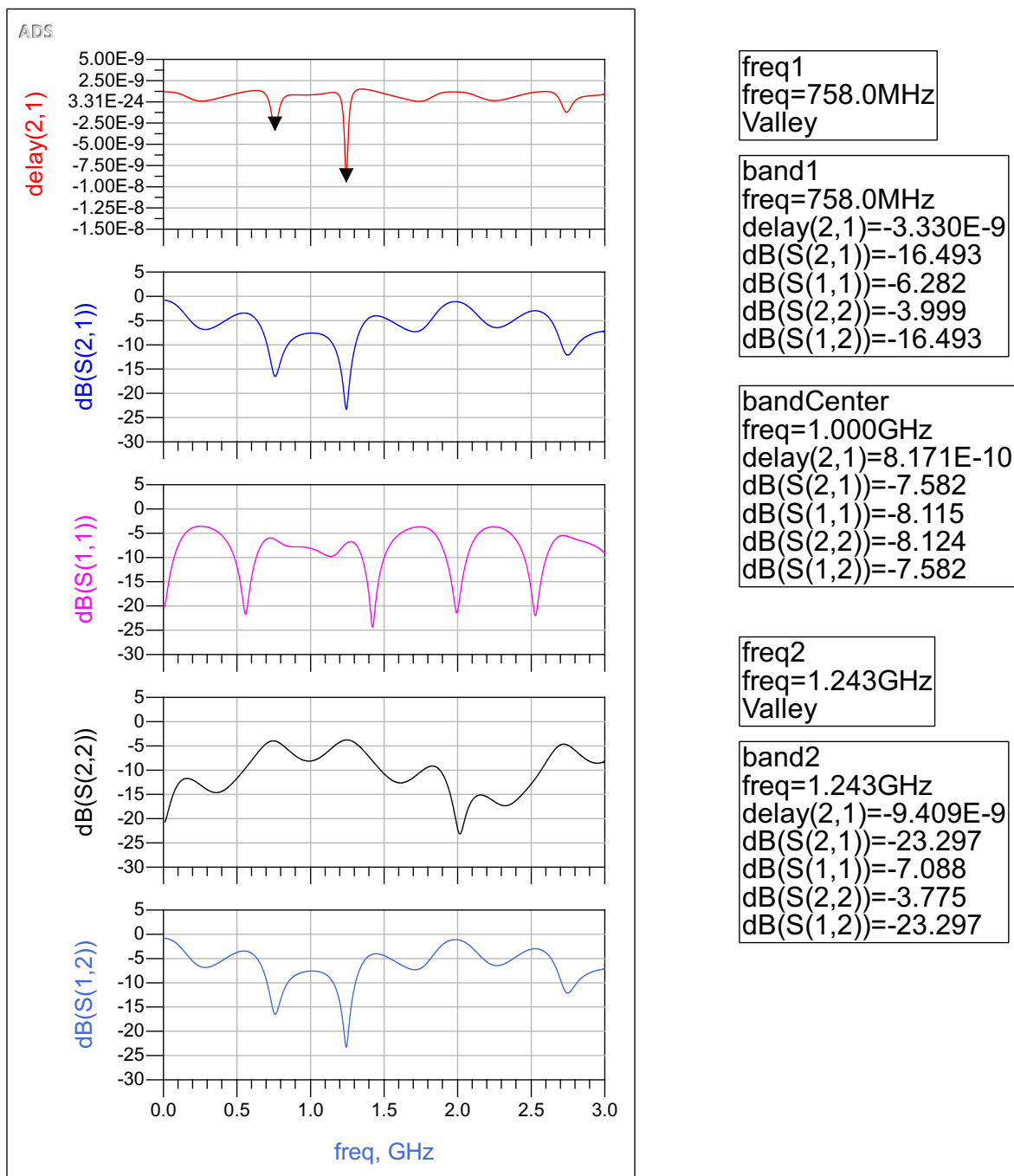


Figura 4.14: Respuesta con el conector 'T' mal configurado (Modelo 1)

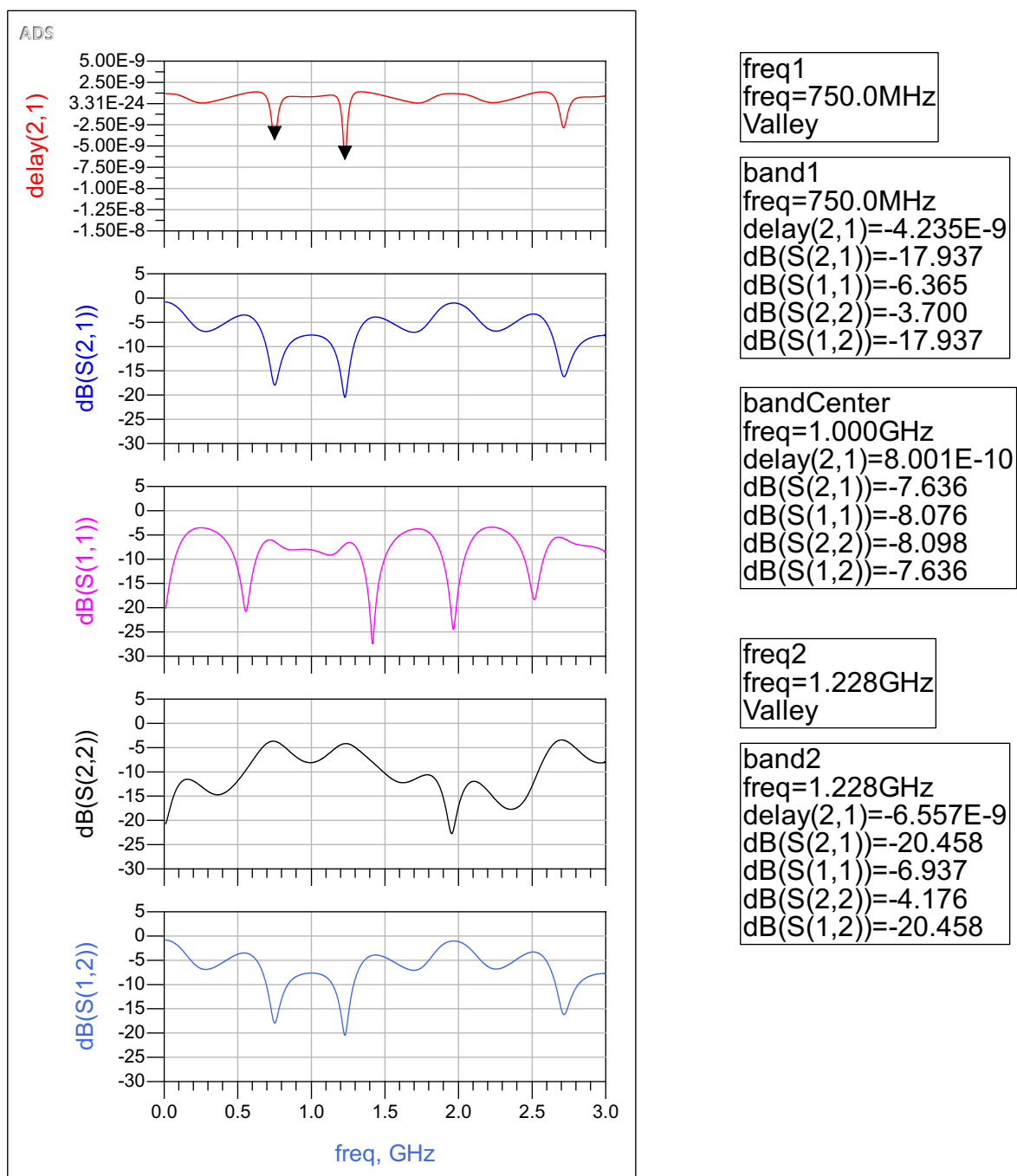


Figura 4.15: Respuesta con el conector 'T' correctamente configurado (Modelo 1)

4.2.3. Simulación de onda completa (Sonnet)

La simulación más exacta es aquella que se hace calculando los campos electromagnéticos en cada punto del circuito y, a su vez, es la más costosa computacionalmente. Sin embargo, llegados al punto previo a la fabricación, es aconsejable realizar este tipo de simulación para conocer con más fiabilidad la respuesta que tendrá el circuito en la vida real.

Este tipo de simulaciones se les conoce con el nombre de onda completa y para llevarlas a cabo en este TFM se utilizará el software Sonnet.

En el Anexo C: Tutorial Sonnet, se explica de forma detallada cómo configurar y crear tiras (*strip*) con este software. Para realizar el estudio de una topología que puede variar las dimensiones físicas de sus líneas también es interesante parametrizar el circuito (Apartado C.2.2.2). Mediante esta técnica es posible variar las propiedades de las líneas de forma rápida y agilizar la simulación de prototipos así como un ajuste fino de los mismos. En este sentido, siguiendo las dimensiones de la tabla 4.5, el prototipo quedaría tal y como se muestra en la Figura 4.16

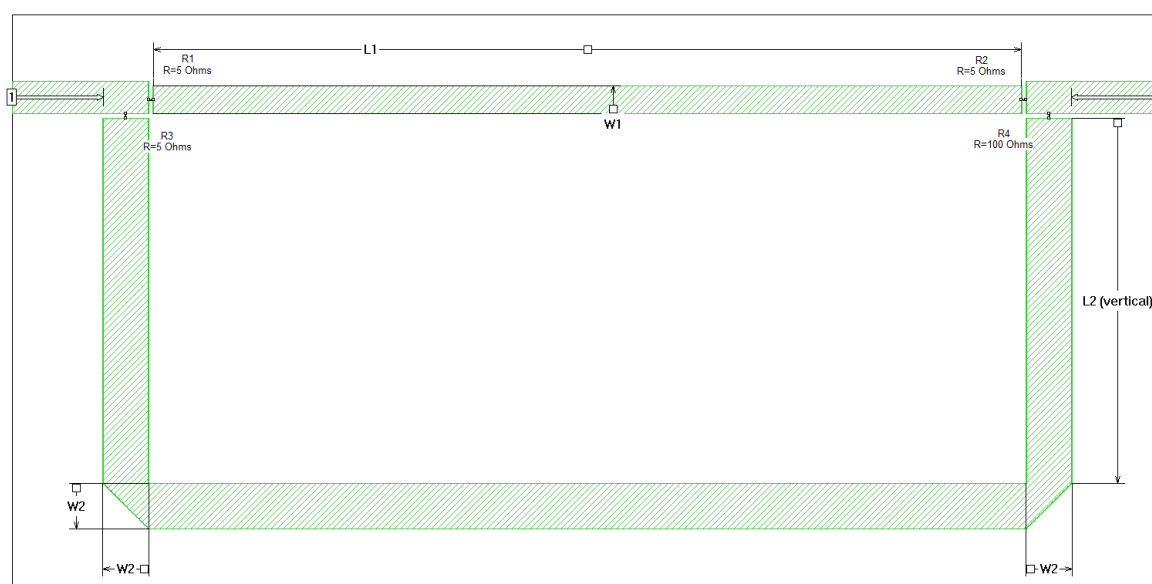
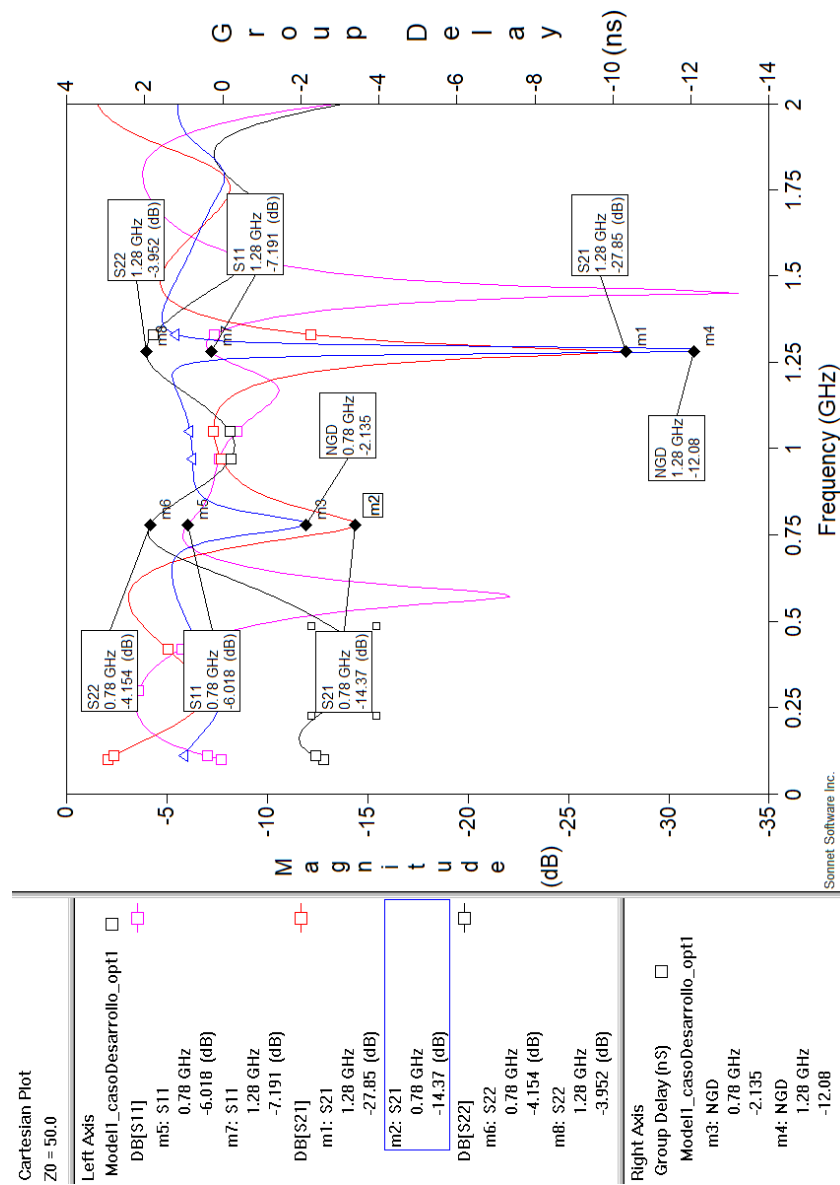


Figura 4.16: Prototipo en Sonnet (Modelo 1)

Tras la correspondiente simulación y configuración de la vista de representación con los parámetros S deseados y el retardo de grupo, se obtiene la respuesta de la topología propuesta en la Figura 4.17.



5. Resultados

En este capítulo se exponen los resultados del estudio de la topología propuesta. En primer lugar se mostrará el análisis paramétrico por fuerza bruta con curvas de diseño de interés. Posteriormente se presentan los resultados principales de los casos escogidos mediante las simulaciones circuitales y de onda completa.

5.1. Análisis paramétrico

Tal y como se ha explicado en el Capítulo 4, la imposibilidad de obtener expresiones analíticamente de la respuesta del circuito nos ha llevado a realizar un análisis paramétrico por fuerza bruta. La computación de los 85.766.121 casos, muy diferentes entre sí, hace que sea complicado encontrar relaciones entre todos ellos.

Teniendo en cuenta que se trata de una topología que ofrece respuestas de una (central), dos (laterales) y tres bandas, se filtran los resultados para evaluar el circuito bajo esas tres condiciones. Además, para que una respuesta se considere apta, la banda o bandas deben tener un $ngd \leq -1 \cdot 10^{-9}$ (s) y una atenuación $S_{2,1} \geq -20$ (dB).

5.1.1. Modelo 1 - Doble Banda

Las condiciones para que sea de Doble Banda se establecen en base a las ya mencionadas, teniendo en cuenta que además para este caso el retardo de grupo de la banda central debe ser positivo o no localizarse un mínimo en dicho punto.

Para analizar este caso, se presenta la Tabla 5.1 con los valores mínimos y máximos para todos los parámetros en relación a las bandas laterales; por otro lado en la Figura 5.1 y 5.2 se representan las distribuciones más interesantes en forma de gráfica; y por último los histogramas de las variables (Figura 5.3).

A partir de este análisis es posible localizar combinaciones para las cuales obtengamos resultados interesantes en función del objetivo. Por ejemplo, se detectaron casos interesantes con $Z_1 = 25$ (Ω) y $Z_1 = 35$ (Ω), por lo que se generaron las siguientes curvas de diseño para el modelo 1 con dichos valores de impedancias y $R_1 = R_3 = 0$ (Ω). En las Figuras 5.19-5.9 se exponen dichas curvas de diseño en función de distintos parámetros.

Ante estas curvas de diseño, podemos seleccionar una combinación concreta y simular rápidamente su respuesta ideal en MATLAB® mediante el Código D.1, obteniendo la respuesta de la Figura 5.10. Los valores seleccionados para las variables se muestran en la Tabla 5.2.

Parámetro	Mínimo	Máximo
NGD	-19,681 ns	-1 ns
f_2/f_1	1,4969	5,0423
S_{21}	-20 dB	-8,3247 dB
S_{11}	-21,8196 dB	-0,0505 dB
S_{22}	-21,8196 dB	-0,0505 dB
BW	27 MHz	243 MHz
BW_{1dB}	8 MHz	233 MHz
BW_{3dB}	14 MHz	417 MHz

Tabla 5.1: Análisis numérico del Modelo 1 - Doble Banda

$R_1(\Omega)$	$Z_1(\Omega)$	$R_2(\Omega)$	$R_3(\Omega)$	$Z_2(\Omega)$	$R_4(\Omega)$
0	25	10	0	35	80

Tabla 5.2: Valores seleccionados para las pruebas del Modelo 1 - Doble Banda

Por lo que obtenemos una configuración con las características de la Tabla 5.3.

Parámetro	Valor
NGD	-2,5056 ns
f_2/f_1	1,6178
S_{21}	-14,276 dB
S_{11}	-4,0813 dB
S_{22}	-3,6170 dB
BW	103 MHz
BW_{1dB}	55 MHz
BW_{3dB}	112 MHz

Tabla 5.3: Valor de los parámetros para el caso elegido del Modelo 1 - Doble Banda

Para poder simular en onda completa esta configuración es necesario calcular las dimensiones físicas de las líneas de transmisión para los substratos Rogers 4003 y TLX-8, las cuales se muestran en la Tabla 5.4.

	Eléctricos		Rogers 4003		TLX-8	
Línea de Transmisión	$Z_0(\Omega)$	$\theta_0(\Omega)$	$W(\text{mm})$	$L(\text{mm})$	$W(\text{mm})$	$L(\text{mm})$
Superior (TL1)	25	180°	9,03	86,09	5,65	99,74
Inferior (TL2)	35	360°	5,75	175,66	3,64	202,61
Puertos	50		3,36		2,17	

Tabla 5.4: Dimensiones físicas para el caso bajo estudio del Modelo 1 - Doble Banda

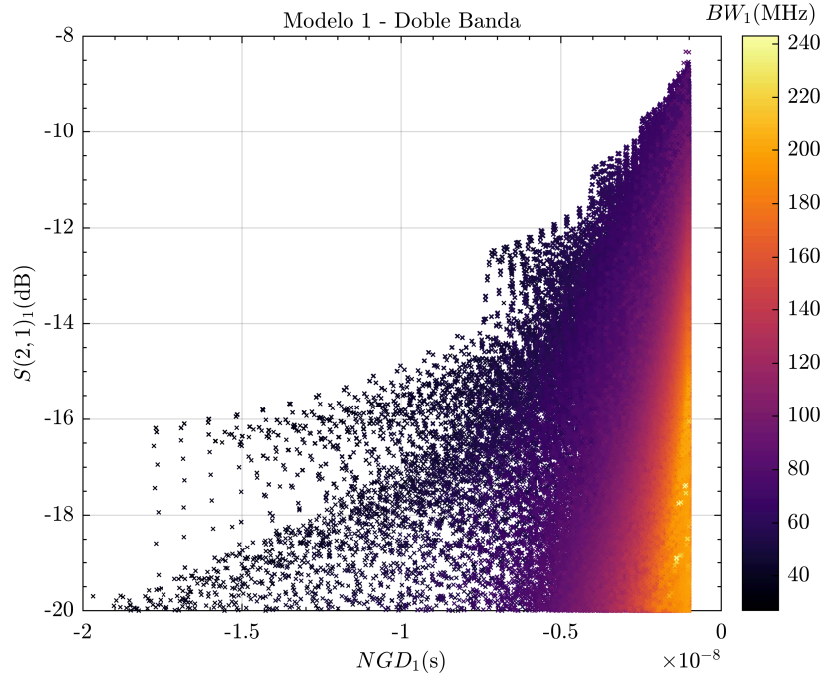


Figura 5.1: NGD frente a atenuación y ancho de banda (Análisis Modelo 1 - Doble Banda)

Por lo tanto, el diseño implementado en Sonnet sólo tiene dos resistencias (junto al puerto de salida) y es necesario ajustar la conexión en 'T' del puerto de entrada para conseguir unos resultados óptimos. En la Figura 5.11 se muestra un posible diseño de la conexión en 'T' para el sustrato Rogers 4003. También se han evaluado otros, centrando el puerto 1 frente a la línea de transmisión 1, pero con peores resultados. Esto se debe a los efectos parásitos que suponen este tipo de uniones. La respuesta de este prototipo se muestra en la Figura 5.12. En las Figuras 5.13 y 5.14 se muestra el mismo prototipo para el sustrato TLX-8.

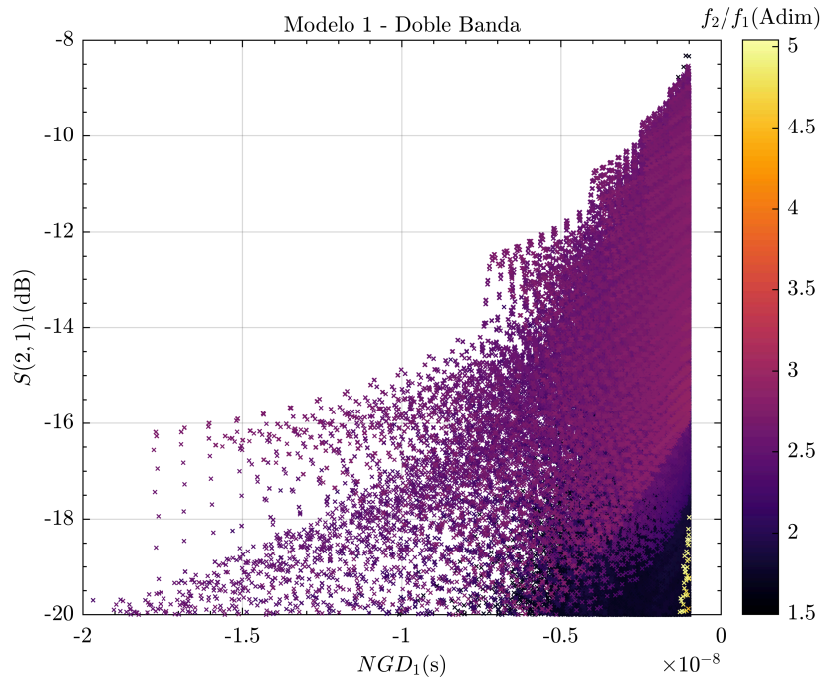


Figura 5.2: NGD frente a atenuación y relación entre bandas (Análisis Modelo 1 - Doble Banda)

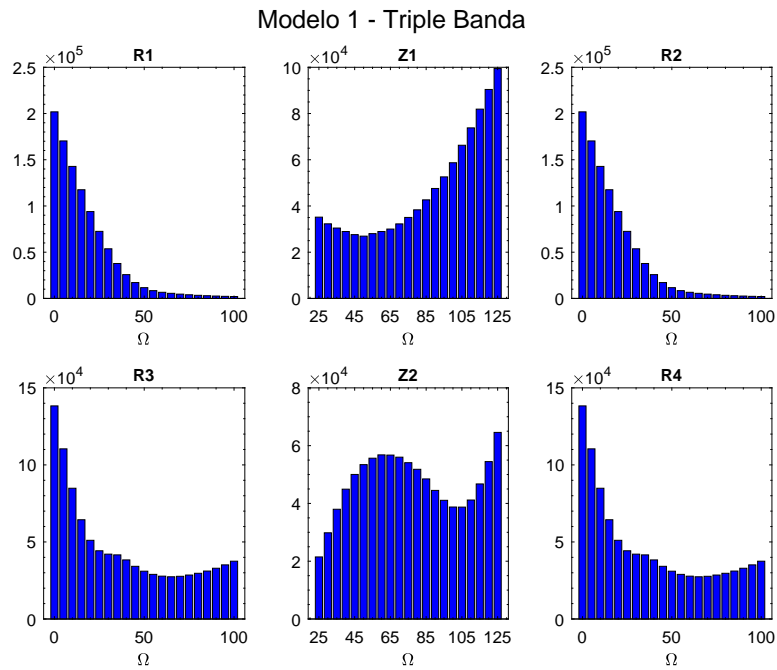


Figura 5.3: Histogramas de las variables para el Modelo 1 - Doble Banda

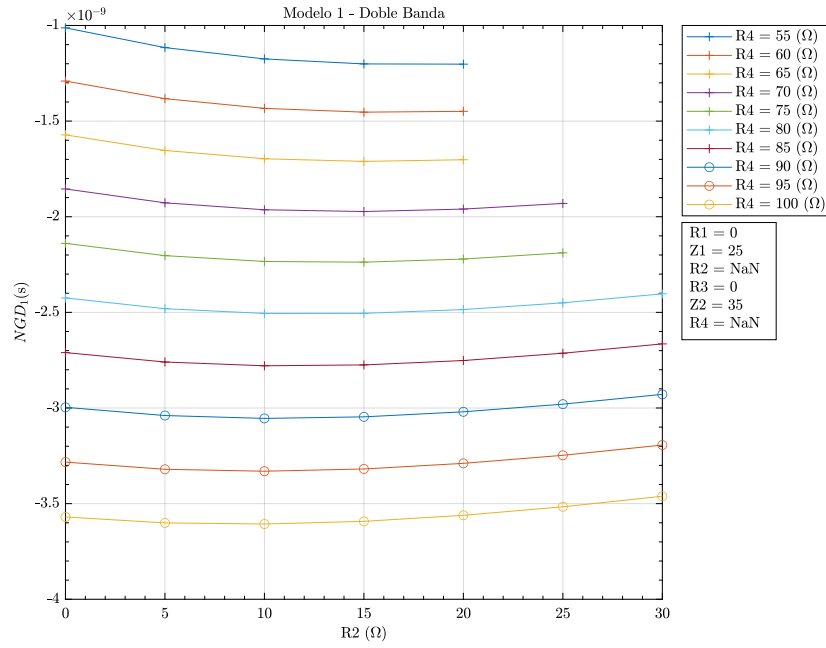


Figura 5.4: Curva de diseño en función de NGD

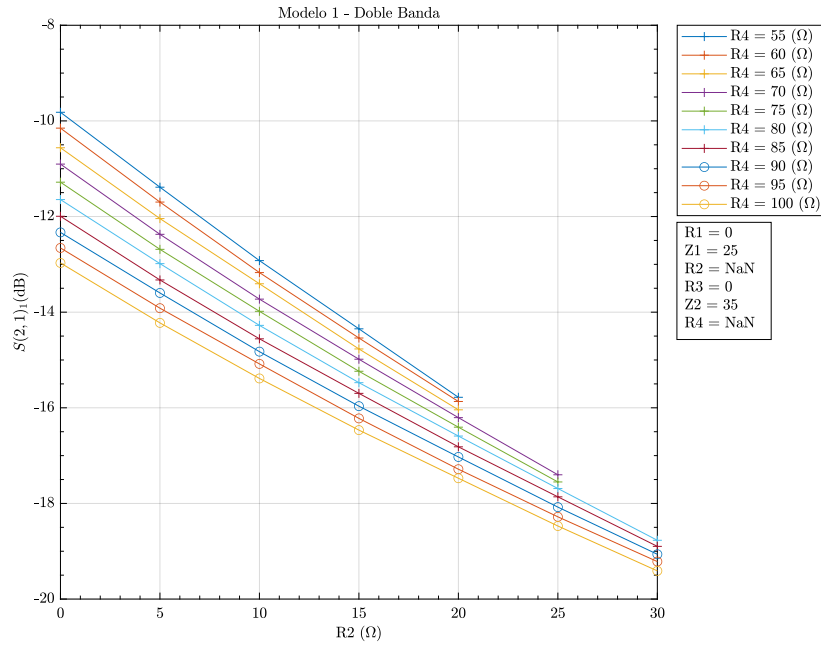


Figura 5.5: Curva de diseño en función del parámetro $S(2,1)$

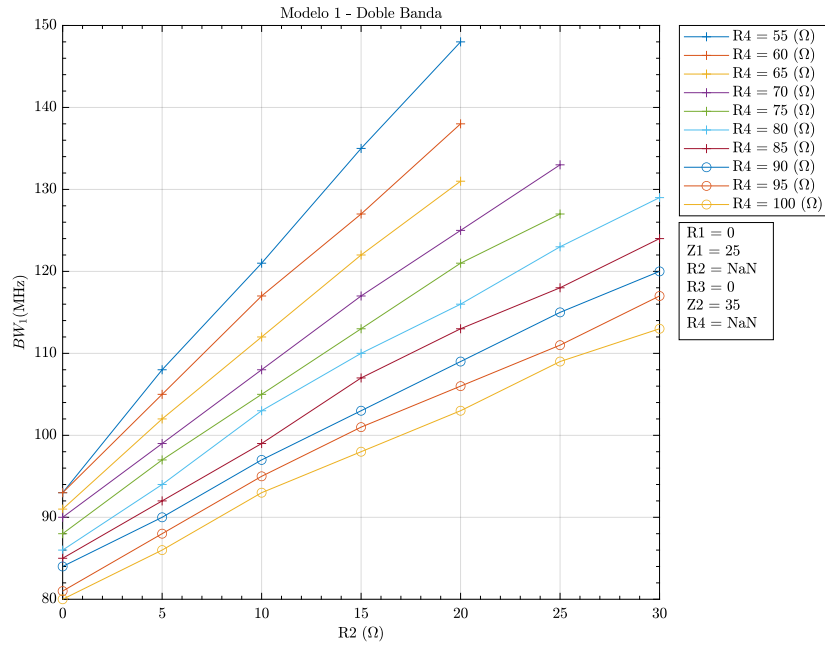


Figura 5.6: Curva de diseño en función del ancho de banda

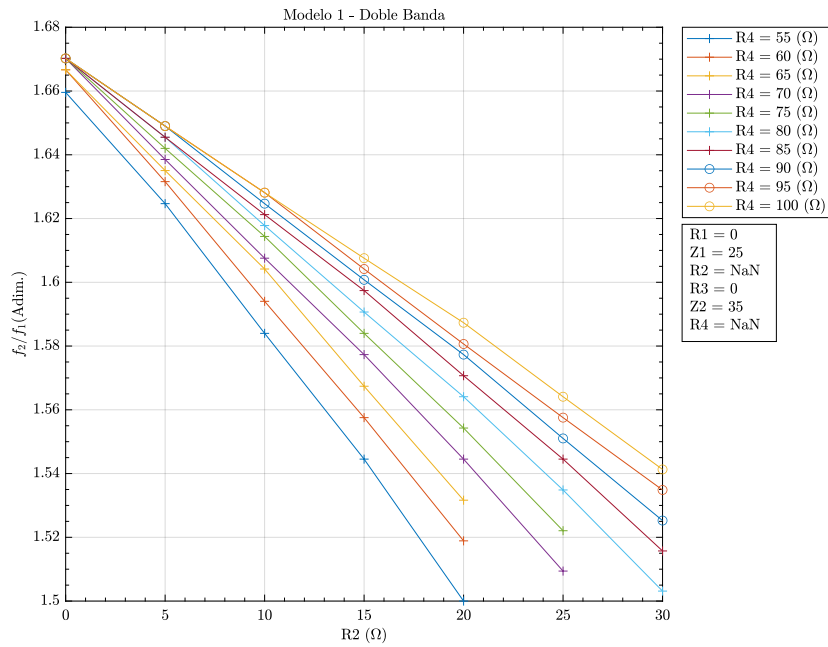


Figura 5.7: Curva de diseño en función de la relación entre bandas laterales

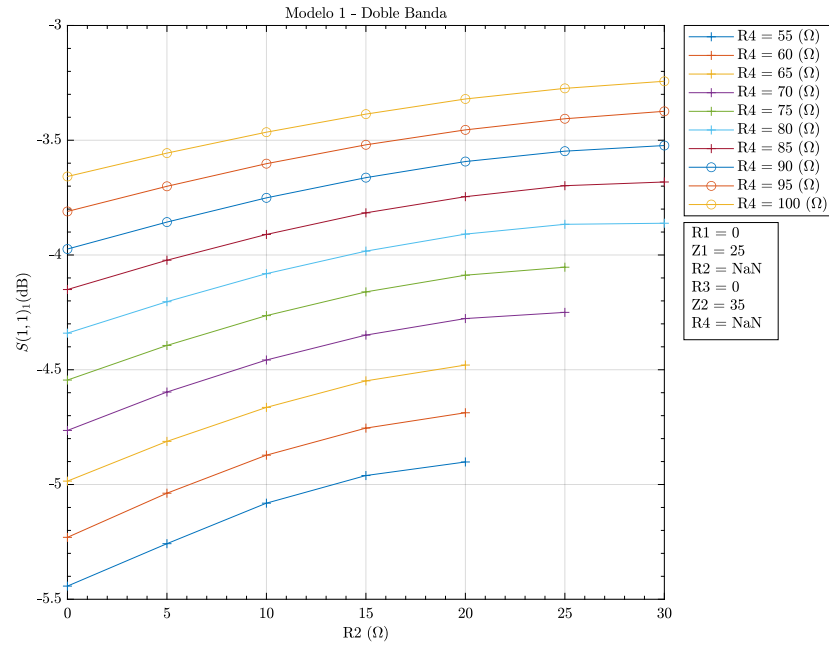


Figura 5.8: Curva de diseño en función del parámetro $S(1,1)$

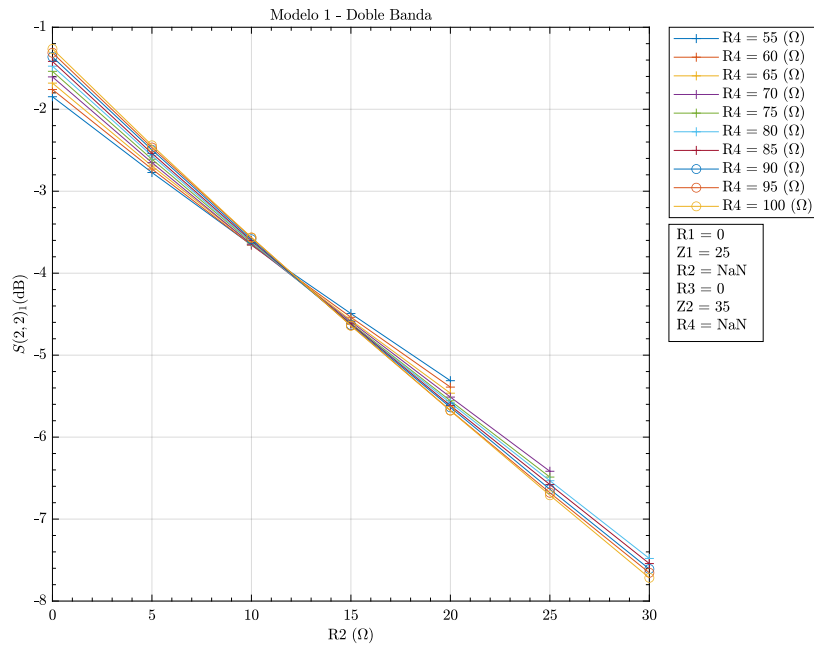


Figura 5.9: Curva de diseño en función del parámetro $S(2,2)$

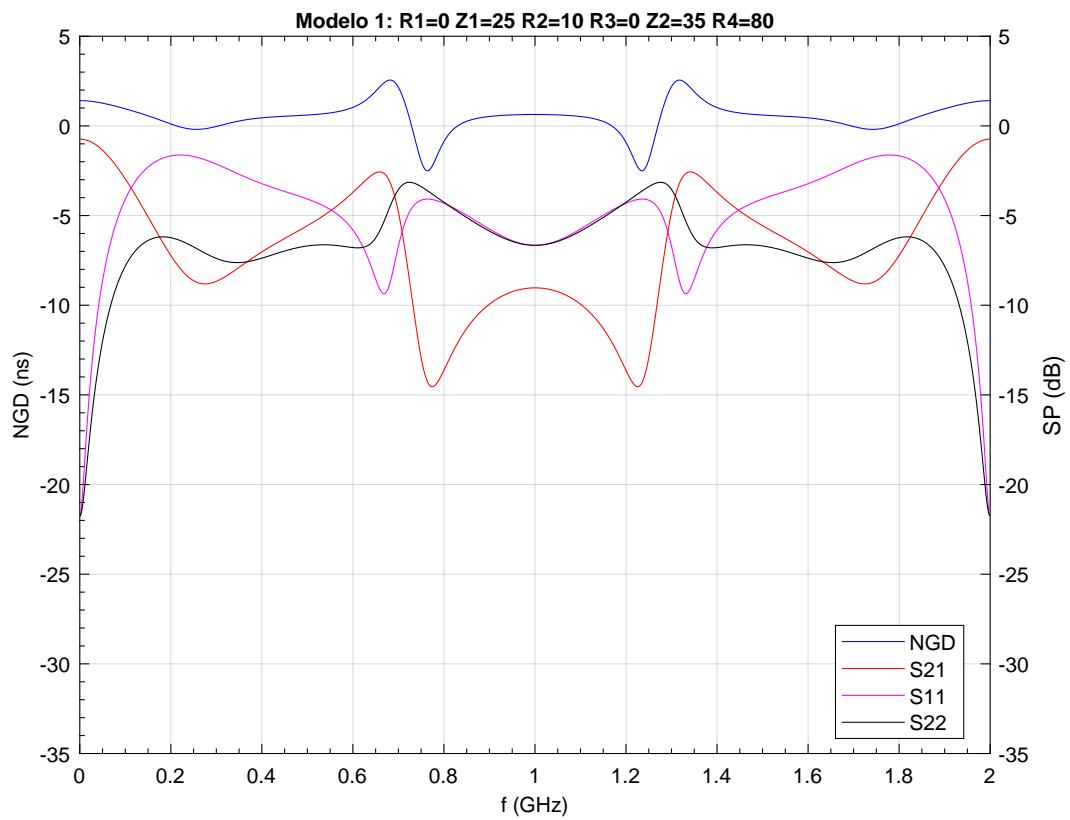


Figura 5.10: Respuesta ideal para la configuración seleccionada

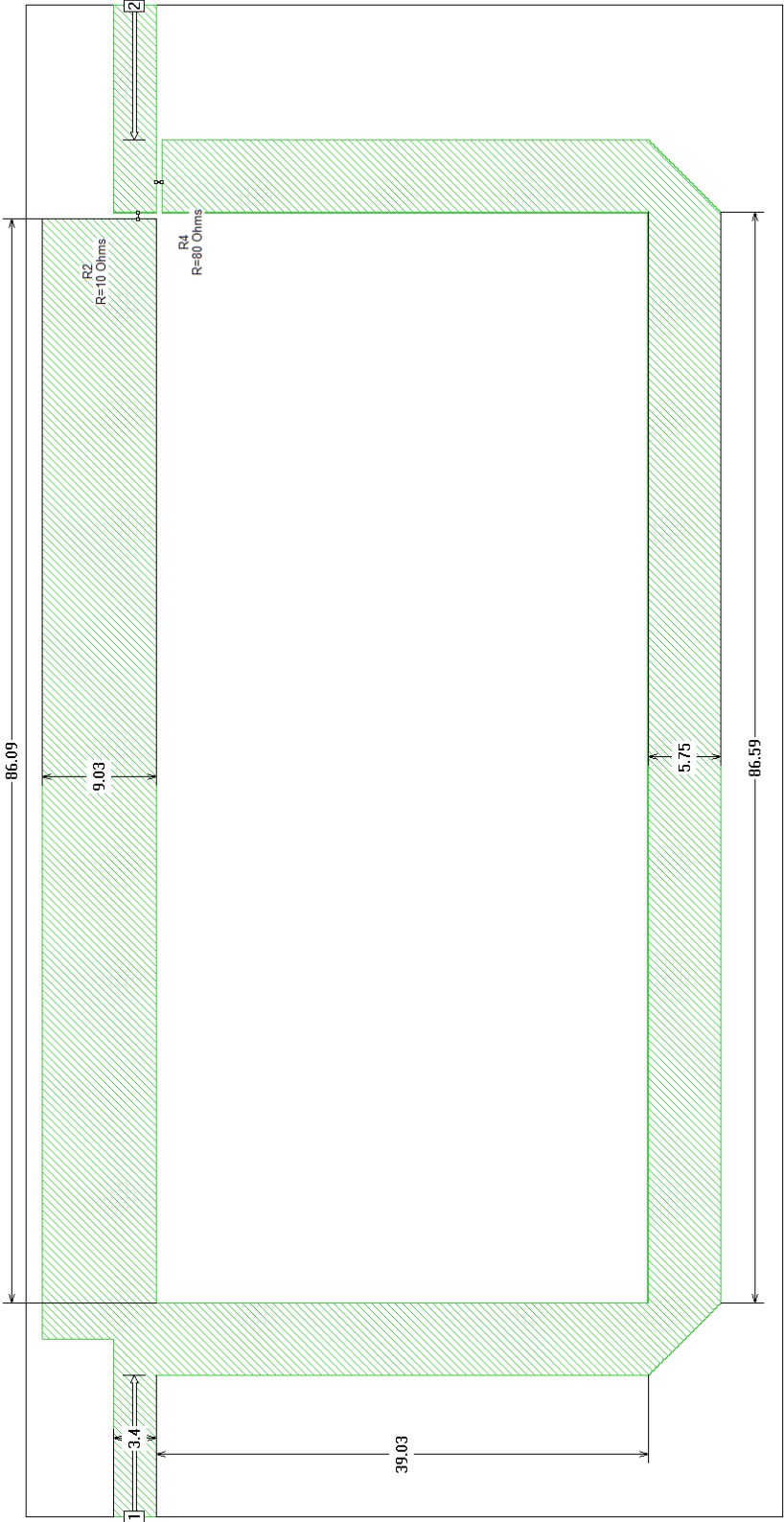


Figura 5.11: Diseño del prototipo en Sonnet (Rogers 4003)

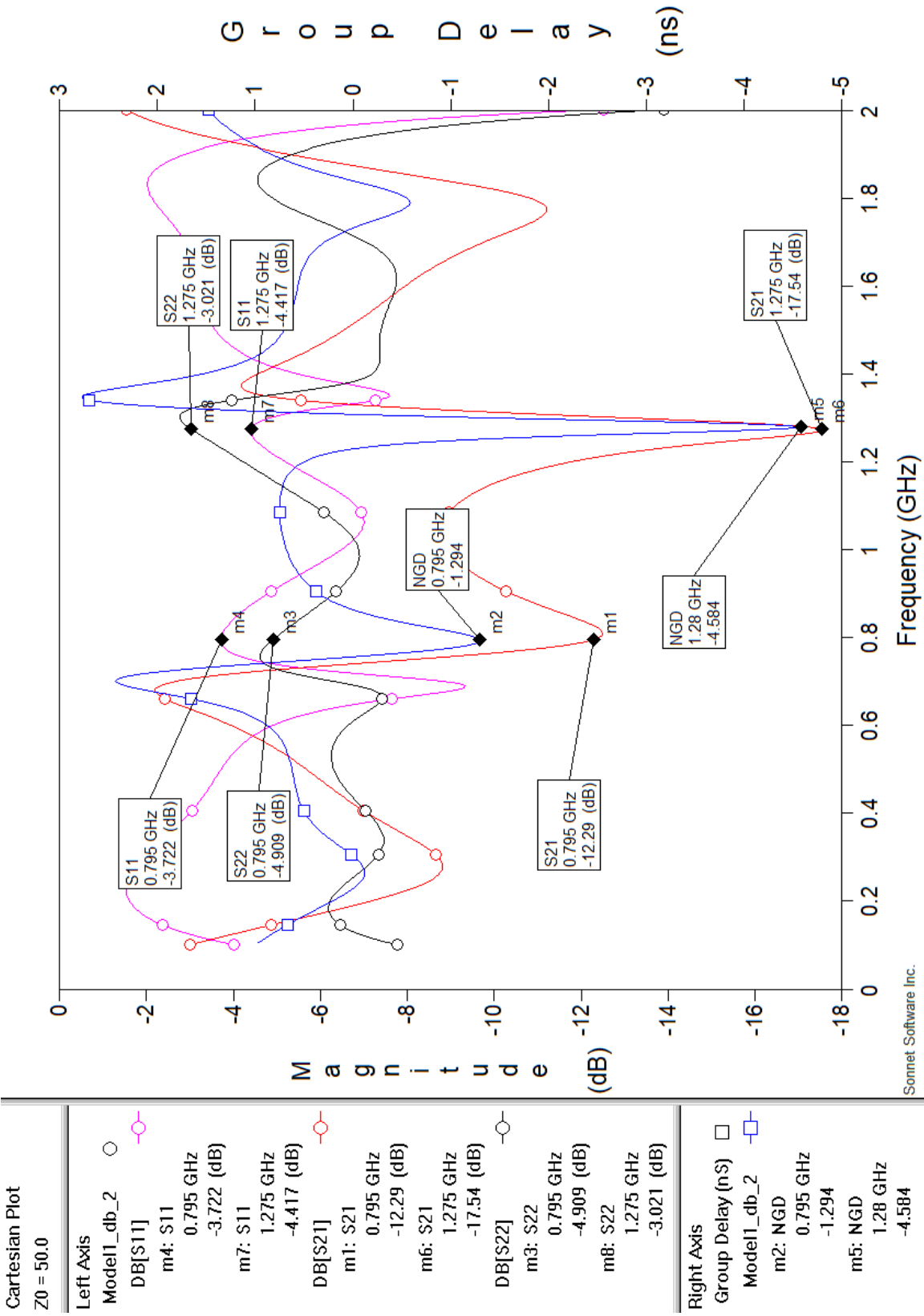


Figura 5.12: Respuesta del prototipo en Sonnet (Rogers 4003)

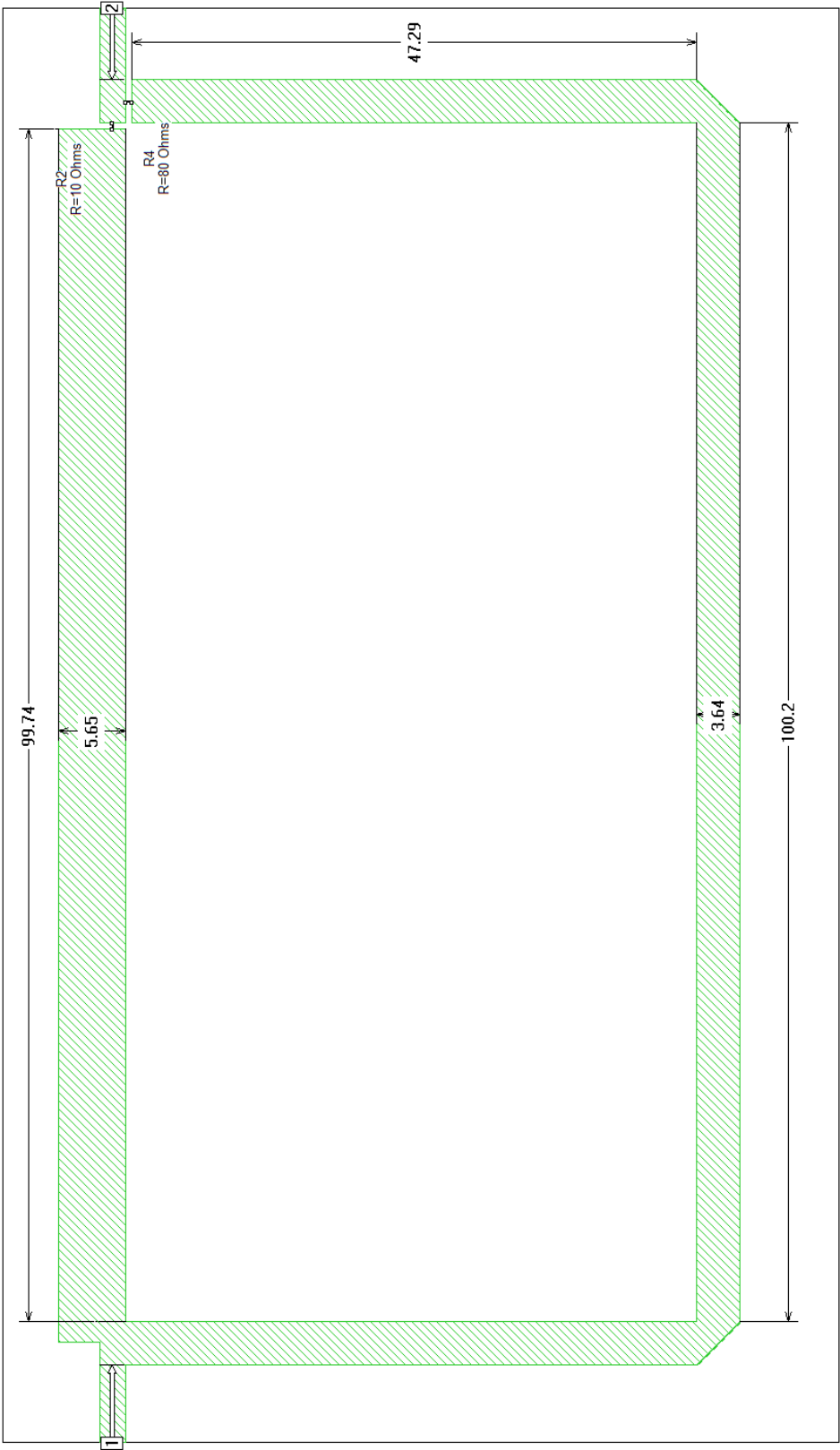


Figura 5.13: Diseño del prototipo en Sonnet (TLX-8)

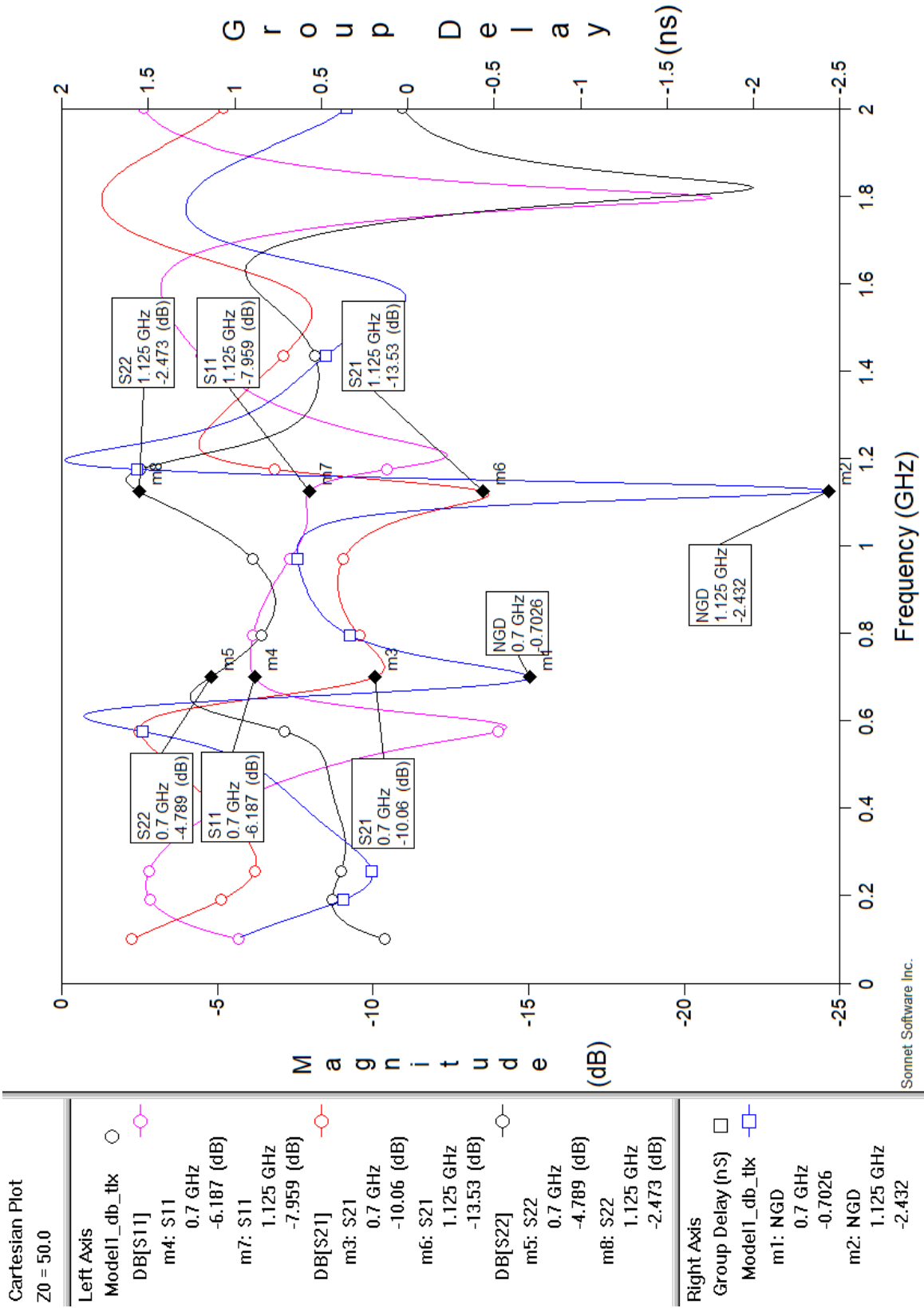


Figura 5.14: Respuesta del prototipo en Sonnet (TLX-8)

Por lo tanto, los valores obtenidos para ambas bandas tras la simulación de onda completa difieren de los calculados idealmente y se muestran en la Tabla 5.5.

Parámetro	Banda 1			Banda 2		
	Ideal	Rogers 4003	TLX-8	Ideal	Rogers 4003	TLX-8
NGD (ns)	-2,506	-1,294	-0,70	-2,506	-4,584	-2,43
f (MHz)	764	795	700	1.236	1.275	1.125
S_{21} (dB)	-14,28	-12,29	-10,06	-14,28	-17,54	-13,53
S_{11} (dB)	-4,08	-3,72	-6,19	-4,08	-4,42	-7,96
S_{22} (dB)	-3,62	-4,09	-4,79	-3,62	-3,02	-2,473
BW (MHz)	103	100	100	103	85	80

Tabla 5.5: Comparación entre la respuesta ideal y la simulada en onda completa

5.1.2. Modelo 1 - Triple Banda

Las condiciones para que se de la configuración Triple Banda se consisten en aplicar tanto a las bandas laterales como la central las condiciones de $ngd \leq -1 \cdot 10^{-9}$ (s) y $S_{2,1} \geq -20$ (dB). De esta forma es posible analizar paramétricamente el sistema. Al igual que con el caso de Doble Banda, se presentan en la Tabla 5.6 los valores mínimos y máximos para todos los parámetros de interés. También se adjuntan las distribuciones más interesantes tanto para las bandas laterales (indicado con el subíndice 1) como para la banda central (subíndice C) en las Figuras 5.15 y 5.16 respectivamente. En la Figura 5.17 se muestran los histogramas de las variables para las configuraciones Triple Banda

Por lo tanto, es posible encontrar curvas de diseño interesantes. En este sentido para $R_1 = R_2 = 5$ (Ω), $R_3 = 100$ (Ω) y $R_4 = 15$ (Ω) se encuentran casos de interés variando los valores de las impedancias superior e inferior. En las Figuras 5.18 - 5.29 se muestran las curvas de diseño pertinentes. Tal y como se observa, las curvas que describen las bandas centrales son más irregulares, por lo que aunque es relativamente sencillo encontrar un triple banda con NGD similares para sus tres bandas, es algo más complicado encontrar atenuaciones ($S(2,1)$) parecidas.

Tras seleccionar una combinación concreta, se obtiene la respuesta ideal en MATLAB® de la Figura 5.30. Los valores seleccionados para esta combinación se muestran en la Tabla 5.7. Y se obtiene una configuración con las características de la Tabla 5.8.

Parámetro	Mínimo	Máximo
$NGD_{1,2}$	-8,3681 ns	-1 ns
NGD_C	-6,2775 ns	-1 ns
f_2/f_1	1,2962	2,8095
$S_{21,2}$	-19,9913 dB	-5,8674 dB
S_{21C}	-19,9740 dB	-10,8818 dB
$S_{11,2}$	-8,1144 dB	-0,3491 dB
S_{11C}	-6,2014 dB	-1,2136 dB
$S_{22,2}$	-8,1144 dB	-0,3491 dB
S_{22C}	-6,2014 dB	-1,2136 dB
$BW_{1,2}$	53 MHz	109 MHz
BW_C	93 MHz	213 MHz
$BW_{1dB,2}$	17 MHz	203 MHz
BW_{1dB_C}	22 MHz	90 MHz
$BW_{3dB,2}$	33 MHz	384 MHz
BW_{3dB_C}	44 MHz	176 MHz

Tabla 5.6: Análisis numérico del Modelo 1 - Triple Banda

$R_1(\Omega)$	$Z_1(\Omega)$	$R_2(\Omega)$	$R_3(\Omega)$	$Z_2(\Omega)$	$R_4(\Omega)$
5	95	5	10	125	15

Tabla 5.7: Valores seleccionados para las pruebas del Modelo 1 - Triple Banda

Parámetro	Valor
$NGD_{1,2}$	-3,003 ns
NGD_C	-3,697 ns
f_2/f_1	2,2
$S_{21,2}$	-13,92 dB
S_{21C}	-19,24 dB
$S_{11,2}$	-2,467 dB
S_{11C}	-2,986 dB
$S_{22,2}$	-2,205 dB
S_{22C}	-2,986 dB
$BW_{1,2}$	85 MHz
BW_C	101 MHz
$BW_{1dB,2}$	36 MHz
BW_{1dB_C}	34 MHz
$BW_{3dB,2}$	72 MHz
BW_{3dB_C}	64 MHz

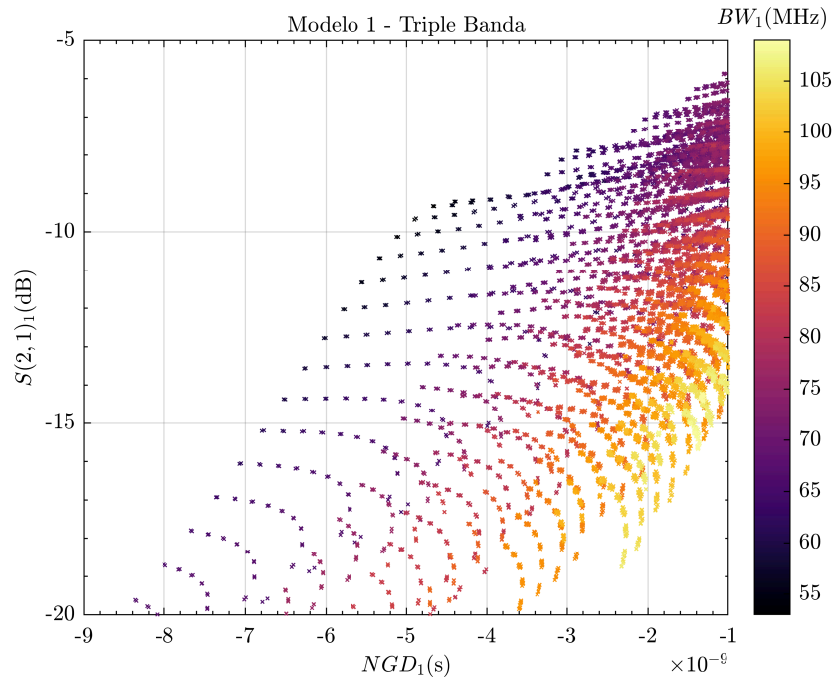
Tabla 5.8: Valor de los parámetros para el caso elegido del Modelo 1 - Doble Banda

Por otro lado, para realizar la simulación en onda completa, se sintetizan las impedancias para obtener sus equivalentes en longitud y anchura, tal y como se muestra en la Tabla 5.9.

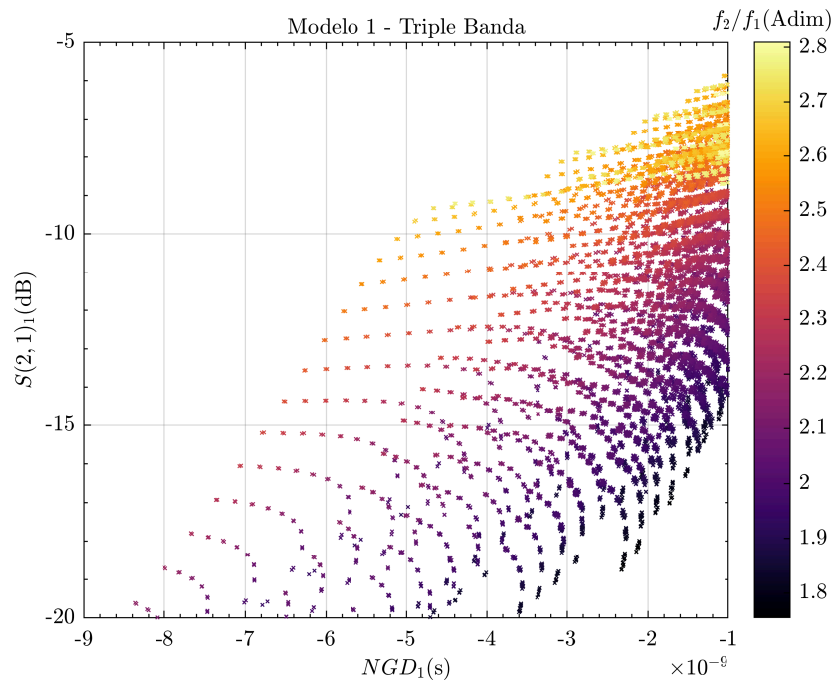
	Eléctricos		Rogers 4003		TLX-8	
Línea de Transmisión	$Z_0(\Omega)$	$\theta_0(\Omega)$	$W(\text{mm})$	$L(\text{mm})$	$W(\text{mm})$	$L(\text{mm})$
Superior (TL1)	95	180°	0,93	94,13	0,65	107,25
Inferior (TL2)	125	360°	0,41	191,81	0,31	218,12
Puertos	50		3,36		2,17	

Tabla 5.9: Dimensiones físicas para el caso bajo estudio del Modelo 1 - Triple Banda

Al igual que en el apartado anterior, se ha simulado dicho en onda completa mediante el software Sonnet. Los prototipos y las respuestas tanto para el sustrato Rogers 4003 como para el TLX-8 se muestran en las Figuras 5.31 - 5.34.

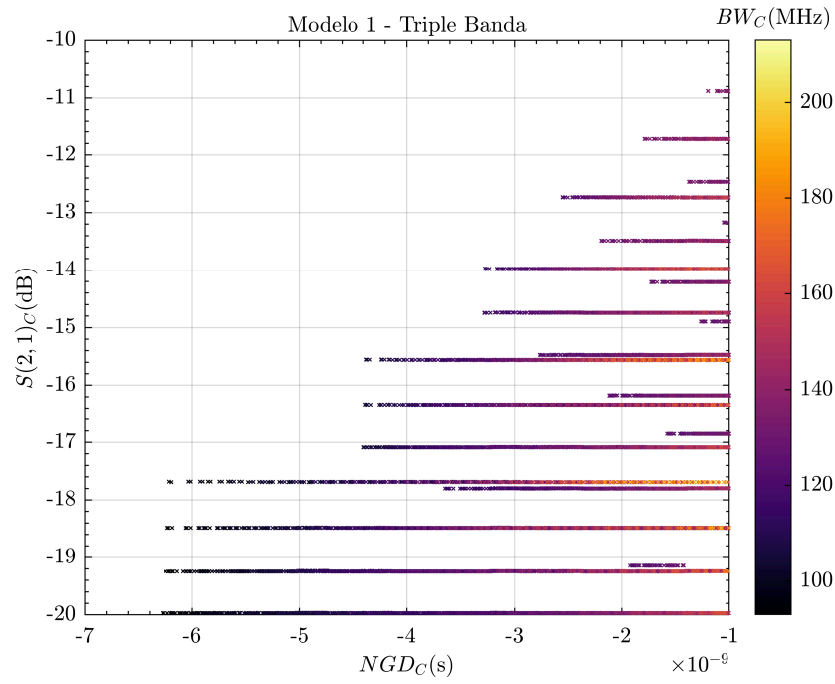


(a) NGD frente a atenuación y ancho de banda.

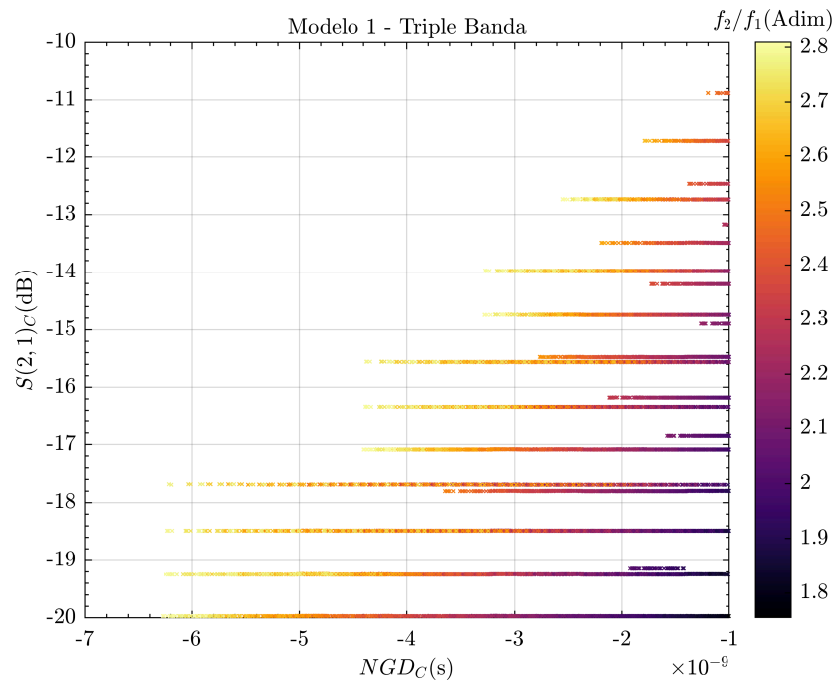


(b) NGD frente a atenuación y relación entre bandas.

Figura 5.15: Análisis Modelo 1 - Triple Banda para las bandas laterales



(a) NGD frente a atenuación y ancho de banda.



(b) NGD frente a atenuación y relación entre bandas.

Figura 5.16: Análisis Modelo 1 - Triple Banda para la banda central

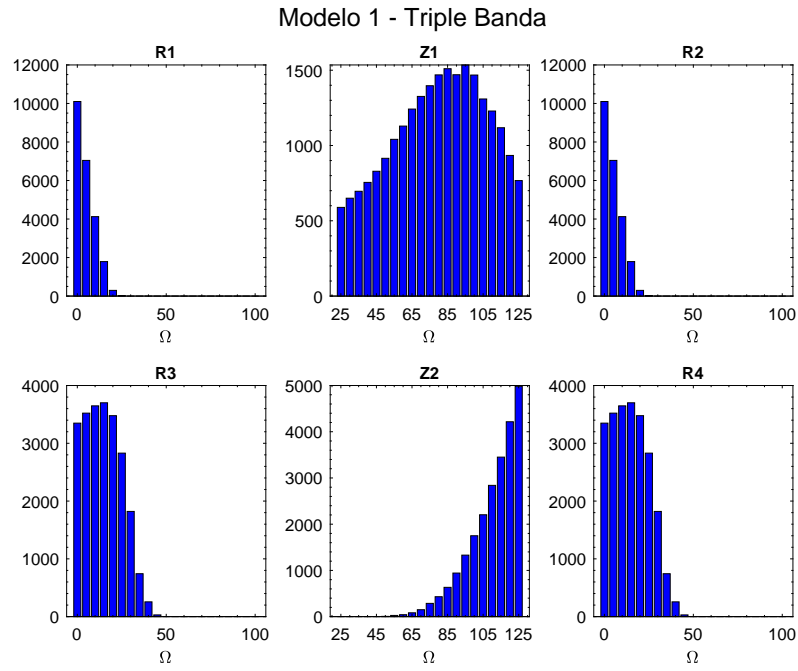


Figura 5.17: Histogramas de las variables para el Modelo 1 - Triple Banda

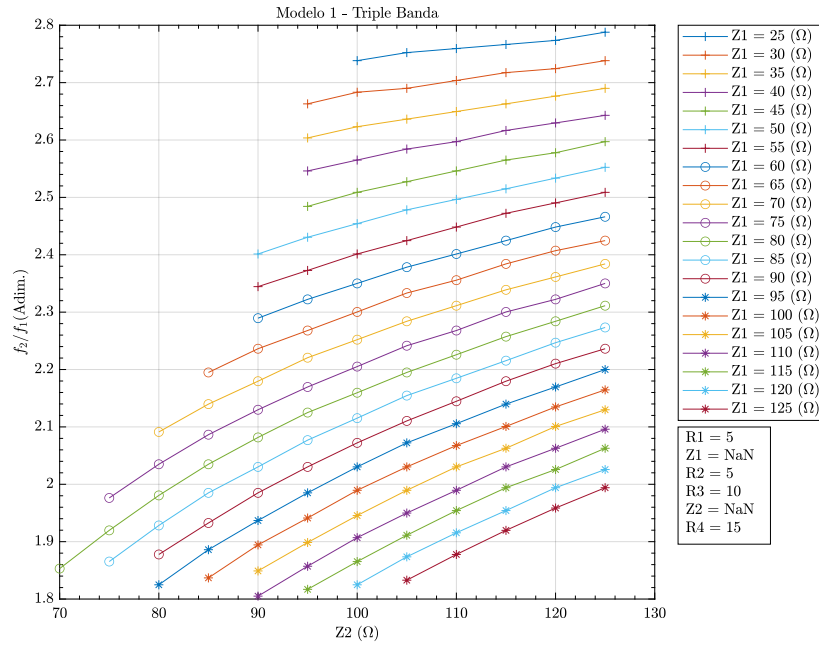


Figura 5.18: Curva de diseño en función de la relación entre bandas laterales

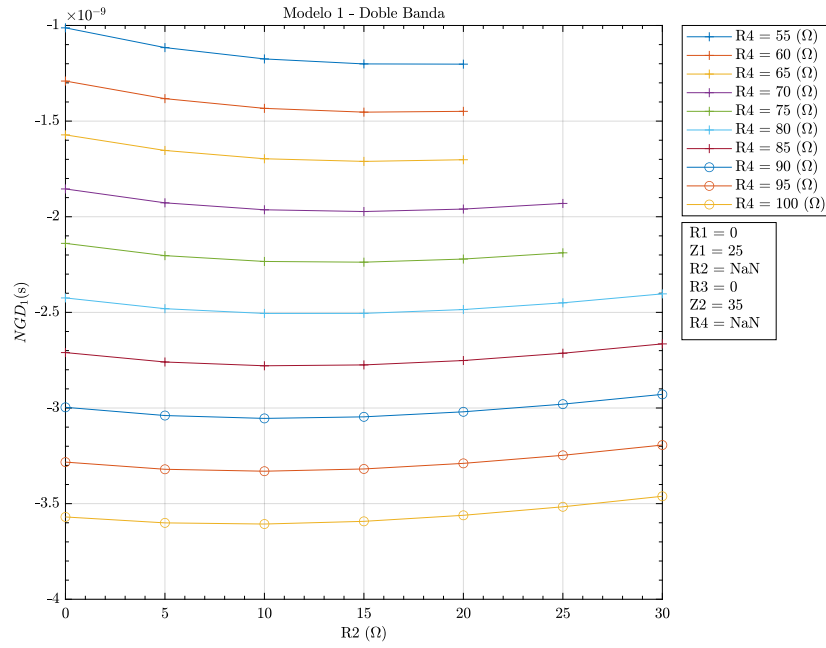


Figura 5.19: Curva de diseño en función de NGD

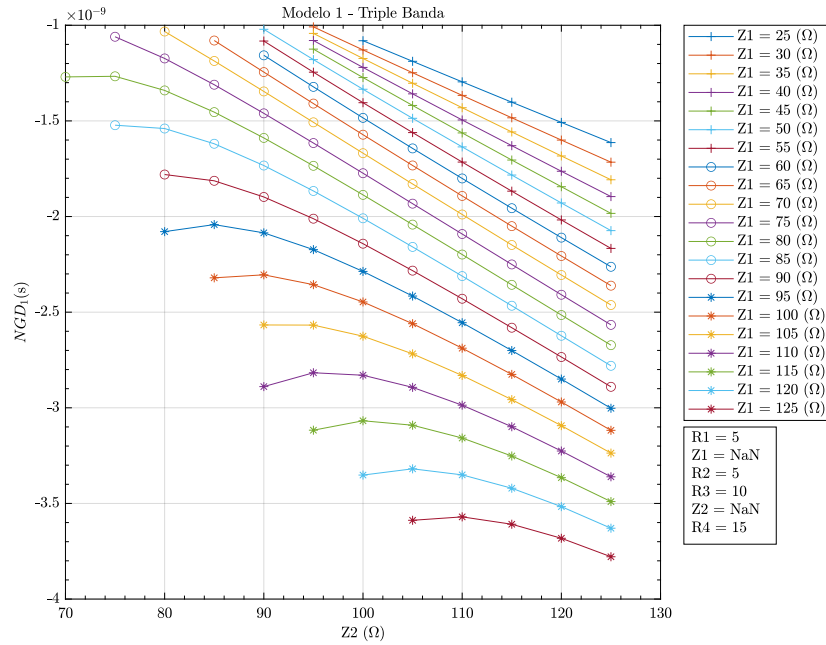


Figura 5.20: Curva de diseño en función de NGD de las bandas laterales

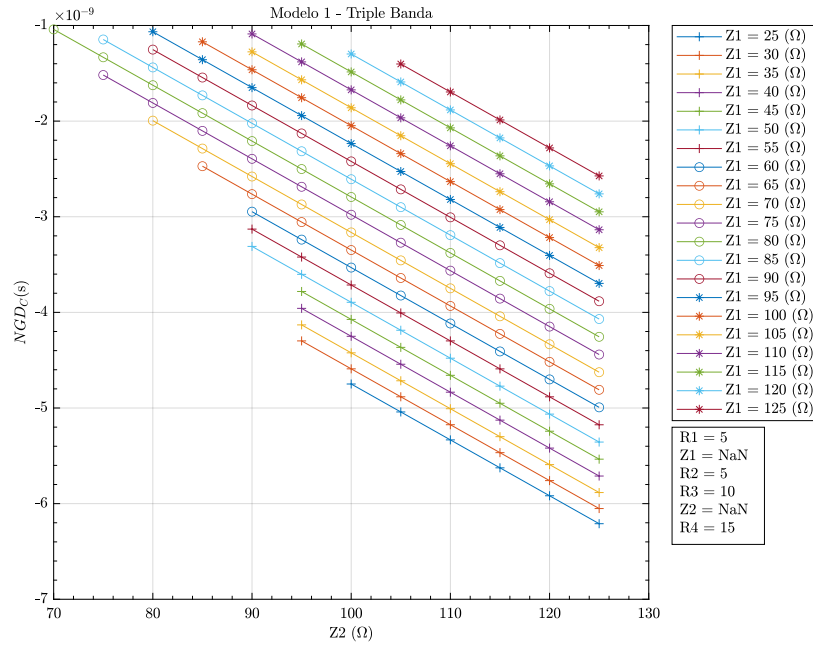


Figura 5.21: Curva de diseño en función de NGD de la banda central

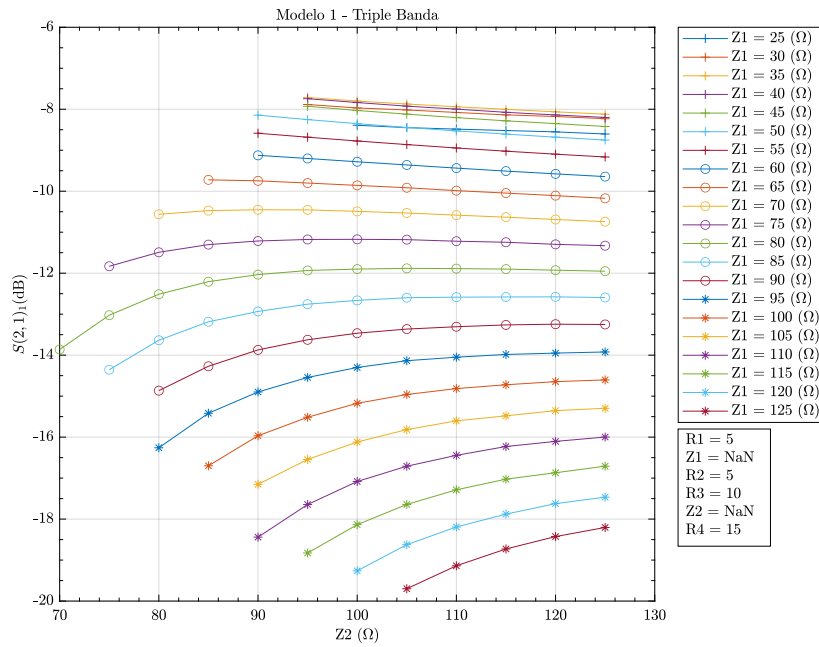


Figura 5.22: Curva de diseño en función del parámetro $S(2,1)$ de las bandas laterales

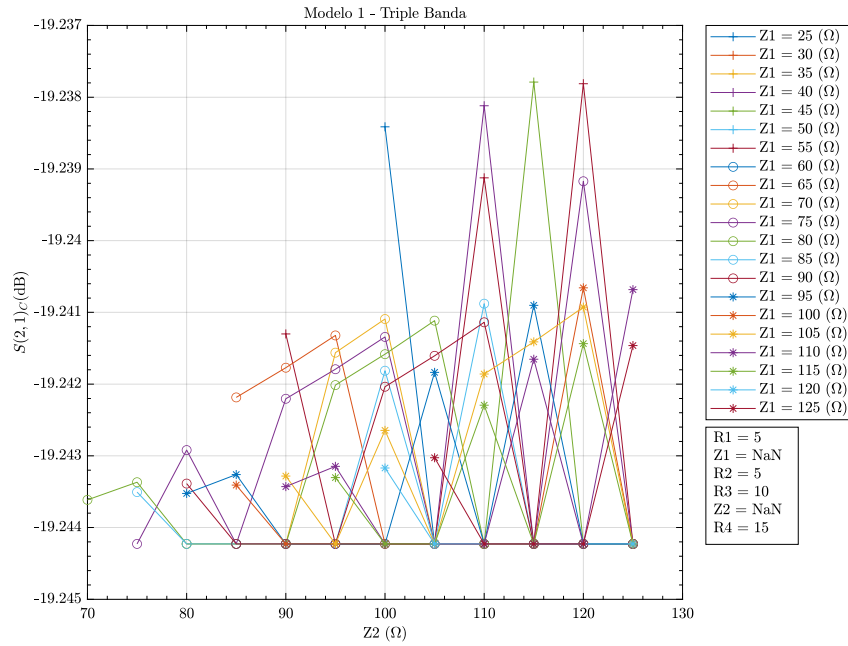


Figura 5.23: Curva de diseño en función del parámetro $S(2,1)$ de la banda central

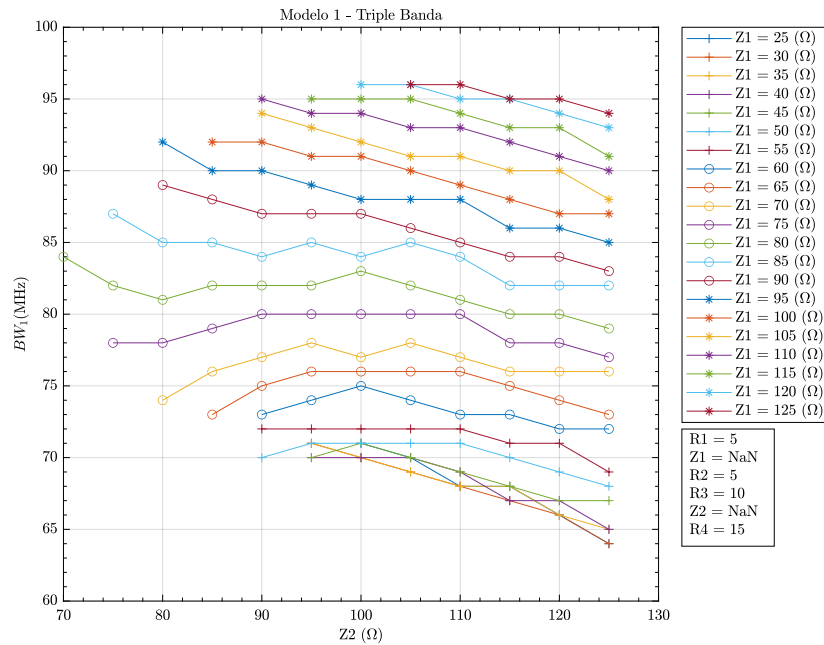


Figura 5.24: Curva de diseño en función del ancho de banda de las bandas laterales

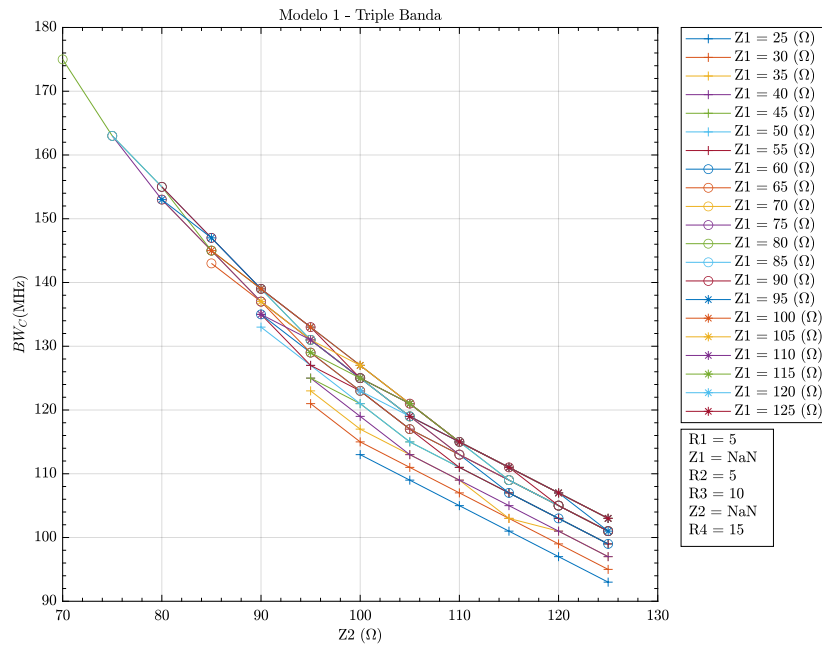


Figura 5.25: Curva de diseño en función del ancho de banda de la banda central

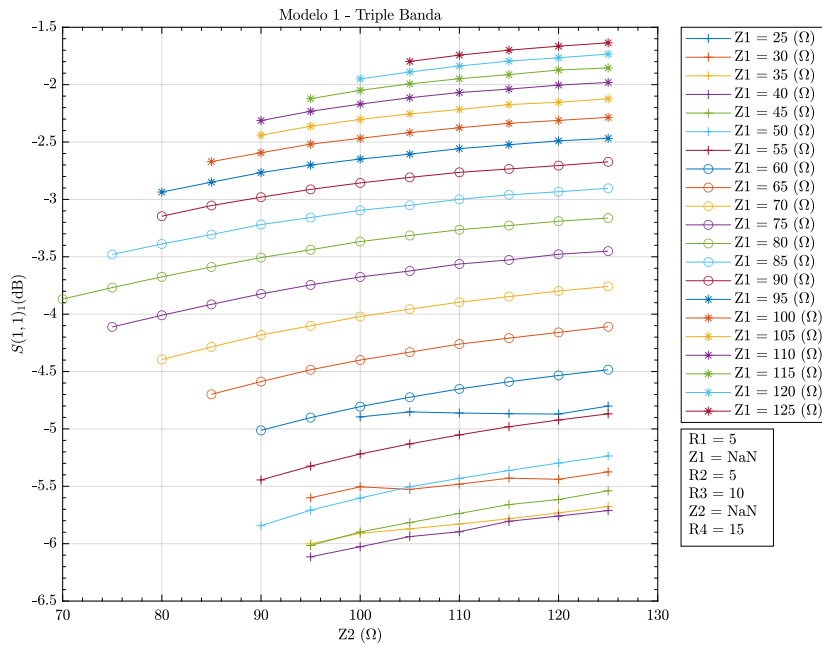


Figura 5.26: Curva de diseño en función del parámetro $S(1,1)$ de las bandas laterales

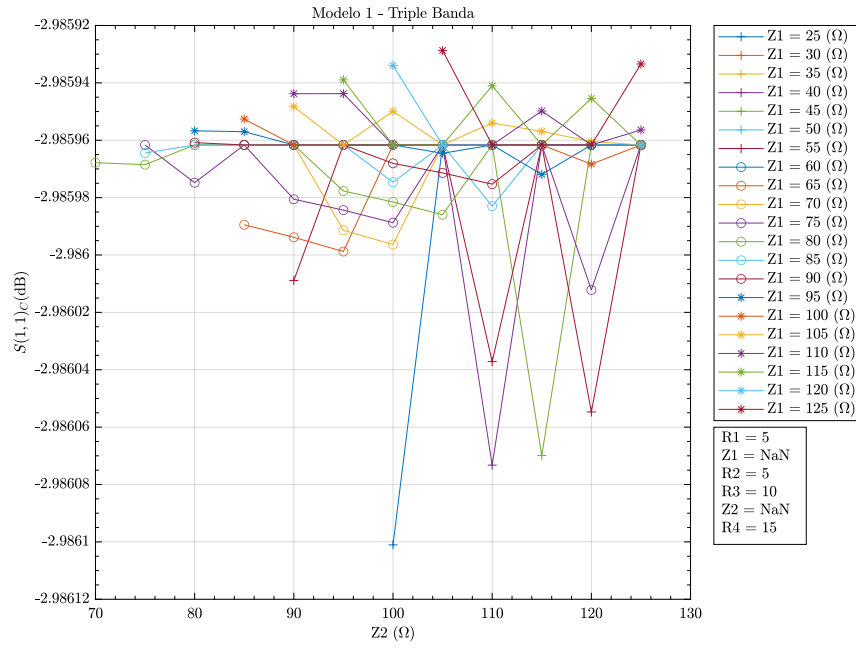


Figura 5.27: Curva de diseño en función del parámetro $S(1,1)$ de la banda central

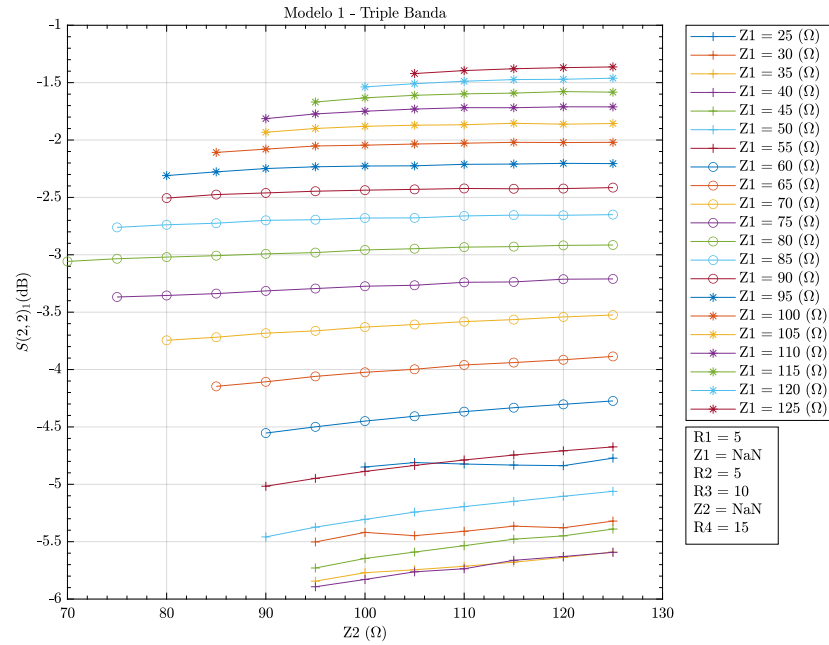


Figura 5.28: Curva de diseño en función del parámetro $S(2,2)$ de las bandas laterales

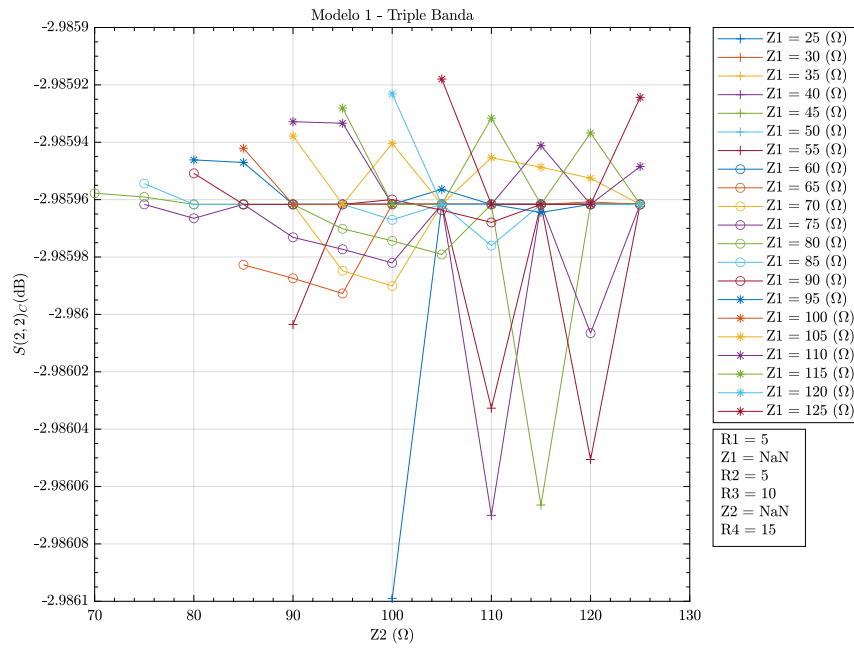


Figura 5.29: Curva de diseño en función del parámetro $S(2,2)$ de la banda central

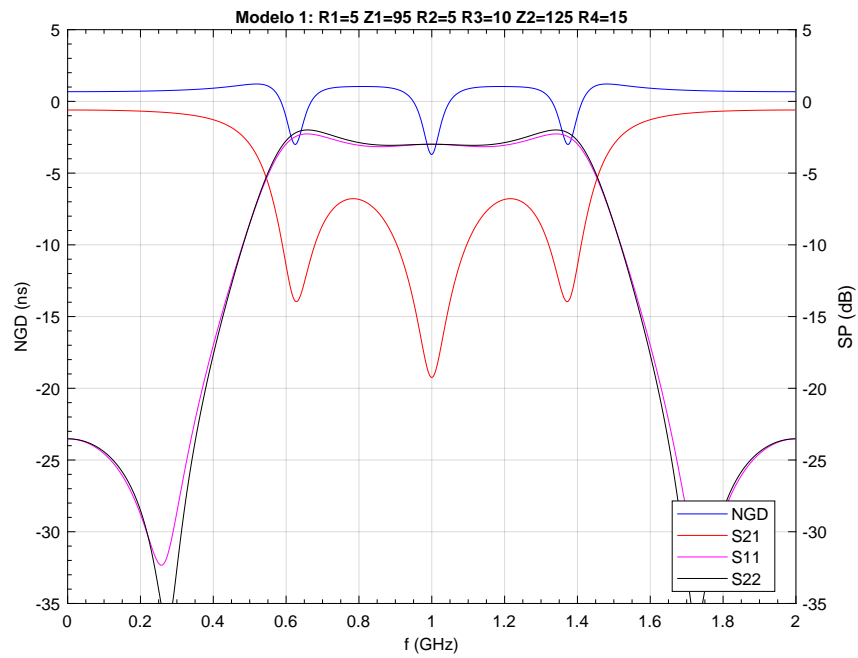


Figura 5.30: Respuesta ideal para la configuración seleccionada

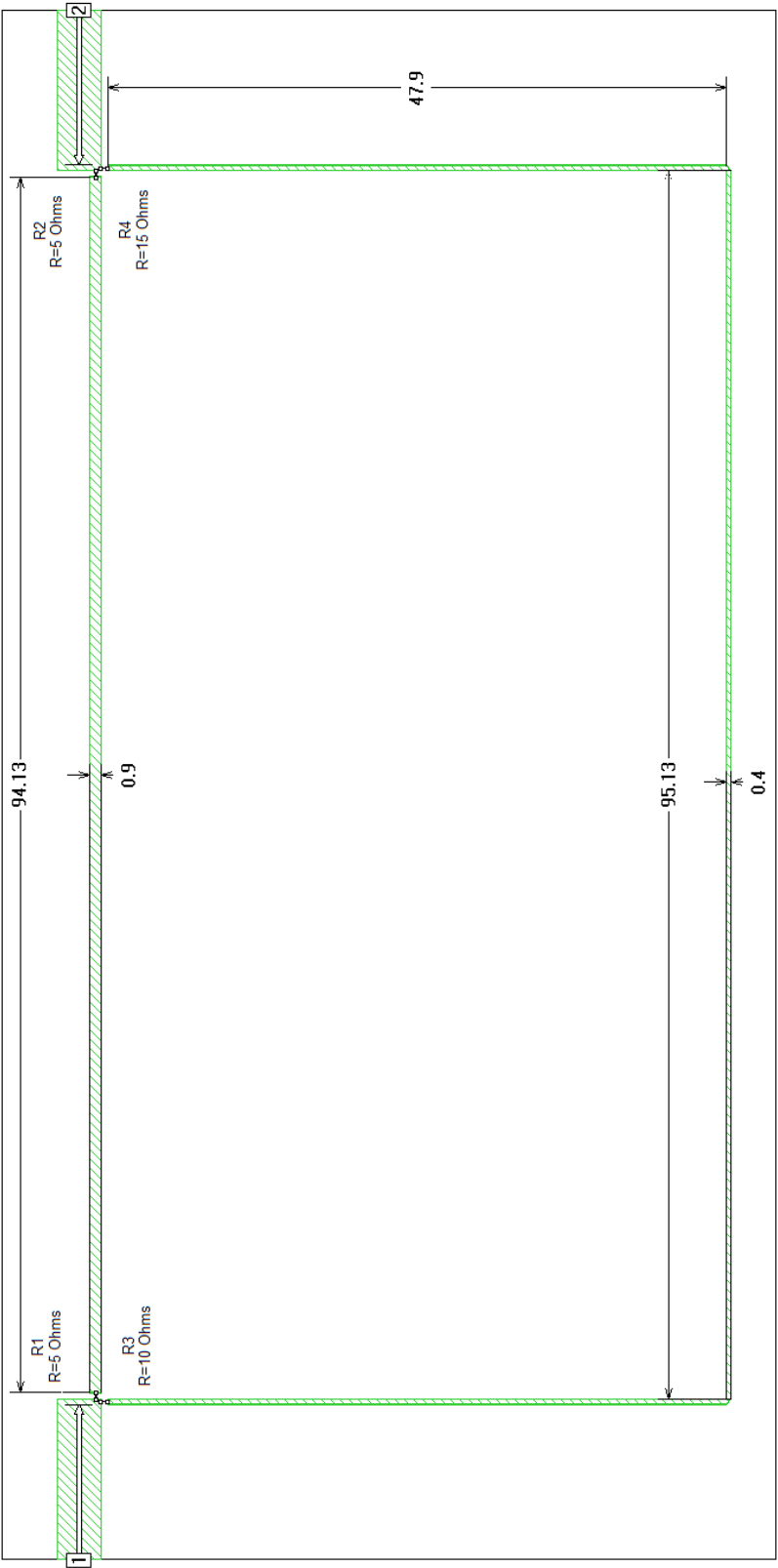


Figura 5.31: Diseño del prototipo en Sonnet (Rogers 4003)

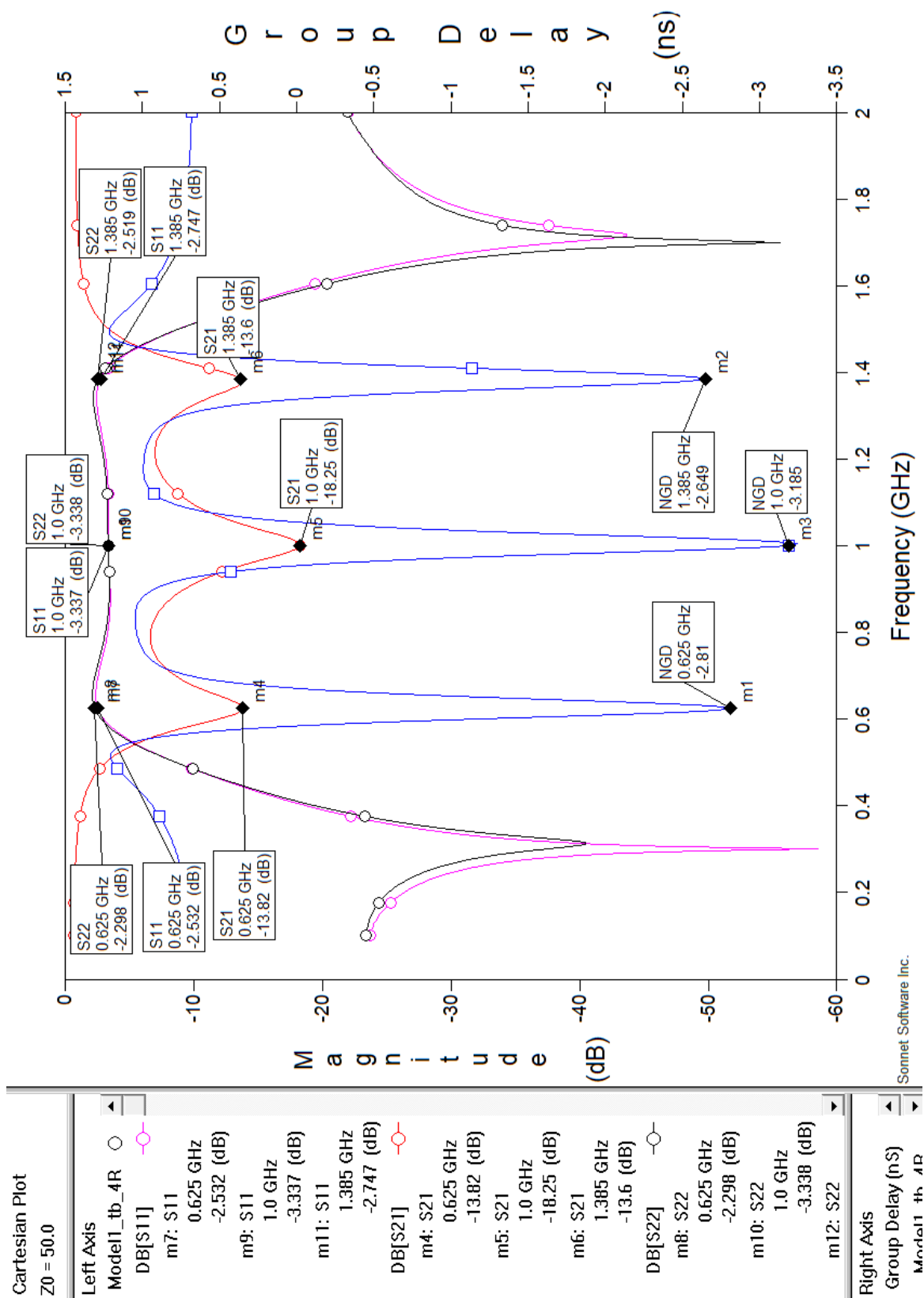


Figura 5.32: Respuesta del prototipo en Sonnet (Rogers 4003)

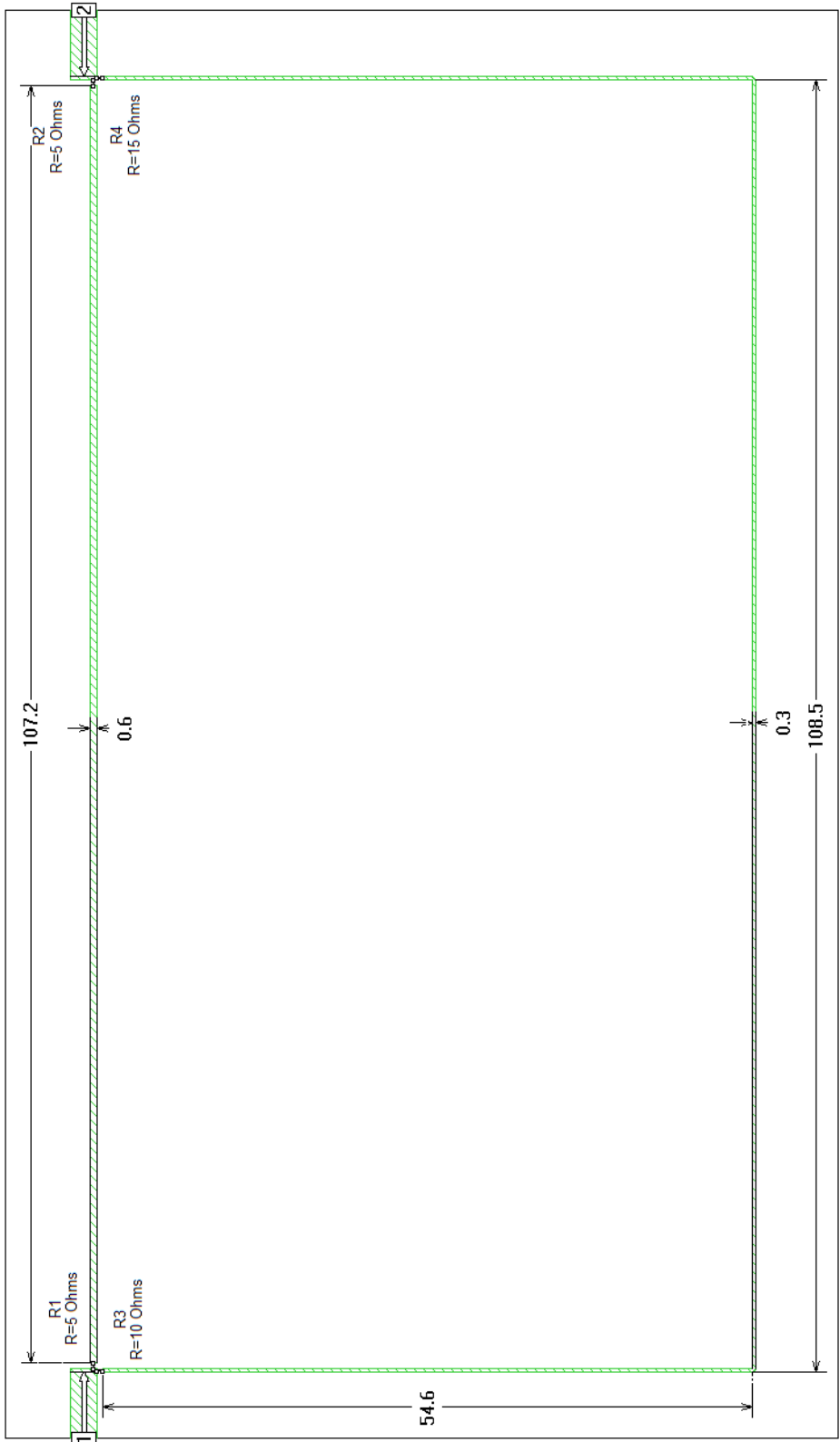


Figura 5.33: Diseño del prototipo en Sonnet (TLX-8)

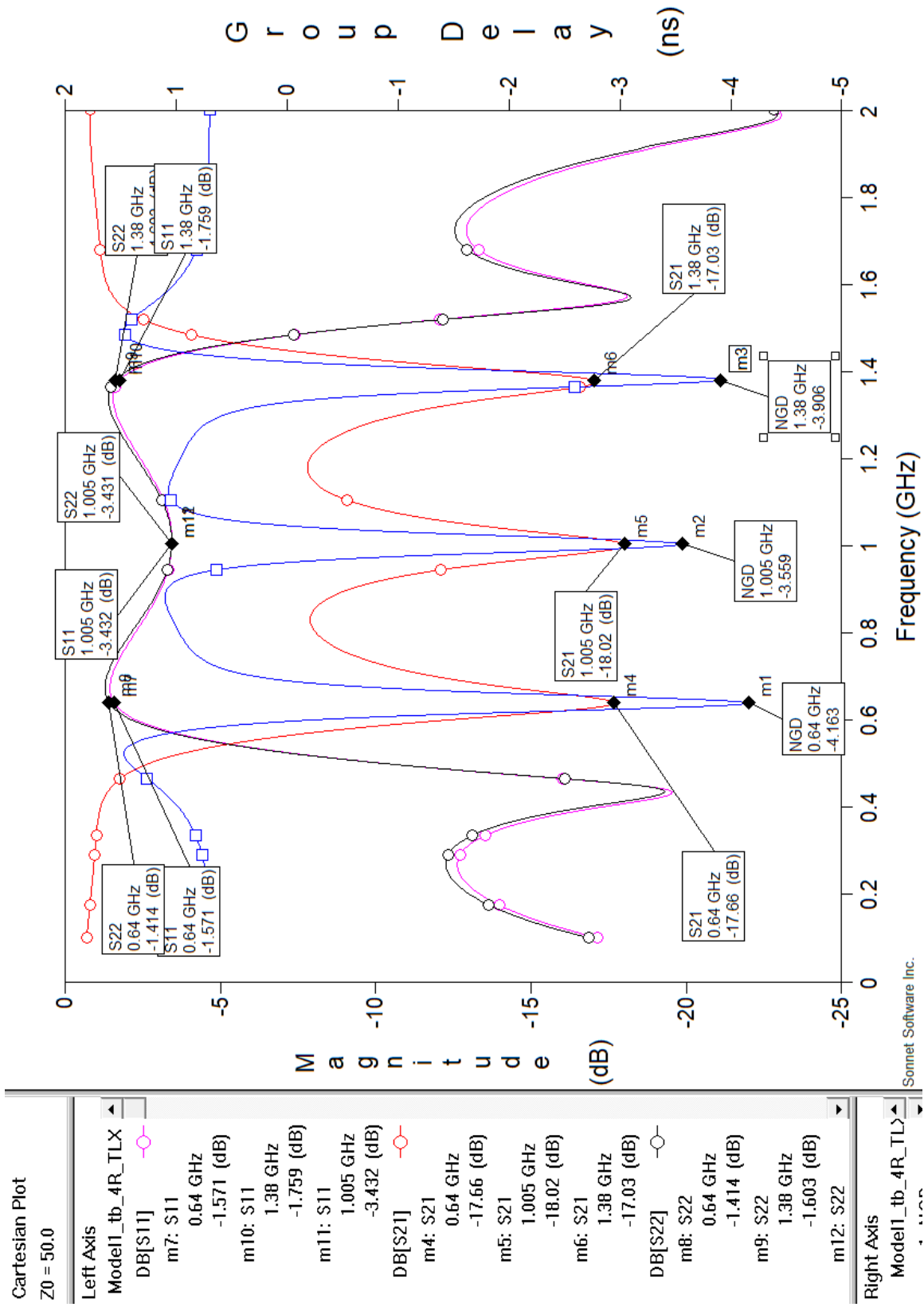


Figura 5.34: Respuesta del prototipo en Sonnet (TLX-8)

Finalmente, los valores obtenidos para todas las bandas tras la simulación de onda completa son más similares a los calculados idealmente que en el caso anterior y se muestran en la Tabla 5.10.

		NGD (ns)	f (MHz)	S_{21} (dB)	S_{11} (dB)	S_{22} (dB)	BW (MHz)
Banda 1	Ideal	-3,003	625	-13,92	-2,467	-2,205	85
	Rogers 4003	-2,81	625	-13,82	-2,532	-2,298	85
	TLX-8	-4,163	640	-17,66	-1,571	-1,414	90
Banda Central	Ideal	-3,697	1000	-19,24	-2,986	-2,986	101
	Rogers 4003	-3,241	1005	-18,21	-3,333	-3,334	95
	TLX-8	-3,559	1005	-18,02	-3,432	-3,431	80
Banda 2	Ideal	-3,003	1375	-13,92	-2,467	-2,205	85
	Rogers 4003	-2,649	1385	-13,6	-2,747	-2,519	85
	TLX-8	-3,906	1380	-17,03	-1,759	-1,603	90

Tabla 5.10: Comparación entre la respuesta ideal y la simulación en onda completa - Triple Banda

5.1.3. Modelo 1 - Banda Central

Ya por último restaría comentar el análisis de la topología para obtener una respuesta con una única banda central. Este era, tal y como se comentó en el Capítulo 3 el objetivo principal de este TFM. Sin embargo los resultados que se obtienen no son excesivamente interesantes, por lo que no se ha implementado ningún prototipo y simulado en onda completa. A continuación se exponen los valores mínimos y máximos para cada parámetro (Tabla 5.11 al igual que la distribución de las combinaciones en la Figura 5.35. De éstos datos es posible extraer que no es posible obtener características adecuadas en cuanto a NGD , atenuación y ancho de banda.

Parámetro	Mínimo	Máximo
NGD	$-3,4647$ ns	-1 ns
S_{21}	-20 dB	$-10,9306$ dB
S_{11}	-343 dB	$-1,2136$ dB
S_{22}	-343 dB	$-1,2136$ dB
BW	55 MHz	293 MHz
BW_{1dB}	36 MHz	104 MHz
BW_{3dB}	70 MHz	196 MHz

Tabla 5.11: Análisis numérico del Modelo 1 - Banda Central

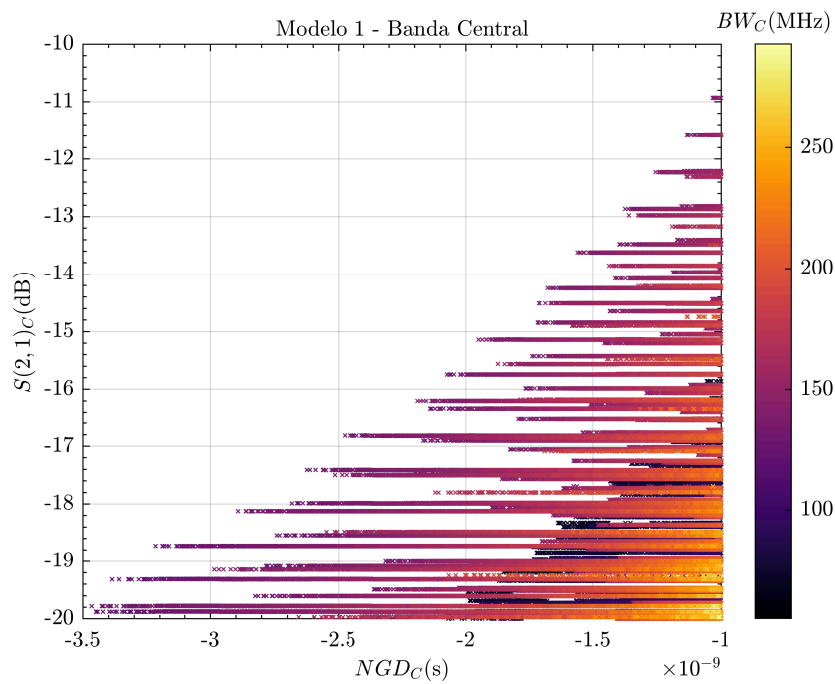


Figura 5.35: NGD frente a atenuación y ancho de banda (Análisis Modelo 1 - Banda Central)

6. Conclusiones y líneas futuras

El presente TFM tenía por objetivo realizar un estudio de estructuras con retardo de grupo negativo (NGD) en tecnología microstrip. Inicialmente pretendía evaluar la topología del Modelo 1, que es relativamente sencilla, para conseguir un ancho de banda, NGD y atenuación capaces de competir con otras estructuras publicadas, como las que se expusieron en el Capítulo 1. Sin embargo, las características de esta topología han supuesto una variación en la metodología planteada inicialmente: en este TFM no sólo se ha realizado un estudio de una topología concreta, sino que se ha desarrollado un sistema capaz de evaluar paramétricamente por fuerza bruta ésta u otras topologías similares.

La fuerza de computación disponible actualmente ha permitido que de un diseño del cual inicialmente no parecía poder extraerse grandes resultados, sea posible parame-trizarlo en base a las variables de mayor interés. Tanto las curvas de diseño mostradas como los diseños simulados en onda completa no tienen por qué ser aquellos con mejores características, sino que son sólo una muestra de lo que el sistema de análisis es capaz de ofrecer: la posibilidad de encontrar rápidamente combinaciones que se adapten a los requisitos.

Una de las posibilidades que surgieron durante la realización de este trabajo, fue introducir una resistencia intermedia en las líneas de transmisión, para comprobar si así era posible anular los ceros de transmisión y conseguir mejores características. Esta variación da pie a tres posibles circuitos que se muestran en la Figura 6.1.

Puesto que el sistema de cómputo desarrollado en Python es escalable, fue posible introducir los cambios pertinentes en el código para computar el Modelo 2 y el Modelo 3. Para computar dichos modelos se utilizó Google Cloud Platform teniendo en cuenta que la variable T , que indica la longitud eléctrica de la línea en cuestión, varía en pasos de 10° . Además, puesto que el sistema es simétrico, no es necesario que la variable T_1 tome todos los valores, sino sólo aquellos de 0 a 90° , al igual que la variable T_2 sólo de 0 a 180° . Pese a estas reducciones, cada vez que se computaba el Modelo 2 o 3 para un valor de T fijo el tiempo necesario de cómputo era de 30 horas en una instancia de Google de 16 procesadores virtuales (a demanda) y 14,5 GB de memoria RAM; o de 35 horas en el ordenador personal utilizado para el cómputo del Modelo 1 de este TFM. Esto supone que son necesarias 300 horas de computación en Google Cloud Platform para el Modelo 2 y 600 horas para el Modelo 3.

Los Modelos 2 y 3 fueron computados y a día de hoy es posible analizarlos directamente con las herramientas desarrolladas en MATLAB[®] o introduciendo algunos pequeños cambios para adaptar el nombre de las variables y el número de éstas. Sin

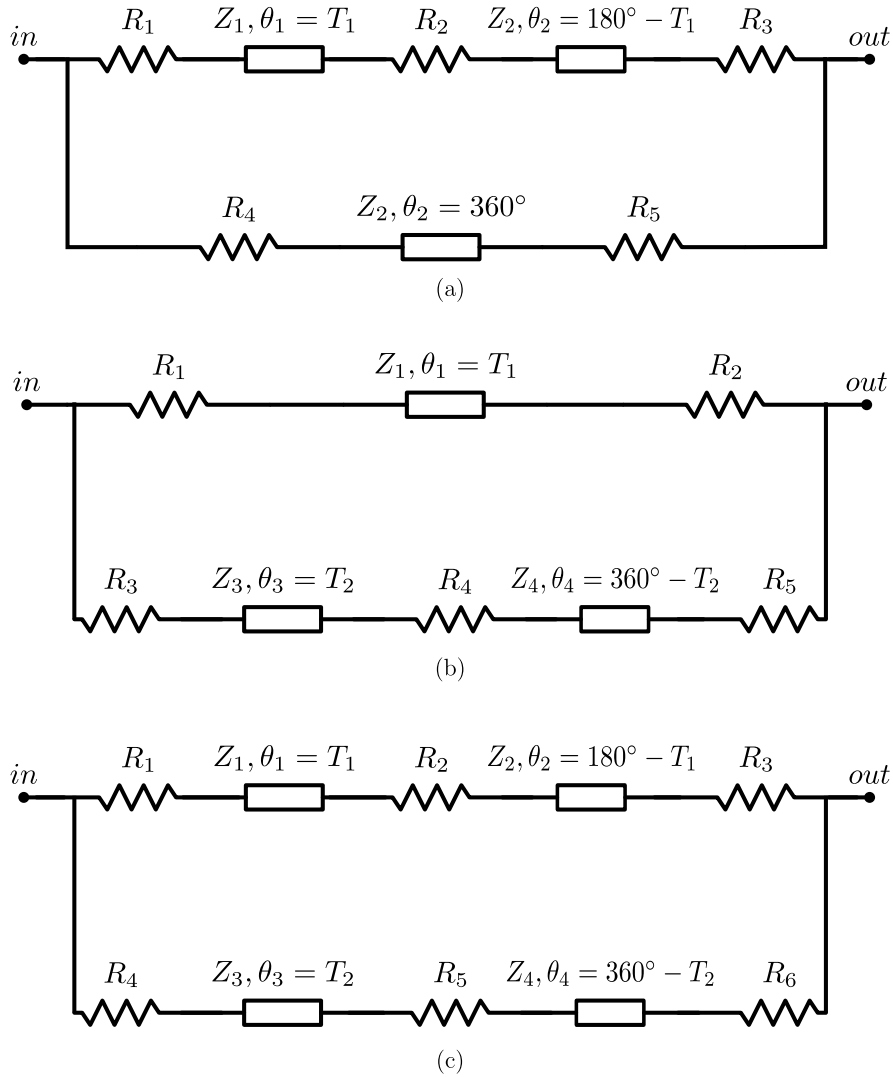


Figura 6.1: Variaciones del modelo propuesto. (a) Modelo 2. (b) Modelo 3. (c) Modelo 4.

embargo, estos resultados se escapan de los objetivos de este TFM y por ello se relatan en este capítulo. También a modo de línea futura, el sistema está preparado para poder computar el Modelo 4 y analizar los Modelos 2 y 3 para parametrizar sus respuestas.

Ya para terminar, este TFM no sólo ha cumplido su cometido en cuanto al aprendizaje de los conceptos principales de la ingeniería de microondas, sino que también ha sido un reto personal encontrar formas distintas a las tradicionales para realizar el análisis paramétrico.

Bibliografía

- [1] D. M. Pozar, *Microwave engineering*, 4th ed. JohnWiley & Sons, Inc., 2012, ch. 1, pp. 1–2.
- [2] “BOE: Orden ETU/1033/2017, de 25 de octubre, por la que se aprueba el cuadro nacional de atribuciones de frecuencias,” p. 364, 2017. [Online]. Available: <https://www.boe.es/eli/es/o/2017/10/25/etu1033>
- [3] “IEEE Standard 802.11 for Wireless LAN,” Tech. Rep., Dec. 2016. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7786995>
- [4] G. Chaudhary, Y. Jeong, and J. Lim, “Microstrip Line Negative Group Delay Filters for Microwave Circuits,” *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, vol. 62, no. 2, pp. 234–243, Feb. 2014.
- [5] A. Sommerfeld, *Lectures on theoretical physics: Optics*. Academic press, 1954, vol. 4.
- [6] L. Brillouin, *Wave propagation and group velocity*. Academic Press, 1960, vol. 8.
- [7] B. Ravelo, “Investigation on Microwave Negative Group Delay Circuit,” *Electromagnetics*, vol. 31, no. 8, pp. 537–549, Nov. 2011. [Online]. Available: <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02726343.2011.621106>
- [8] C. G. B. Garrett and D. E. McCumber, “Propagation of a Gaussian Light Pulse through an Anomalous Dispersion Medium,” *Physical Review A*, vol. 1, no. 2, pp. 305–313, Feb. 1970. [Online]. Available: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.1.305>
- [9] B. Segard and B. Macke, “Observation of negative velocity pulse propagation,” *Physics Letters A*, vol. 109, no. 5, pp. 213–216, May 1985. [Online]. Available: <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0375960185903056>
- [10] B. Macke and B. Ségard, “Propagation of light-pulses at a negative group-velocity,” *The European Physical Journal D - Atomic, Molecular and Optical Physics*, vol. 23, no. 1, pp. 125–141, Apr. 2003. [Online]. Available: <http://www.springerlink.com/Index/10.1140/epjd/e2003-00022-0>
- [11] K. T. McDonald, “Negative group velocity,” *American Journal of Physics*, vol. 69, no. 5, pp. 607–614, 2001.

-
- [12] O. F. Siddiqui, M. Mojahedi, and G. V. Eleftheriades, "Periodically loaded transmission line with effective negative refractive index and negative group velocity," *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, vol. 51, no. 10, pp. 2619–2625, Oct. 2003.
- [13] J. F. Woodley and M. Mojahedi, "Negative group velocity and group delay in left-handed media," *Phys. Rev. E*, vol. 70, no. 4, p. 046603, Oct. 2004. [Online]. Available: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.70.046603>
- [14] E. L. Bolda, R. Y. Chiao, and J. C. Garrison, "Two theorems for the group velocity in dispersive media," *Physical Review A*, vol. 48, no. 5, pp. 3890–3894, Nov. 1993. [Online]. Available: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.48.3890>
- [15] M. W. Mitchell and R. Y. Chiao, "Negative group delay and "fronts" in a causal system: An experiment with very low frequency bandpass amplifiers," *Physics Letters A*, vol. 230, no. 3-4, pp. 133–138, Jun. 1997. [Online]. Available: <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0375960197002442>
- [16] M. A. Sanchez-Soriano, J. Dura, S. Sirci, and S. Marini, "Signal-Interference-Based Structure with Negative Group Delay Properties," in *2018 48th European Microwave Conference (EuMC)*. Madrid: IEEE, Sep. 2018, pp. 1021–1024. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8541678/>
- [17] R. Y. Chiao, E. L. Bolda, J. Bowie, J. Boyce, and M. W. Mitchell, "Superluminality and amplifiers," *Progress in Crystal Growth and Characterization of Materials*, vol. 33, no. 1, pp. 319 – 325, 1996. [Online]. Available: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0960897496836631>
- [18] C. M. Wu and T. Itoh, "Maximally Flat Negative Group-Delay Circuit: A Microwave Transversal Filter Approach," *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, vol. 62, no. 6, pp. 1330–1342, Jun. 2014.
- [19] M. Kandic and G. E. Bridges, "Bilateral Gain-Compensated Negative Group Delay Circuit," *IEEE Microwave and Wireless Components Letters*, vol. 21, no. 6, pp. 308–310, Jun. 2011.
- [20] S. Lucyszyn, I. Robertson, and A. Aghvami, "Negative group delay synthesiser," *Electronics Letters*, vol. 29, no. 9, p. 798, 1993. [Online]. Available: https://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/el_19930533
- [21] S. Lucyszyn and I. D. Robertson, "Analog reflection topology building blocks for adaptive microwave signal processing applications," *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, vol. 43, no. 3, pp. 601–611, 1995.
-

-
- [22] B. Ravelo, A. Pérennec, M. Le Roy, and Y. G. Boucher, "Active microwave circuit with negative group delay," *IEEE Microwave and Wireless Components Letters*, vol. 17, no. 12, pp. 861–863, 2007.
- [23] B. Ravelo, A. Pérennec, and M. Le Roy, "Synthesis of broadband negative group delay active circuits," in *2007 IEEE/MTT-S International Microwave Symposium*. IEEE, 2007, pp. 2177–2180.
- [24] M. Kandic and G. E. Bridges, "Asymptotic limits of negative group delay in active resonator-based distributed circuits," *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers*, vol. 58, no. 8, pp. 1727–1735, 2011.
- [25] P. Mondal and M. Mandal, "Design of sharp-rejection, compact, wideband bandstop filters," *IET Microwaves, Antennas & Propagation*, vol. 2, no. 4, pp. 389–393, Jun. 2008. [Online]. Available: https://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/iet-map_20070212
- [26] R. Gomez-Garcia and J. I. Alonso, "Design of sharp-rejection and low-loss wide-band planar filters using signal-interference techniques," *IEEE microwave and wireless components letters*, vol. 15, no. 8, pp. 530–532, 2005.
- [27] M. Á. Sánchez-Soriano, G. Torregrosa-Penalva, and E. Bronchalo, "Compact wideband bandstop filter with four transmission zeros," *IEEE Microwave and Wireless Components Letters*, vol. 20, no. 6, pp. 313–315, 2010.
- [28] H. Choi, Y. Jeong, C. D. Kim, and J. S. Kenney, "Efficiency enhancement of feedforward amplifiers by employing a negative group-delay circuit," *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, vol. 58, no. 5, pp. 1116–1125, 2010.
- [29] C. Broomfield and J. Everard, "Broadband negative group delay networks for compensation of microwave oscillators and filters," *Electronics Letters*, vol. 36, no. 23, pp. 1931–1933, 2000.
- [30] G. Chaudhary, Y. Jeong, and J. Lim, "Realization of Negative Group Delay Network Using Defected Microstrip Structure," *International Journal of Antennas and Propagation*, 2014. [Online]. Available: <https://www.hindawi.com/journals/ijap/2014/836960/>
- [31] G. Chaudhary and Y. Jeong, "A design of compact wideband negative group delay network using cross coupling," *Microwave and Optical Technology Letters*, vol. 56, no. 11, pp. 2495–2497, 2014. [Online]. Available: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mop.28627>
-

-
- [32] H. Choi, S. Shim, Y. Jeong, J. Lim, C. D. Kim, S. Eom, and Y. Jung, "2.14/3.5 GHz novel dual-band negative group delay circuit design based on composite right/left handed transmission line," in *The 40th European Microwave Conference*, Sep. 2010, pp. 441–444.
- [33] B. Ravelo and S. De Blasi, "An FET-based microwave active circuit with dual-band negative group delay," *Journal of Microwaves, Optoelectronics and Electromagnetic Applications*, vol. 10, no. 2, pp. 355–366, 2011.
- [34] H. Choi, Y. Jeong, J. Lim, S. Eom, and Y. Jung, "A Novel Design for a Dual-Band Negative Group Delay Circuit," *IEEE Microwave and Wireless Components Letters*, vol. 21, no. 1, pp. 19–21, Jan. 2011.
- [35] G. Chaudhary, Y. Jeong, and J. Lim, "Miniaturized Dual-Band Negative Group Delay Circuit Using Dual-Plane Defected Structures," *IEEE Microwave and Wireless Components Letters*, vol. 24, no. 8, pp. 521–523, Aug. 2014.
- [36] G. Chaudhary, P. Kim, J. Jeong, Y. Jeong, and J. Lim, "Dual-band negative group delay circuit using defected microstrip structure," in *2015 IEEE Radio and Wireless Symposium (RWS)*, Jan. 2015, pp. 129–131.
- [37] H. Taher and R. Farrell, "Dual wide-band miniaturized negative group delay circuit using open circuit stubs," *Microwave and Optical Technology Letters*, vol. 60, no. 2, pp. 428–432, 2018. [Online]. Available: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mop.30979>
- [38] T. Shao, S. Fang, Z. Wang, and H. Liu, "A Compact Dual-Band Negative Group Delay Microwave Circuit," *Radioengineering*, vol. 27, no. 4, pp. 1070–1076, Dec. 2018.
- [39] D. M. Pozar, *Microwave engineering*, 4th ed. JohnWiley & Sons, Inc., 2012, ch. 2.
- [40] D. Grieg and H. Engelmann, "Microstrip-a new transmission technique for the kilomegacycle range," *Proceedings of the IRE*, vol. 40, no. 12, pp. 1644–1650, 1952.
- [41] R. M. Barrett, "Microwave printed circuits - the early years," *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, vol. 32, no. 9, pp. 983–990, 1984.
- [42] D. M. Pozar, *Microwave engineering*, 4th ed. JohnWiley & Sons, Inc., 2012, ch. 3.
- [43] R. E. Collin, *Foundations for microwave engineering*, 2nd ed. John Wiley & Sons, 2001, ch. 3.
-

-
- [44] I. J. Bahl, “A designer’s guide to microstrip line.” 1977.
 - [45] D. M. Pozar, *Microwave engineering*, 4th ed. JohnWiley & Sons, Inc., 2012, ch. 4.
 - [46] J. M. R. Plens, “Setfig paper,” <https://github.com/jmrplens/SetFigPaper>, 2020.
-

A. Equivalencias entre parámetros para redes de dos puertos

	S	Z	Y	$ABCD$
S_{11}	S_{11}	$\frac{(Z_{11}-Z_0)(Z_{22}+Z_0)-Z_{12}Z_{21}}{\Delta Z}$	$\frac{(Y_0-Y_{11})(Y_0+Y_{22})+Y_{12}Y_{21}}{\Delta Y}$	$\frac{A+B/Z_0-CZ_0-D}{A+B/Z_0+CZ_0+D}$
S_{12}	S_{12}	$\frac{2Z_{12}Z_0}{\Delta Z}$	$-\frac{2Y_{12}Y_0}{\Delta Y}$	$\frac{2(AD-BC)}{A+B/Z_0+CZ_0+D}$
S_{21}	S_{21}	$\frac{2Z_{21}Z_0}{\Delta Z}$	$-\frac{2Y_{21}Y_0}{\Delta Y}$	$\frac{2}{A+B/Z_0+CZ_0+D}$
S_{22}	S_{22}	$\frac{(Z_{11}+Z_0)(Z_{22}-Z_0)-Z_{12}Z_{21}}{\Delta Z}$	$\frac{(Y_0+Y_{11})(Y_0-Y_{22})+Y_{12}Y_{21}}{\Delta Y}$	$\frac{-A+B/Z_0-CZ_0+D}{A+B/Z_0+CZ_0+D}$
Z_{11}	$Z_0 \frac{(1+S_{11})(1-S_{22})+S_{12}S_{21}}{(1-S_{11})(1-S_{22})-S_{12}S_{21}}$	Z_{11}	$\frac{Y_{22}}{ Y }$	$\frac{A}{C}$
Z_{12}	$Z_0 \frac{2S_{12}}{(1-S_{11})(1-S_{22})-S_{12}S_{21}}$	Z_{12}	$-\frac{Y_{12}}{ Y }$	$\frac{AD-BC}{C}$
Z_{21}	$Z_0 \frac{2S_{21}}{(1-S_{11})(1-S_{22})-S_{12}S_{21}}$	Z_{21}	$-\frac{Y_{21}}{ Y }$	$\frac{1}{C}$
Z_{22}	$Z_0 \frac{(1-S_{11})(1+S_{22})+S_{12}S_{21}}{(1-S_{11})(1-S_{22})-S_{12}S_{21}}$	Z_{22}	$\frac{Y_{11}}{ Y }$	$\frac{D}{C}$
Y_{11}	$Y_0 \frac{(1-S_{11})(1+S_{22})+S_{12}S_{21}}{(1+S_{11})(1+S_{22})-S_{12}S_{21}}$	$\frac{Z_{22}}{ Z }$	Y_{11}	$\frac{D}{B}$
Y_{12}	$Y_0 \frac{-2S_{12}}{(1+S_{11})(1+S_{22})-S_{12}S_{21}}$	$-\frac{Z_{12}}{ Z }$	Y_{12}	$\frac{BC-AD}{B}$
Y_{21}	$Y_0 \frac{-2S_{21}}{(1+S_{11})(1+S_{22})-S_{12}S_{21}}$	$-\frac{Z_{21}}{ Z }$	Y_{21}	$-\frac{1}{B}$
Y_{22}	$Y_0 \frac{(1+S_{11})(1-S_{22})+S_{12}S_{21}}{(1+S_{11})(1-S_{22})-S_{12}S_{21}}$	$\frac{Z_{11}}{ Z }$	Y_{22}	$\frac{A}{B}$
A	$\frac{(1+S_{11})(1-S_{22})+S_{12}S_{21}}{2S_{21}}$	$\frac{Z_{11}}{Z_{21}}$	$-\frac{Y_{22}}{Y_{21}}$	A
B	$Z_0 \frac{(1+S_{11})(1+S_{22})-S_{12}S_{21}}{2S_{21}}$	$\frac{ Z }{Z_{21}}$	$-\frac{1}{Y_{21}}$	B
C	$\frac{1}{Z_0} \frac{(1-S_{11})(1-S_{22})-S_{12}S_{21}}{2S_{21}}$	$\frac{1}{Z_{21}}$	$-\frac{ Y }{Y_{21}}$	C
D	$\frac{(1-S_{11})(1+S_{22})+S_{12}S_{21}}{2S_{21}}$	$\frac{Z_{22}}{Z_{21}}$	$-\frac{Y_{11}}{Y_{21}}$	D
$ Z = Z_{11}Z_{22}; \quad \Delta Y = (Y_{11} + Y_0)(Y_{22} + Y_0) - Y_{12}Y_{21}; \quad \Delta Z = (Z_{11} + Z_0)(Z_{22} + Z_0) - Z_{12}Z_{21}; \quad Y_0 = 1/Z_0$				

Tabla A.1: Conversión entre parámetros de redes de dos puertos

B. Tutorial ADS

ADS es una herramienta de diseño y simulación de circuitos electrónicos desarrollada por Keysight¹. Mediante este software es posible simular la respuesta de circuitos electrónicos para frecuencias de microondas. A continuación se muestra cómo generar los circuitos de este TFM.

B.1. Creación de un circuito con ADS

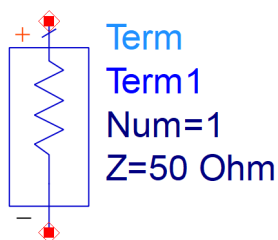
Tras configurar el espacio de trabajo, podemos crear un circuito nuevo (File →New →Schematic). Los componentes a utilizar para la creación de los circuitos de este TFM son:

¹<https://www.keysight.com/>

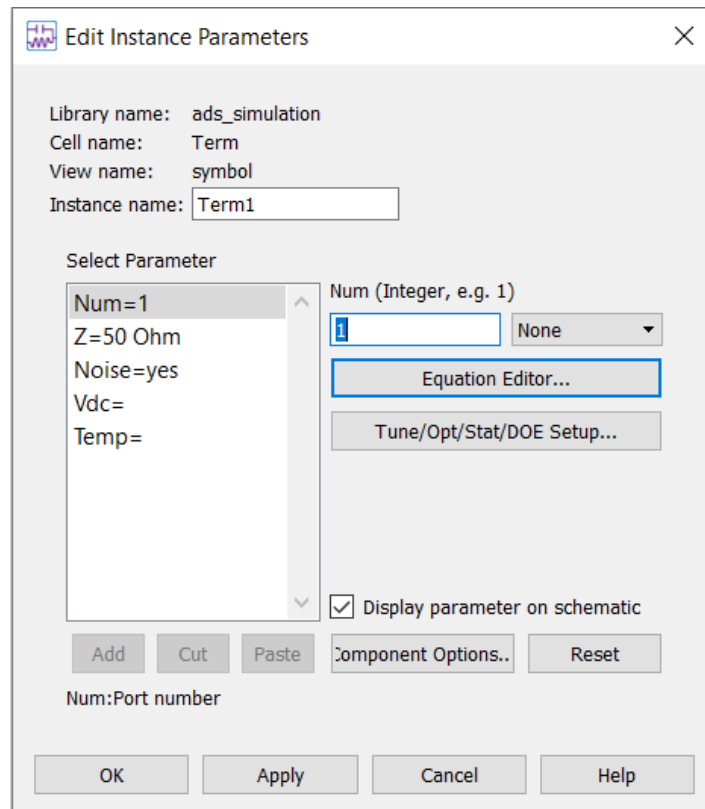
B.1.1. Componentes genéricos

B.1.1.1. Term

El componente **Term** simboliza la impedancia característica de un puerto para simulaciones de parámetros S. En la Figura B.1 se muestra el símbolo y la configuración de sus propiedades. Este componente se encuentra en la paleta Simulation-S_Parameters.



(a) Símbolo

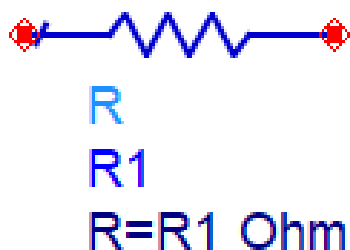


(b) Propiedades

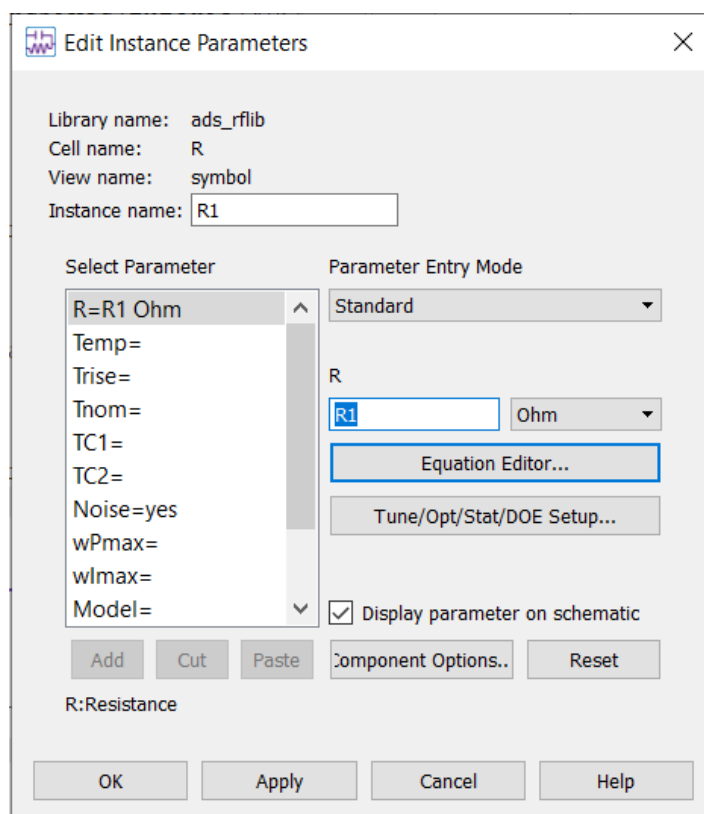
Figura B.1: Componente Term

B.1.1.2. Resistencia

El componente **R** simboliza una resistencia. En la Figura B.2 se muestra el símbolo y la configuración de sus propiedades. Este componente se encuentra en la paleta Lumped-Components. Cabe destacar que en las propiedades (Figure B.2b) se indica como valor de resistencia el nombre de una variable (R1), que comentaremos más adelante



(a) Símbolo



(b) Propiedades

Figura B.2: Componente Resistencia

B.1.1.3. Variable

El componente **VAR** simboliza una resistencia. En la Figura B.3 se muestra el símbolo y la configuración de sus propiedades. Este componente se encuentra en la paleta Data Items. La configuración de Tuning y de Optimización no son obligatorias si no se van a realizar este tipo de simulaciones.

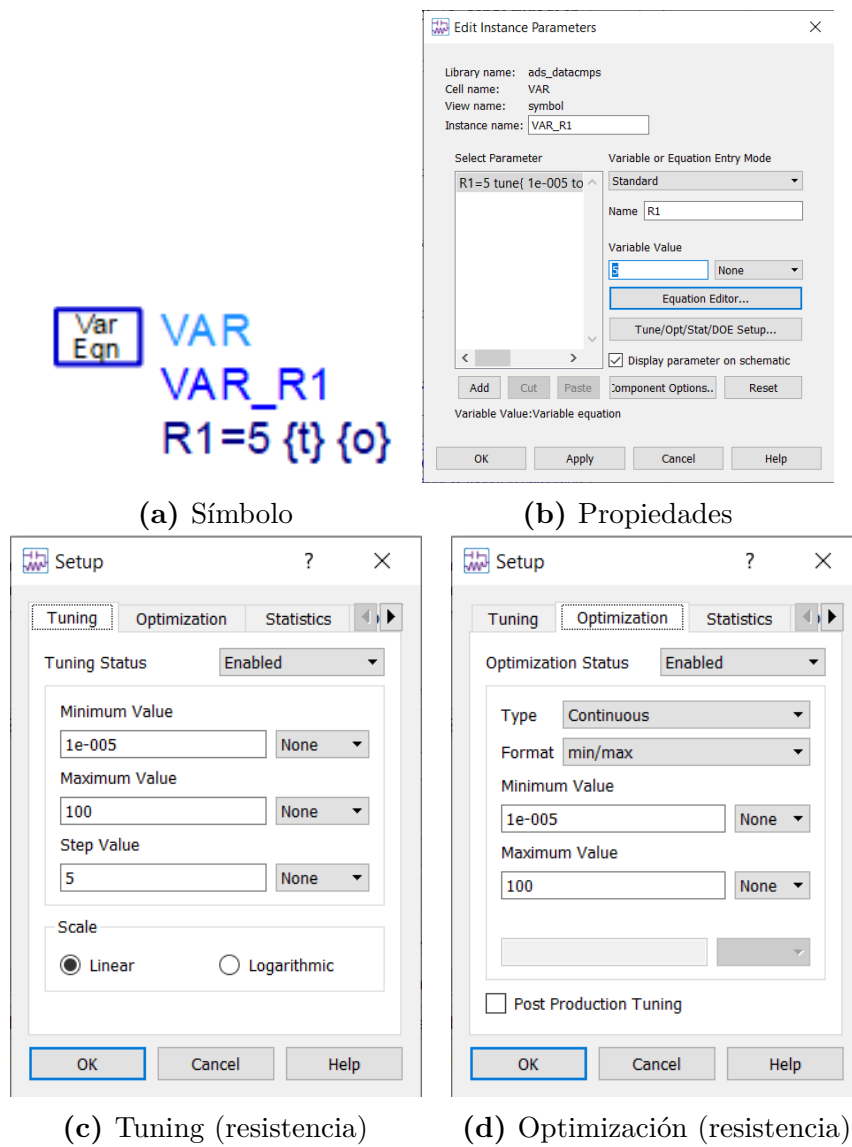


Figura B.3: Componente Variable

B.1.1.4. Línea de transmisión ideal

El componente **TLIN** simboliza una línea de transmisión ideal. En la Figura B.4 se muestra el símbolo y la configuración de sus propiedades. Este componente se encuentra en la paleta TLine-Ideal. En las Figuras B.4c y B.4d se muestran las configuraciones adecuadas para una variable asociada si se desea simular en modo Tuning u Optimización.

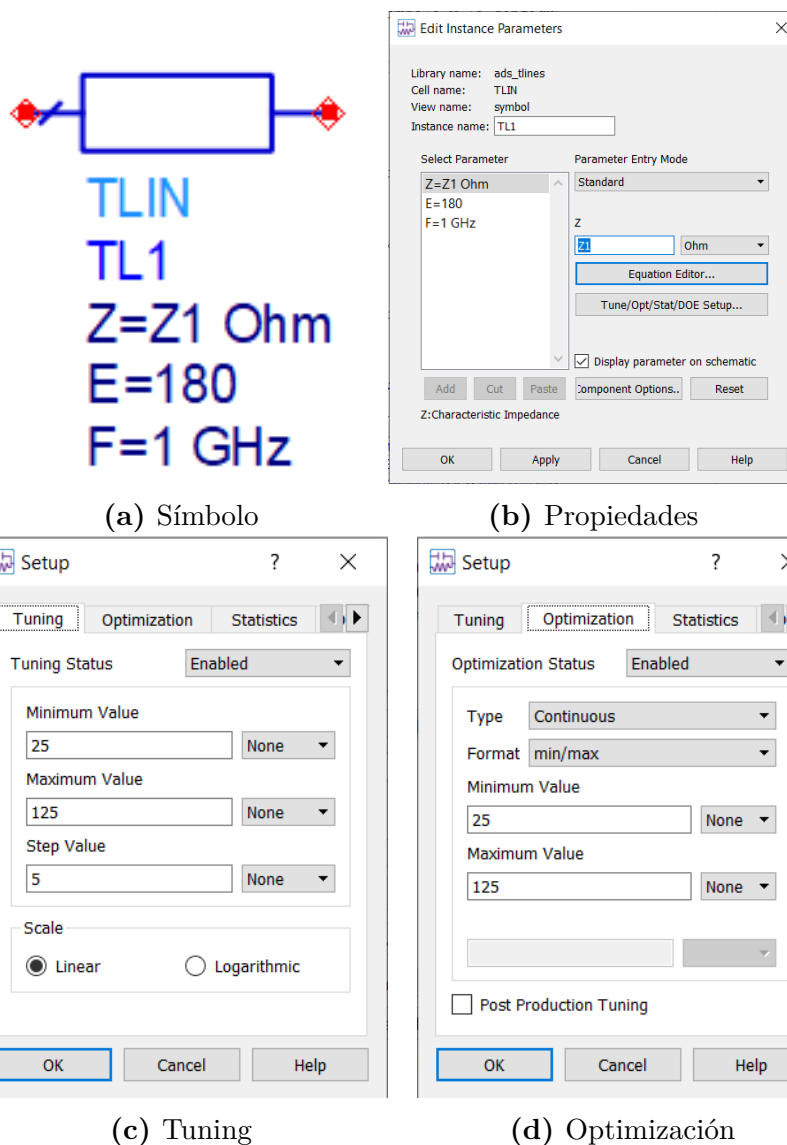
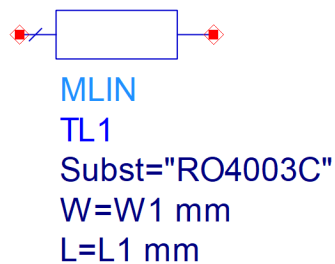


Figura B.4: Componente Variable

B.1.1.5. Línea de transmisión Microstrip

El componente **MLIN** simboliza una línea microstrip. En la Figura B.5 se muestra el símbolo y la configuración de sus propiedades. Este componente se encuentra en la paleta TLines-Microstrip. A diferencia de la línea ideal, en este caso se configuran las dimensiones físicas W y L, así como el sustrato.



(a) Símbolo

Edit Instance Parameters

Library name: ads_tlines
Cell name: MLIN
View name: symbol
Instance name: TL1

Select Parameter: Subst="RO4003C", W=W1 mm, L=L1 mm, Wall1=1.0E+30 mil, Wall2=1.0E+30 mil, Temp=, Mod=Kirschning

Parameter Entry Mode: String and Reference

Subst: RO4003C

☒ Display parameter on schematic

Buttons: Add, Cut, Paste, Component Options..., Reset

Subst: Substrate instance name

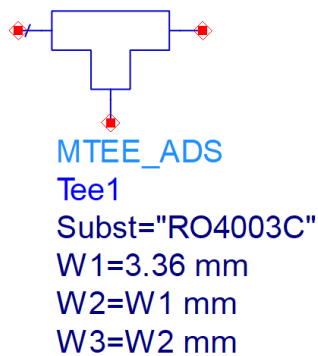
Buttons: OK, Apply, Cancel, Help

(b) Propiedades

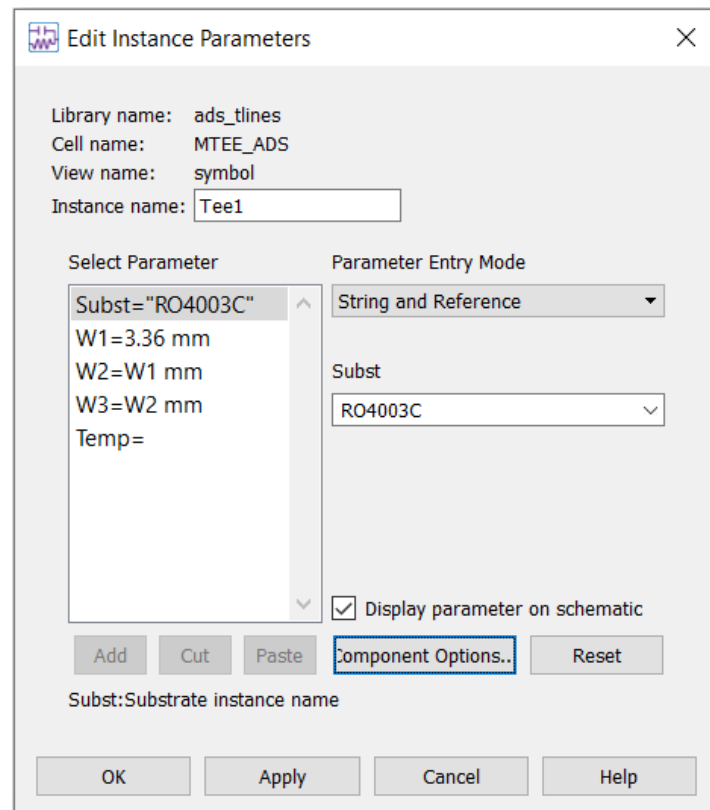
Figura B.5: Componente para conexión en 'T'

B.1.1.6. Conexión microstrip en 'T'

El componente **MTEE** simboliza una conexión en 'T'. En la Figura B.6 se muestra el símbolo y la configuración de sus propiedades. Este componente se encuentra en la paleta TLines-Microstrip.



(a) Símbolo



(b) Propiedades

Figura B.6: Componente conexión en 'T'

B.1.1.7. Substrato de componentes Microstrip

El componente **MSUB** define las propiedades del sustrato utilizado para los componentes microstrip como los anteriores. En la Figura B.7 se muestra el símbolo y la configuración de sus propiedades. Este componente se encuentra en la paleta TLines-Microstrip.

MSub

MSUB
RO4003C
H=1.524 mm
Er=3.55
Mur=1
Cond=5.7e7
Hu=3.9e+034 mil
T=0.032 mil
TanD=0.0027
Rough=0 mil
Bbase=
Dpeaks=

Library name: ads_tlines
Cell name: MSUB
View name: symbol
Instance name: RO4003C

Select Parameter: H=1.524 mm, Er=3.55, Mur=1, Cond=5.7e7, Hu=1e33 mm, T=0.030 mil, TanD=0.002, Rough=0 mil, Cond1="cond:drawin"

Parameter Entry Mode: Standard

H: 1.524 mm

Equation Editor...
Tune/Opt/Stat/DOE Setup...

☒ Display parameter on schematic

Add Cut Paste Component Options.. Reset

H: Substrate thickness

OK Apply Cancel Help

(a) Símbolo

(b) Propiedades

Figura B.7: Componente Substrato Microstrip

B.1.2. Componentes para Simulación

Los siguientes componentes son necesarios para simular el circuito, por lo que son más bien parámetros de configuración que componentes al uso.

B.1.2.1. Parámetros S

Necesario para indicar los parámetros a computar cuando se lance la simulación. En la Figura B.8 se muestra la configuración necesaria para poder computar también el retardo de grupo.

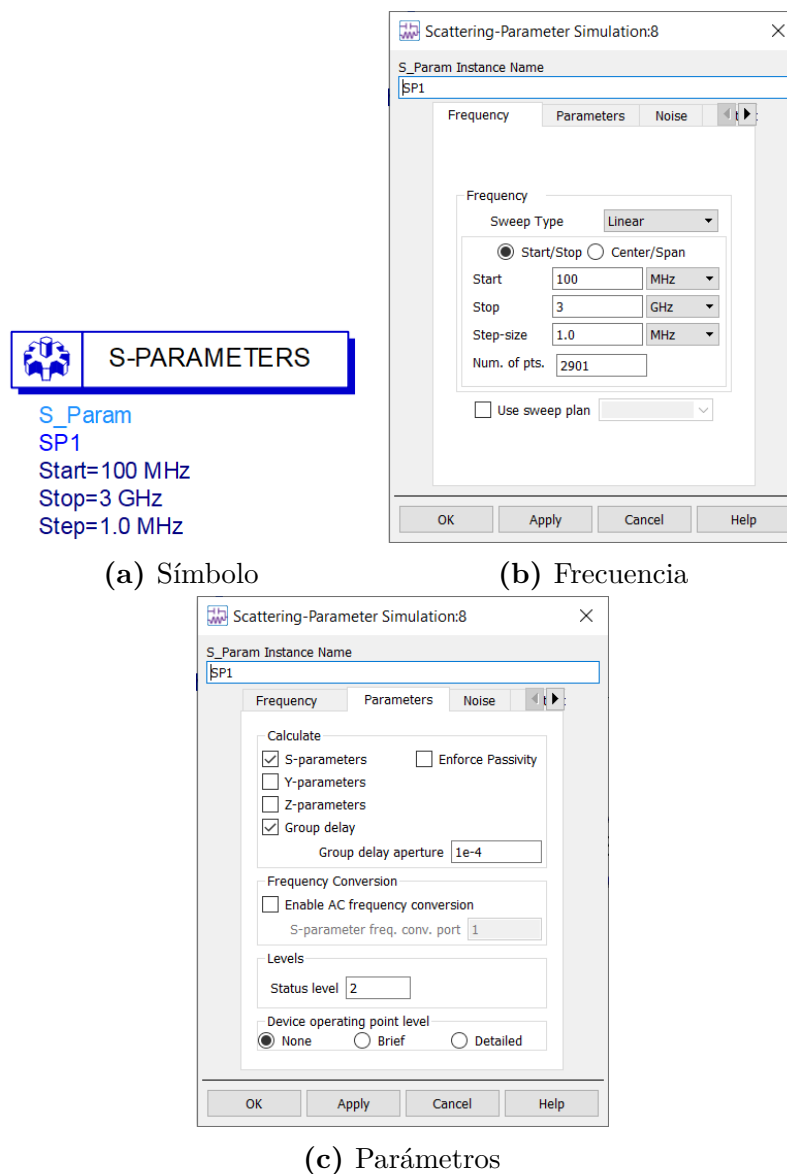


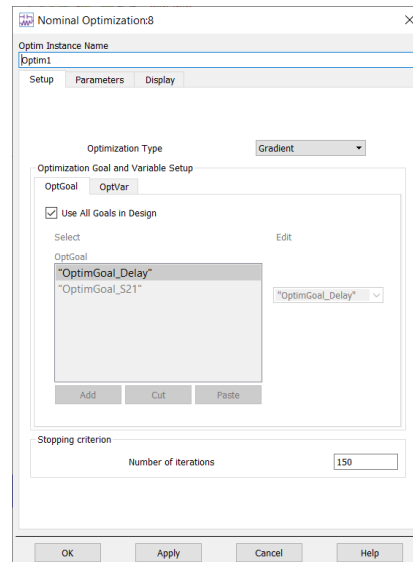
Figura B.8: Componente Parámetros S

B.1.2.2. Optimización

Este componente es necesario para indicar al software cómo debe realizar la optimización para alcanzar los objetivos. En la Figura B.8 se muestra la configuración necesaria para poder computar este tipo de simulación.

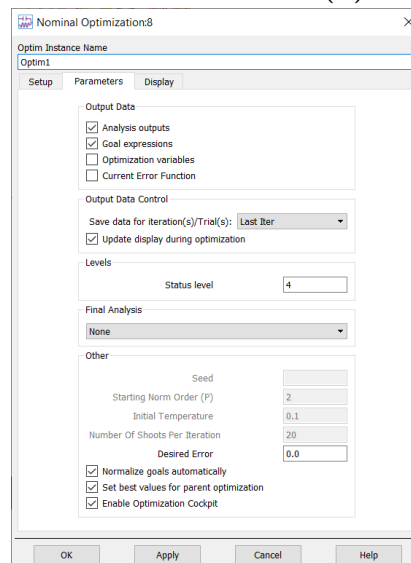


Optim
Optim 1
Optim Type=Gradient
MaxIters=150
DesiredError=0.0
StatusLevel=4
FinalAnalysis="None"
NormalizeGoals=yes
SetBestValues=yes
SaveSolns=yes
SaveGoals=yes
SaveOptimVars=no
UpdateDataset=yes
SaveNominal=no
SaveAllIterations=no
OptVar[1]="R4"
OptVar[2]="R3"
OptVar[3]="Z2"
OptVar[4]="Z1"
UseAllGoals=yes
SaveCurrentEF=no
EnableCockpit=yes
SaveAllTrials=no



(a) Símbolo

(b) Configuración

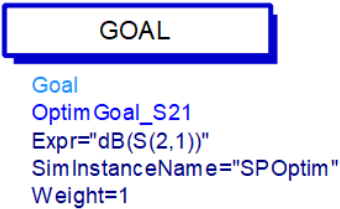


(c) Parámetros

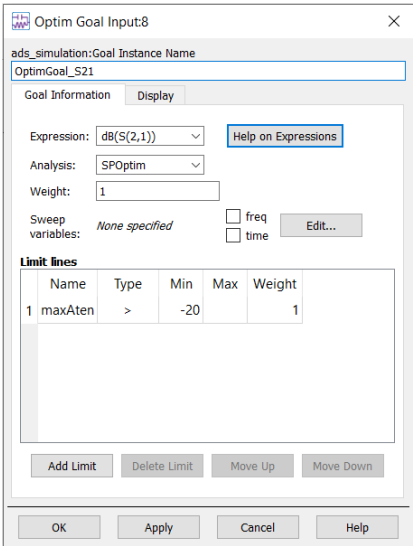
Figura B.9: Componente Optimización

B.1.2.3. Objetivo

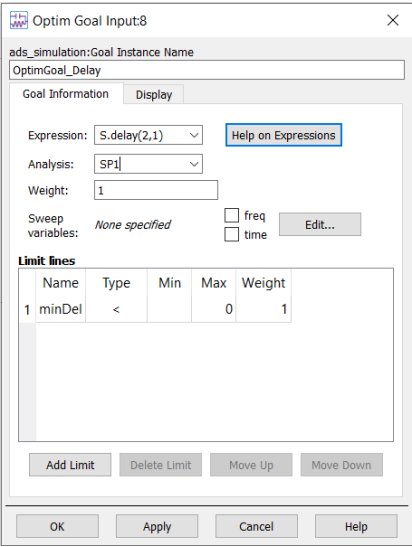
Este componente es necesario para indicar cual es el objetivo de la optimización. En la Figura B.10 se muestra la configuración necesaria para poder computar este tipo de simulación.



(a) Símbolo



(b) Objetivos Atenuación



(c) Objetivos NGD

Figura B.10: Componente Objetivos

B.1.3. Simulación y Visualización

Tras la construcción del circuito deseado, existen principalmente tres formas de lanzar la simulación: Simulación (estática), Tuning y Optimización. Todas ellas se encuentran en el menú *Simulate* de la barra de tareas. La diferencia entre la Simulación estática y una simulación con Tuning está en el valor que adquieren las variables. Mientras que para la primera se realiza una simulación con los valores que tengan en dicho momento, si se selecciona la segunda al lanzar la simulación se abre una nueva ventana (Figura B.11) que permite modificarlos. Esto es especialmente interesante de cara a realizar ajustes rápidos ya que se vuelve a calcular la respuesta al circuito tras cada modificación.

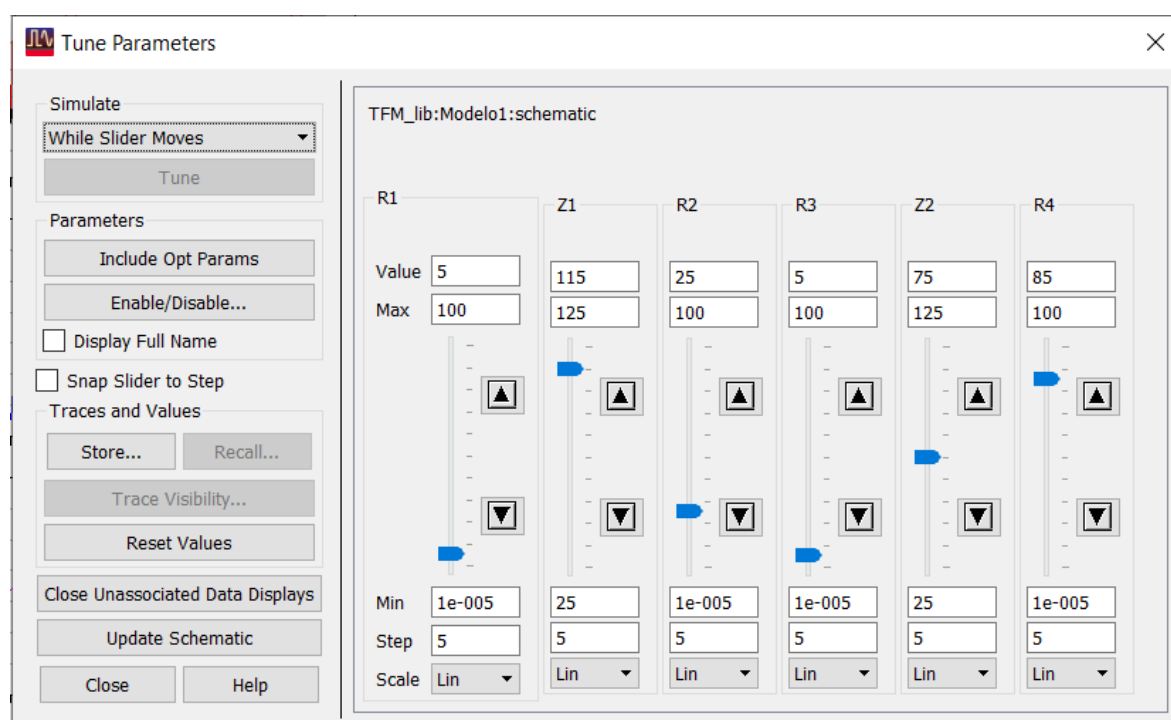


Figura B.11: Ventana de ajuste

Si se opta por optimizar las variables del circuito, tras realizar los cálculos pertinentes el programa ofrecerá la posibilidad de aplicar dichos valores a las variables.

En cualquiera de los casos, tras la simulación se abrirá una nueva ventana donde será posible incluir las gráficas deseadas para representar los parámetros S o el retardo de grupo, entre otros. Existen multitud de opciones para representar los datos, pero puesto que principalmente se desean comparar los parámetros S_{21} , S_{11} y S_{22} y el retardo de grupo negativo, en la Figura B.12 se muestra un tipo de representación apilada, con marcadores para las frecuencias de interés. Por otro lado, en la Figura B.13 se muestran las opciones a configurar para mostrar las gráficas apiladas.

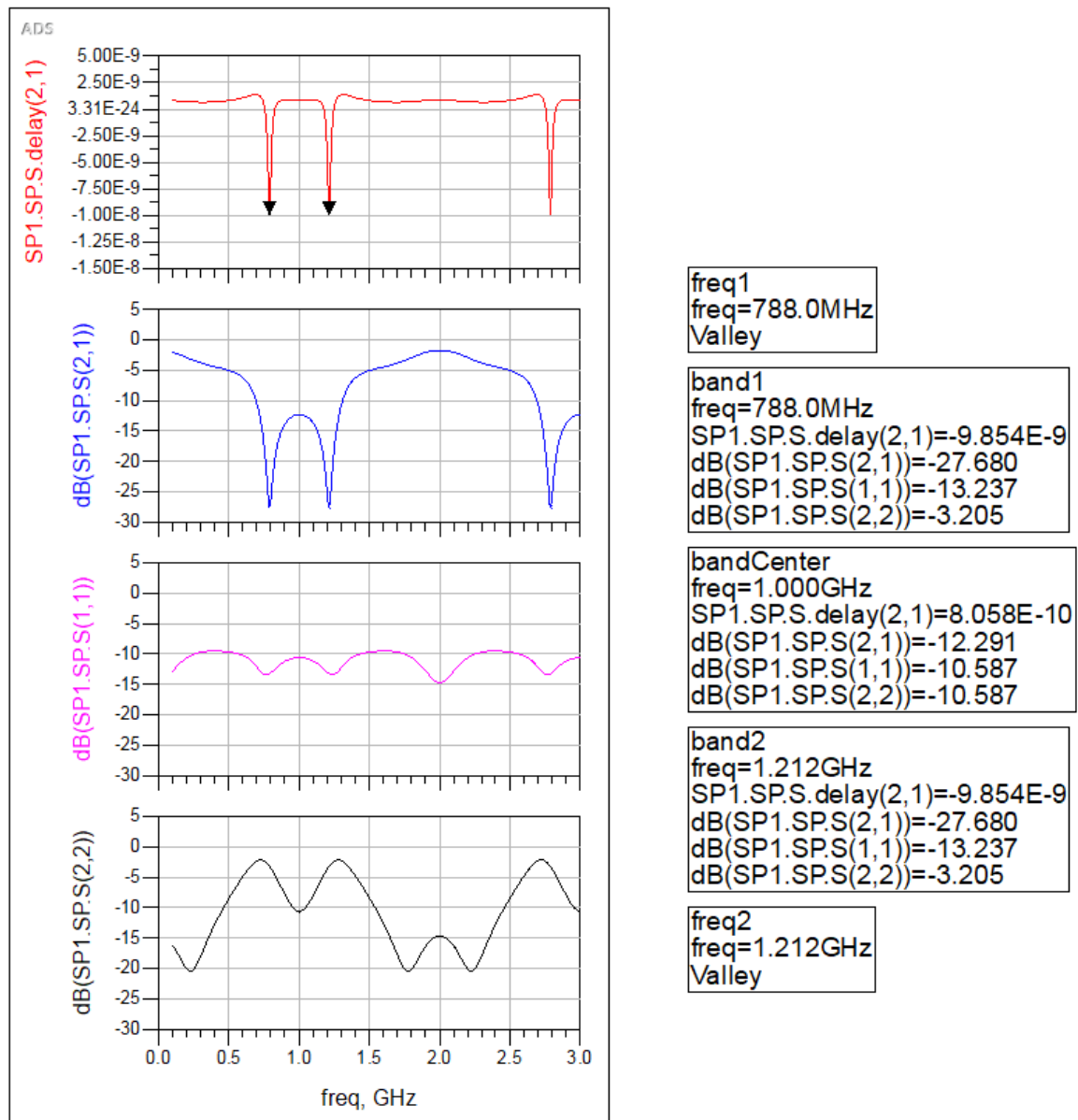


Figura B.12: Representación gráfica de las variables

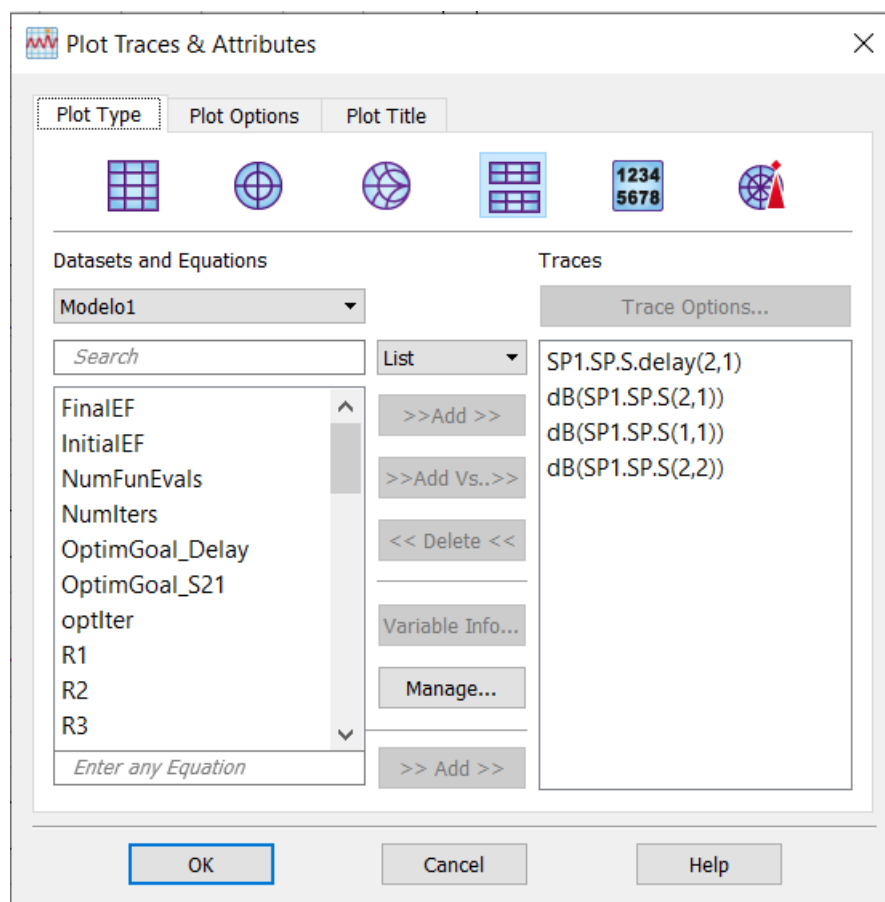


Figura B.13: Opciones para la representación

C. Tutorial Sonnet

Sonnet es una herramienta de diseño y simulación de circuitos electrónicos al igual que ADS. Sin embargo, mientras que en ADS se diseña conectando componentes, en Sonnet se diseña dibujando directamente las dimensiones físicas y teniendo total control sobre las conexiones entre líneas. Además, Sonnet realiza una simulación en onda completa, es decir internamente resuelve las ecuaciones de Maxwell calculando los niveles de voltaje e intensidad en cada punto del dispositivo.

En este Anexo se expone de forma secuencial y mediante las capturas de la interfaz de Sonnet los pasos a seguir para diseñar y simular un circuito.

C.1. Interfaz de Sonnet

Al iniciar Sonnet aparece una pequeña ventana a modo de barra de tareas (Figura C.1) donde se da acceso rápido a las cinco herramientas principales de Sonnet:

- **Edit Project:** Creación y modificación de la geometría del circuito.
- **Analyze Project:** Lanzamiento, cola, errores y estado de la simulación o simulaciones.
- **View Response:** Visualización de la respuesta del circuito (parámetros S, Y, Z, retardo de grupo...)
- **View Current:** Visualización de las corrientes sobre el diseño geométrico del circuito en 3D.
- **View Far Field:** Visualización del campo lejano. Útil en contextos donde se analiza la directividad de una antena.

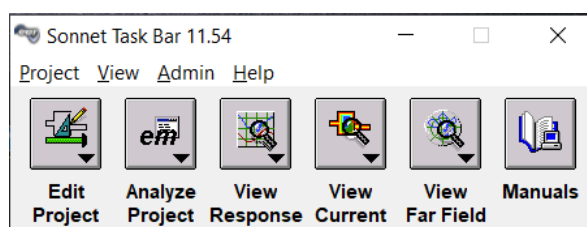


Figura C.1: Ventana principal de Sonnet

C.2. Creación de un prototipo con Sonnet

Para generar un nuevo proyecto se debe seleccionar **New Geometry**, dentro de la opción **Project** de la barra de tareas superior o del botón **Edit Project**. Se generará entonces una ventana como la de la Figura C.2.

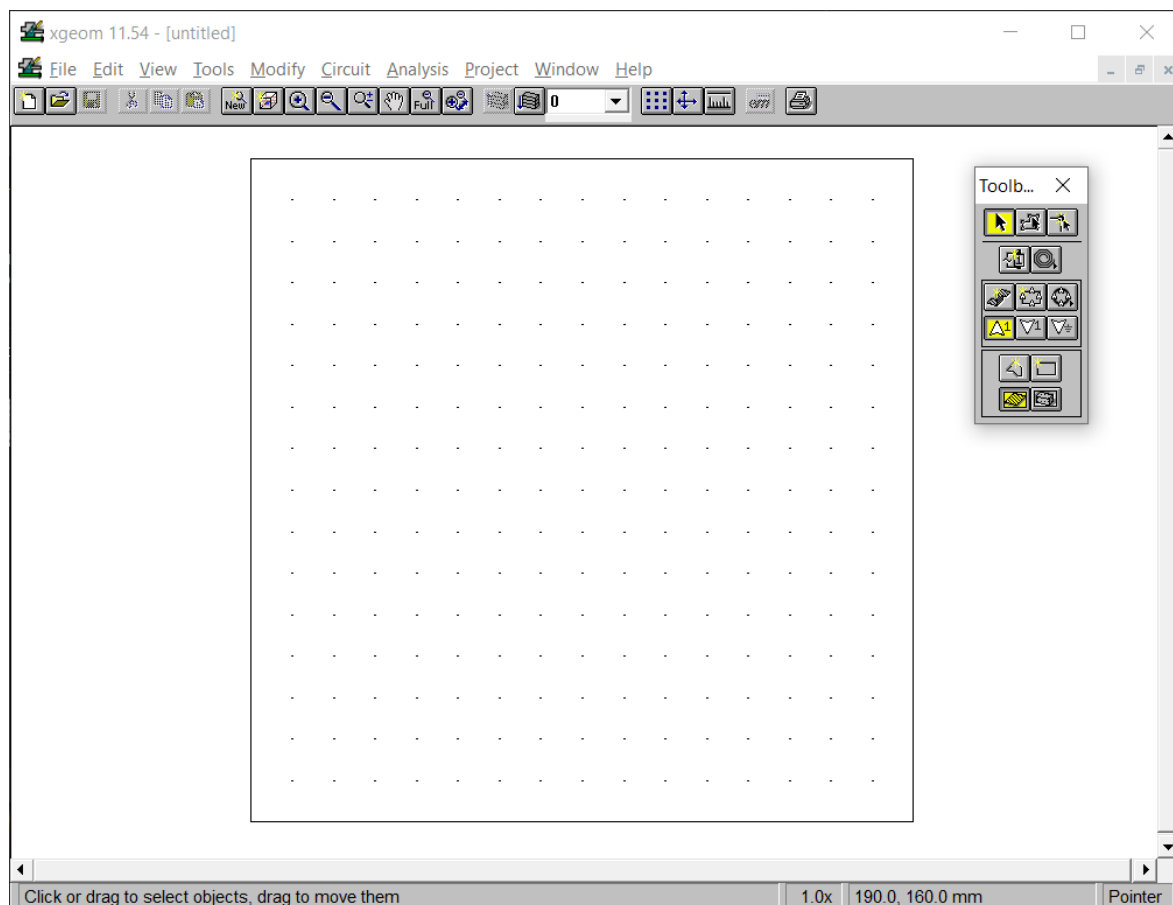


Figura C.2: Editor de Sonnet

C.2.1. Configuración del prototipo

Antes de comenzar a dibujar la geometría de las líneas del prototipo es necesario configurar el proyecto. En el menú **Circuit** de la barra de tareas del Editor (Figura C.2) encontramos diversas opciones que deben configurarse como se explica a continuación.

C.2.1.1. Units

Seleccionar la unidad deseada para cada magnitud. En este TFM se trabaja con la configuración mostrada en la Figura C.3.

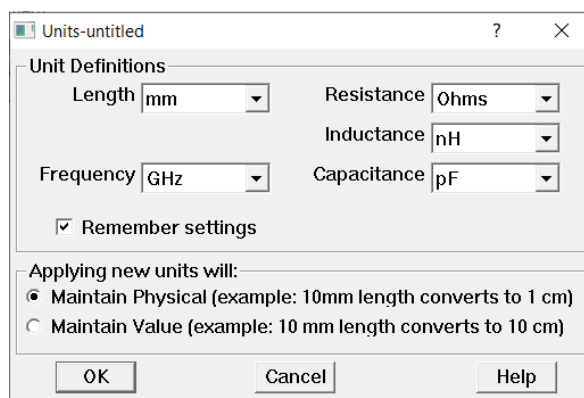


Figura C.3: Configuración de las unidades

C.2.1.2. Box

Configuración de la precisión geométrica indicando el tamaño de celda y los metales superior e inferior de la caja. El metal superior también es posible definirlo como espacio libre si se producen resonancias que interfieran con el prototipo. En este TFM se trabaja con la configuración mostrada en la Figura C.4.

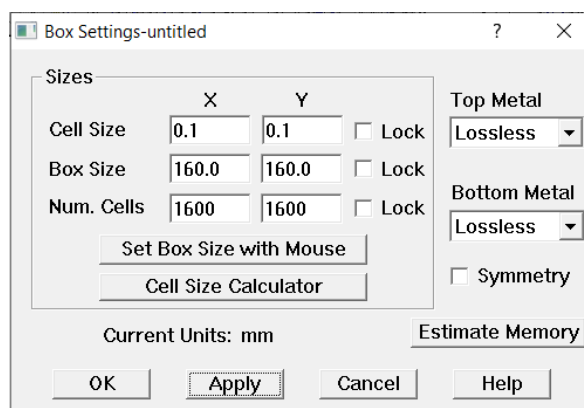
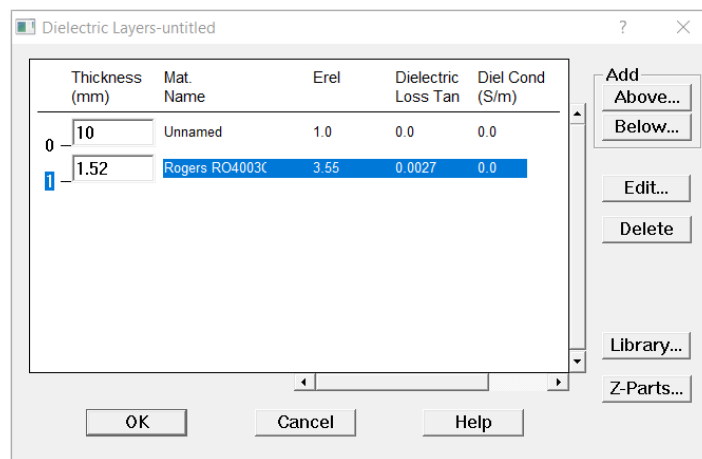


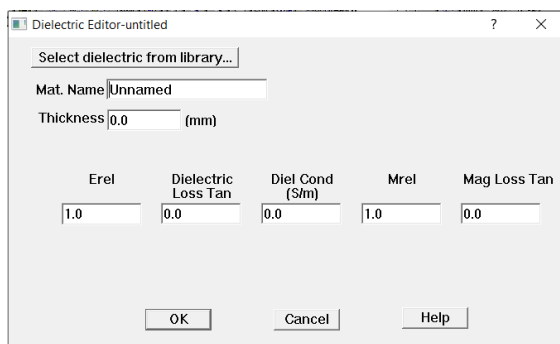
Figura C.4: Configuración de la caja

C.2.1.3. Dielectric Layers

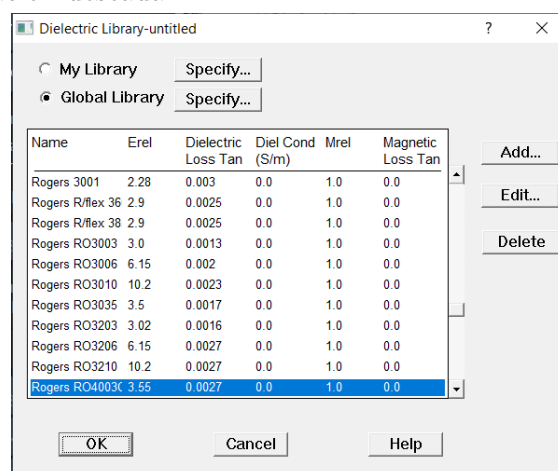
Configuración de la precisión geométrica indicando el tamaño de celda y los metales superior e inferior de la caja. El metal superior también es posible definirlo como espacio libre si se producen resonancias que interfieran con el prototipo. En este TFM se trabaja con la configuración mostrada en la Figura C.5.



(a) Configuración deseada



(b) Editor de capa dieléctrica

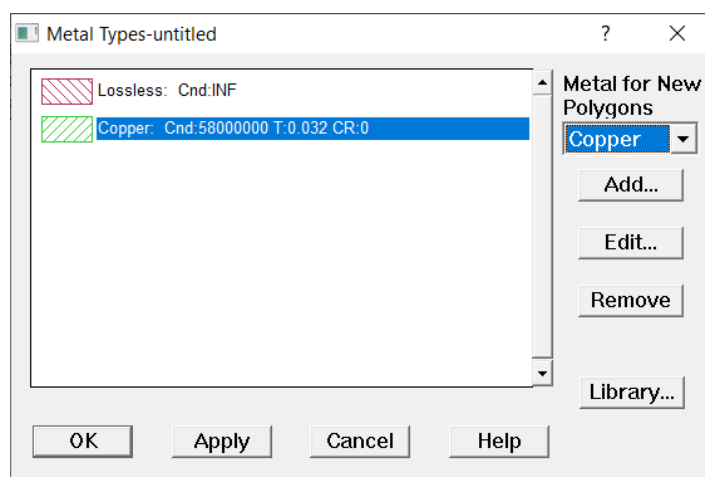


(c) Librería de capas dieléctricas

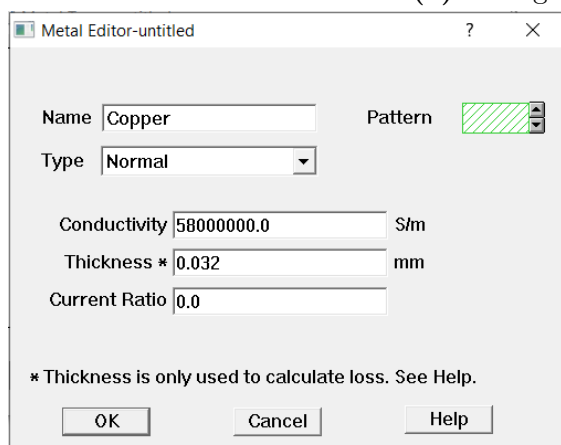
Figura C.5: Configuración de las capas dieléctricas

C.2.1.4. Metal Types

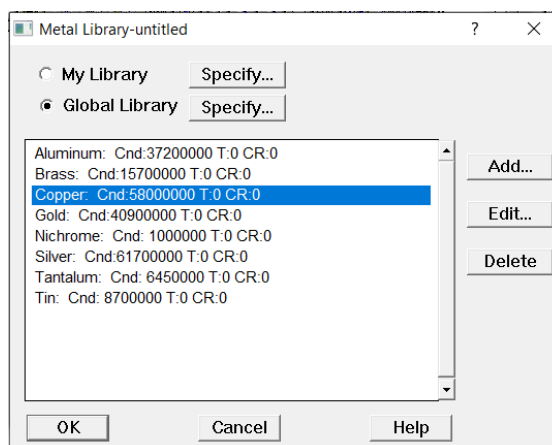
Configuración de los metales conductores del prototipo. En este TFM se trabaja con la configuración mostrada en la Figura C.6.



(a) Configuración deseada



(b) Editor de metales



(c) Librería de metales

Figura C.6: Configuración de los metales conductores

C.2.2. Diseño geométrico del prototipo

C.2.2.1. Añadir una tira microstrip

Para comenzar a diseñar el dispositivo partimos del Editor de Sonnet (Figura C.2). Las tiras microstrip son polígonos geométricos de determinadas dimensiones, por lo que

para generar uno, seleccionamos la opción **Draw Rectangle**, dentro del menú **Add Metalization** que se encuentra en la opción **Tools** de la barra de tareas superior. Con esta opción es posible dibujar el rectángulo, sin embargo también podemos generar un rectángulo a partir de sus dimensiones con la opción **Rectangle** del menú **Add Metalization**. En ambos casos, el resultado será similar al de la Figura C.7. Cabe destacar que el color del polígono añadido representa el tipo de metal que ya se ha configurado con anterioridad en el apartado C.2.1.4: Metal Types.

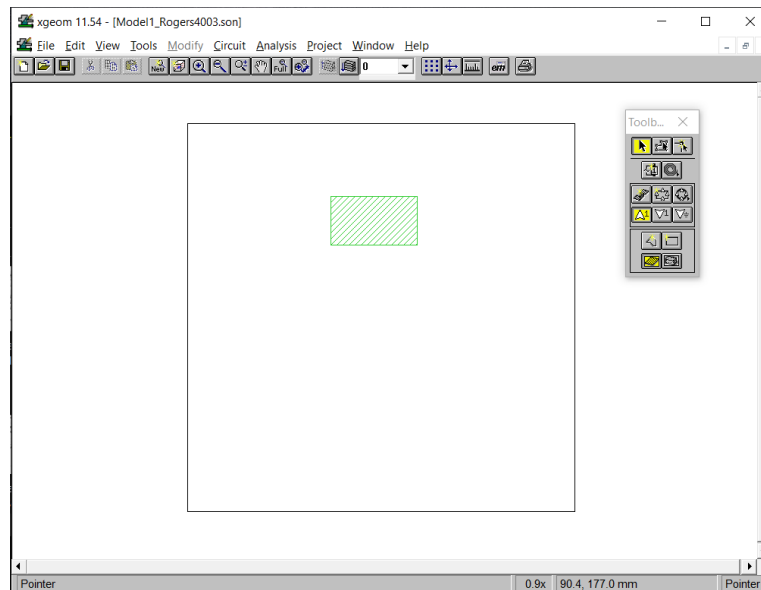


Figura C.7: Línea de transmisión generada mediante un rectángulo

C.2.2.2. Parametrizar las dimensiones de las tiras

Si únicamente se desea diseñar un prototipo no es necesario parametrizar las dimensiones de las tiras ya que no se realizarán muchos cambios más allá de pequeños ajustes para optimizar la respuesta del circuito. Sin embargo, si el objetivo es diseñar diversos prototipos, merece la pena parametrizar las dimensiones para poder variar todo el diseño únicamente introduciendo las nuevas medidas.

La versión de Sonnet utilizada no implementa la opción de definir dimensiones en base a otras mediante una fórmula, pero sí que permite nombrar dimensiones de diversos polígonos con el mismo nombre para que varíen de igual forma y definir puntos de anclaje que serán fijos aunque varíe dicha dimensión.

Definir todo un circuito parametrizándolo geométricamente puede ser costoso con esta versión de Sonnet ya que no es demasiado intuitiva. A continuación se explica de forma secuencial:

1. Seleccionamos **Tools** → **Add Parameter** → **Add Anchored**.

2. Seleccionamos 3 nodos (Figura C.8) teniendo en cuenta que:
 - El primer nodo (cuadrado hueco) será el punto de anclaje.
 - El segundo nodo marca la dimensión a parametrizar.
 - El tercer nodo es un nodo relativo (cuadrado sólido), sirve para indicar que también variará su posición junto con el segundo.
3. Pulsamos Enter y aparecerá un diálogo donde indicamos el nombre de dicho parámetro y, si se desea, variar la dimensión (Figura C.9).
4. Es posible modificar los nodos seleccionando **Modify Point Set** del menú contextual desplegado al pulsar sobre el parámetro creado con el botón derecho.
5. Para añadir nuevos nodos relativos (como el tercero) debemos mantener pulsada la tecla Control mientras seleccionamos estos nuevos nodos.

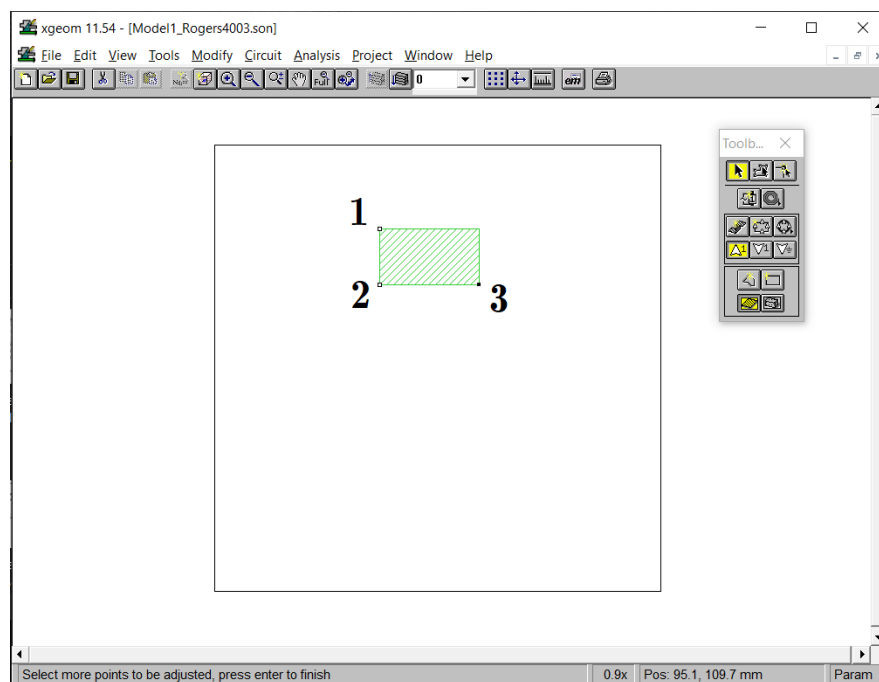


Figura C.8: Selección de nodos a parametrizar mediante el método de anclado

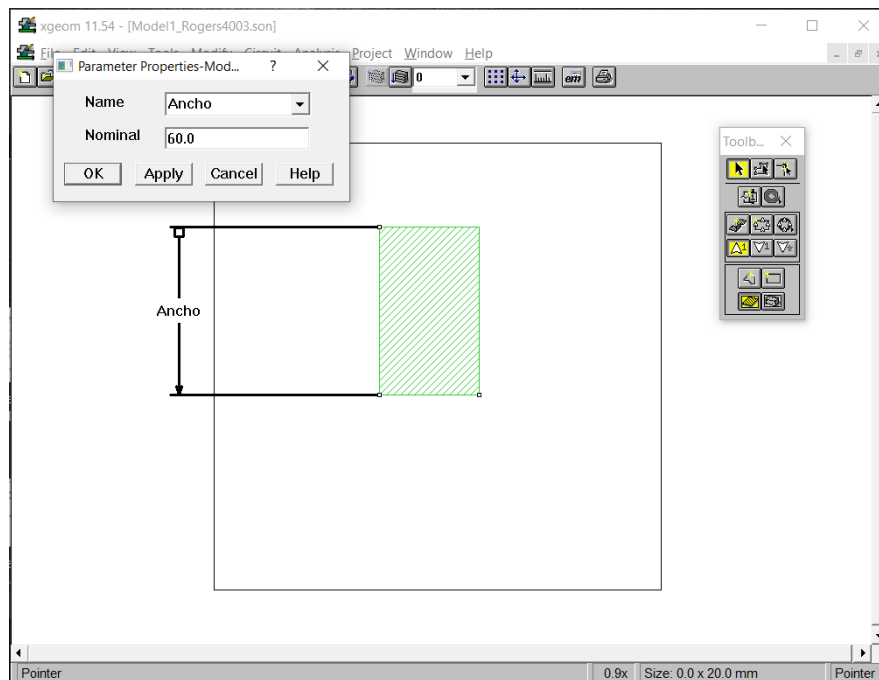


Figura C.9: Diálogo de creación el parámetro

También es interesante la parametrización simétrica, ya que no ancla un nodo a un punto fijo, sino que ancla el punto medio del polígono. La creación de dichos parámetros es algo diferente a la anterior:

1. Seleccionamos **Tools** → **Add Parameter** → **Add Symetric**.
2. Seleccionamos 4 nodos (Figura C.10) teniendo en cuenta que:
 - El primer y segundo nodo serán relativos entre sí y se desplazarán por igual.
 - Tras seleccionarlos debemos pulsar Enter para indicar que cambiamos de posición.
 - El tercer y cuarto nodo también serán relativos entre sí.
 - Cada grupo de nodos se desplazará de forma simétrica respecto al centro de la figura.
3. Pulsamos enter y aparecerá de nuevo el diálogo de propiedades(Figura C.11).
4. Es posible modificar los grupos de nodos seleccionando **Modify Left Point Set** o **Modify Right Point Set** del menú contextual.
5. Para añadir nuevos nodos relativos al grupo debemos mantener pulsada la tecla Control mientras seleccionamos estos nuevos nodos.

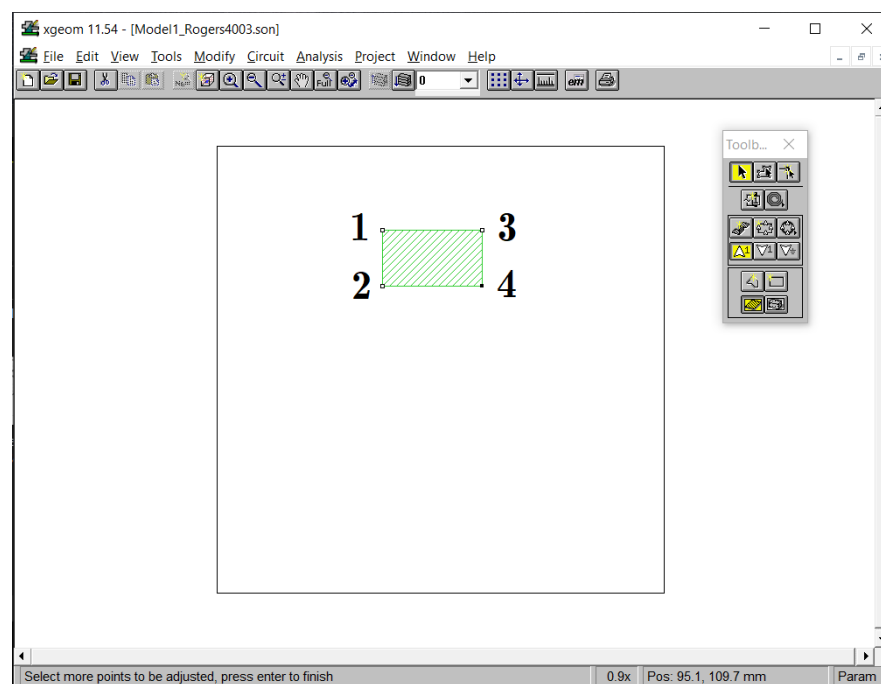


Figura C.10: Selección de nodos a parametrizar mediante el método simétrico

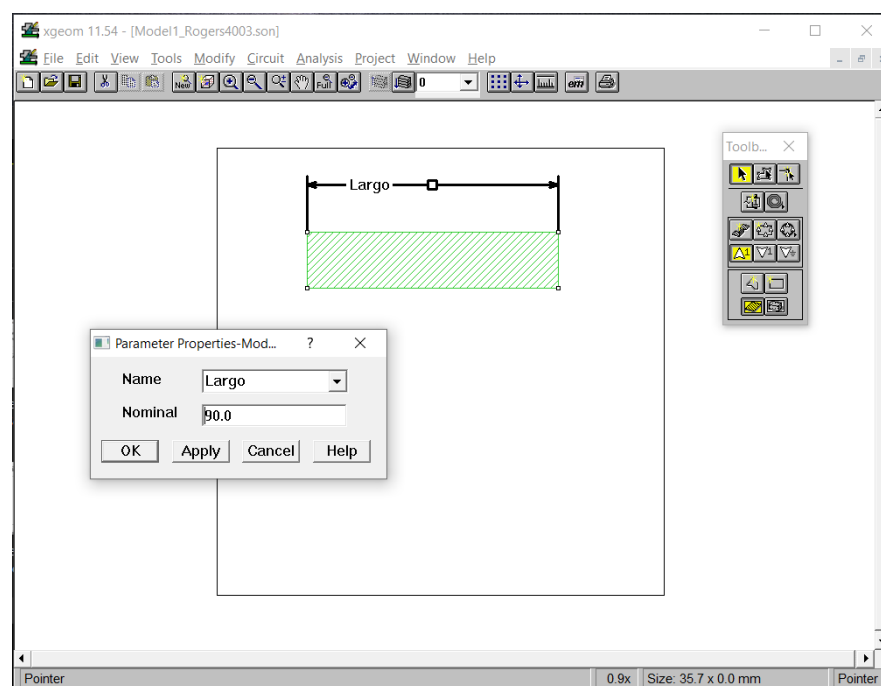


Figura C.11: Diálogo de creación el parámetro

C.2.2.3. Añadir los Puertos

Para poder simular el dispositivo es necesario indicar dónde se encuentran los puertos (únicamente dos en este TFM). Para ello es necesario crear tiras microstrip que se encuentren en contacto con el borde de la caja (Figura C.12). Esas tiras deben tener una anchura equivalente a 50Ω o a la impedancia característica deseada para los puertos.

Tras generar el polígono y asegurar que está en contacto con el borde, se procede a añadir los puertos mediante la opción **Add Ports** del menú **Tools** de la barra de herramientas del Editor. Esto generará un indicador numérico en dicha posición que simboliza el puerto. Si se hace doble click sobre él se accede al menú de configuración (Figura C.13).

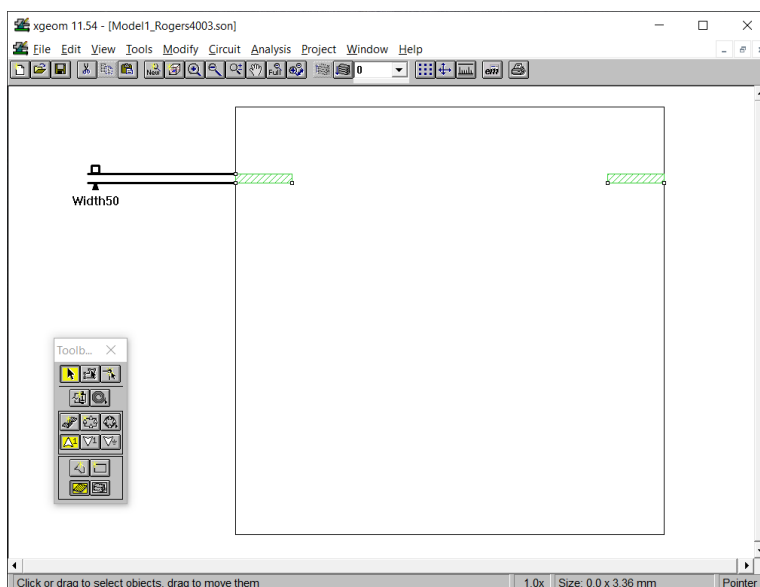


Figura C.12: Creación de tiras para situar los puertos

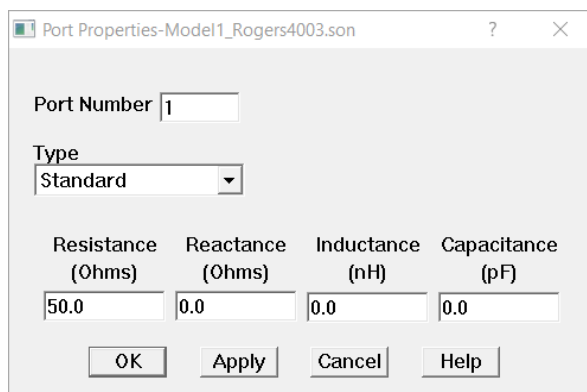


Figura C.13: Diálogo de configuración del puerto

C.2.2.4. Añadir Resistencias

Para finalizar este apartado se explica cómo añadir resistencias. Para añadir un componente nuevo se selecciona la opción **Ideal** del menú **Add Component**, que se encuentra en el apartado **Tools** de la barra de herramientas. Hay que tener en cuenta el tipo y modelo de resistencias que se va a utilizar para determinar el ancho del terminal (0,5mm en este TFM). También es posible decidir si se tratará al componente de forma ideal o no, que al tratarse de resistencias de valores acotados en este caso es posible analizar con una resistencia ideal. En la Figura C.14 se muestra el diálogo de configuración.

Es importante tener en cuenta el lugar en el que se añade la resistencia respecto a las tiras, siendo aconsejable centrarlas respecto a sus bordes.

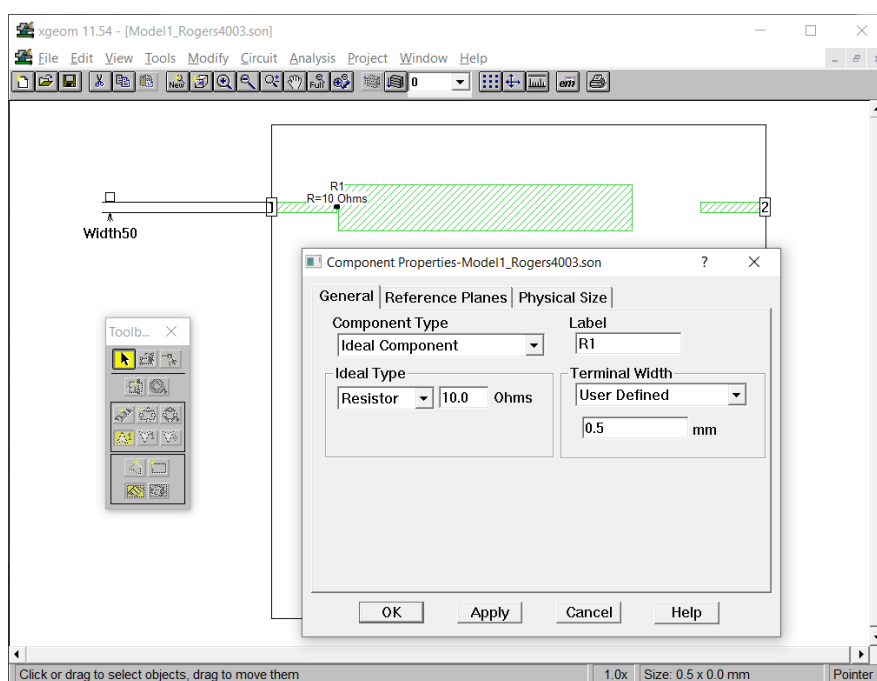


Figura C.14: Añadir un componente al prototipo

C.2.2.5. Añadir Planos de Referencia

Los planos de referencia permiten que el software calcule el retardo de grupo con respecto a dichos puntos, descontando el retardo debido a la longitud de los puertos. Para añadir los planos de referencia seleccionamos la opción **Ref. Planes/Calc Length...** del menú **Circuit**. Existen tres opciones para marcar el plano de referencia, pero la más sencilla es **Linked**, que nos permite simplemente pinchar en el punto donde queremos que se sitúe dicho plano y el software calcula el resto (Figura C.15).

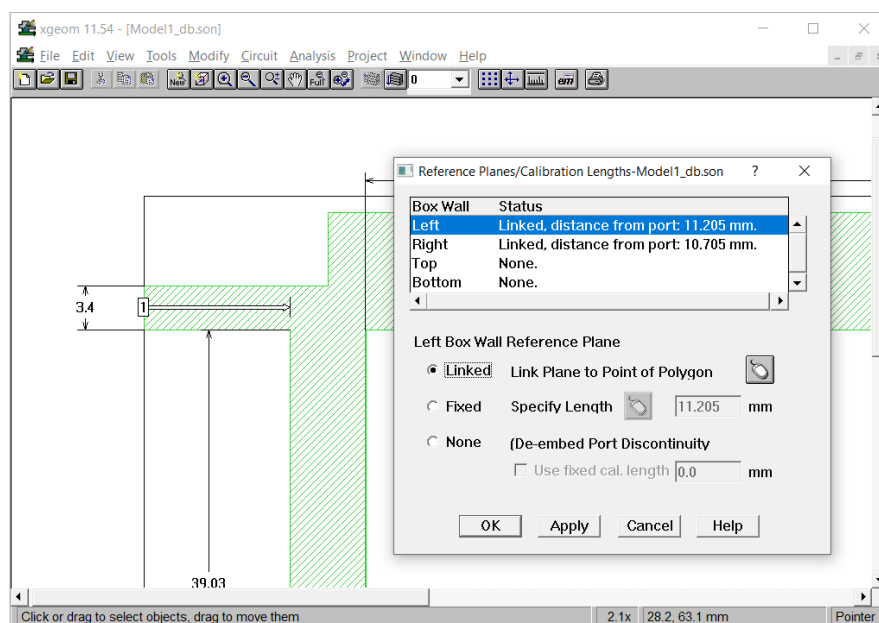


Figura C.15: Añadir un plano de referencia

C.2.3. Configuración de la simulación

Para poder simular correctamente, es necesario configurar los parámetros de análisis seleccionando, al menos, el tipo y el rango frecuencial. Esta configuración se encuentra en el En este TFM se opta por **Adaptative Sweep (ABS)** (Figura C.16a). Este tipo de análisis simula el dispositivo para las frecuencias inicial y final introducidas por el usuario. Posteriormente y de forma iterativa, calcula la respuesta del circuito en otros puntos hasta que determina un polinomio racional para los parámetros S.

También es posible elegir un tipo de análisis para optimizar el circuito en base a unas condiciones (Figura C.16b).

Es interesante también las opciones de cálculo de densidad de corriente y de ahorro de memoria. La primera, como su nombre indica, devuelve también la densidad de corriente para el dispositivo, pudiendo visualizarla mediante una vista 3D del prototipo. La segunda, al igual que las opciones dentro del menú **Speed/Memory**, sirven para realizar simulaciones más precisas a costa de un uso intensivo de la memoria o ahorrar memoria a costa de sacrificar la precisión.

C.2.4. Simulación y Visualización

Tras analizar el prototipo (**Project** → **Analyze**) se obtendrá un resultado similar al de la Figura C.17, es posible visualizar la respuesta mediante la opción **View Response**, de la barra de iconos superior, se abre una nueva ventana con la respuesta (Figura C.17). Para añadir otros parámetros S (o aquellos que se deseen), es necesario

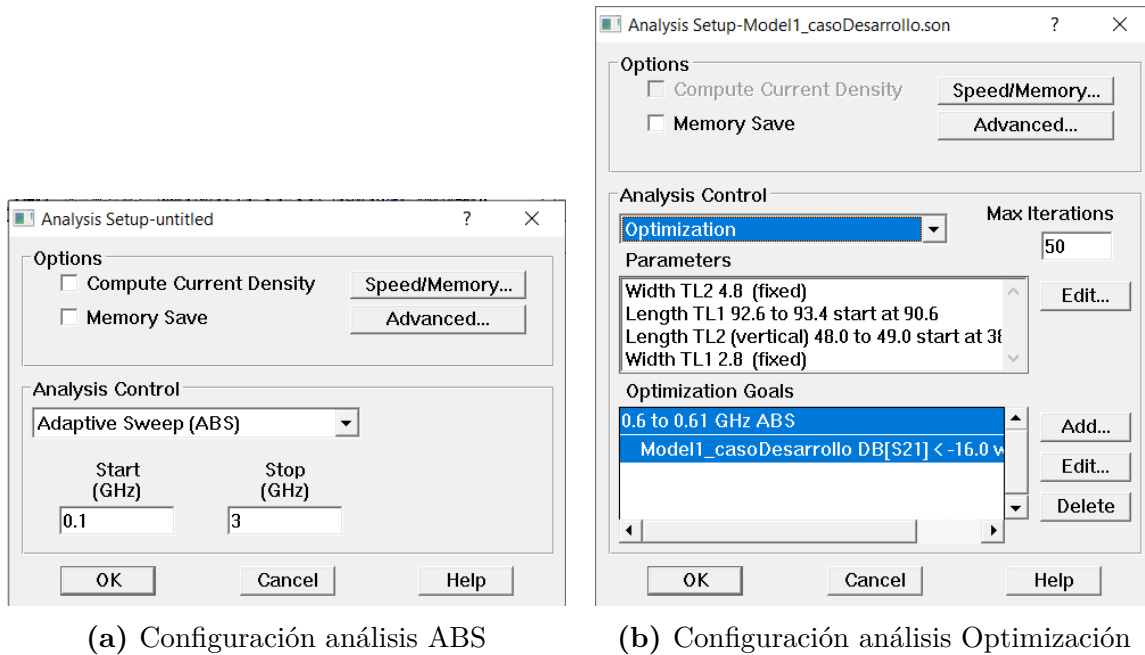


Figura C.16: Configuración del análisis

abrir el menú **Add Curve Group** de la opción **Curve** de la barra de herramientas. Sin embargo, si lo que se desea es representar el retardo de grupo, que se calcula a partir del parámetro S_{21} , se debe añadir mediante el diálogo que se muestra al seleccionar **Add Equation Curve** del menú **Equation**. Tras añadir todas las respuestas deseadas se obtiene una representación similar a la de la Figura C.18

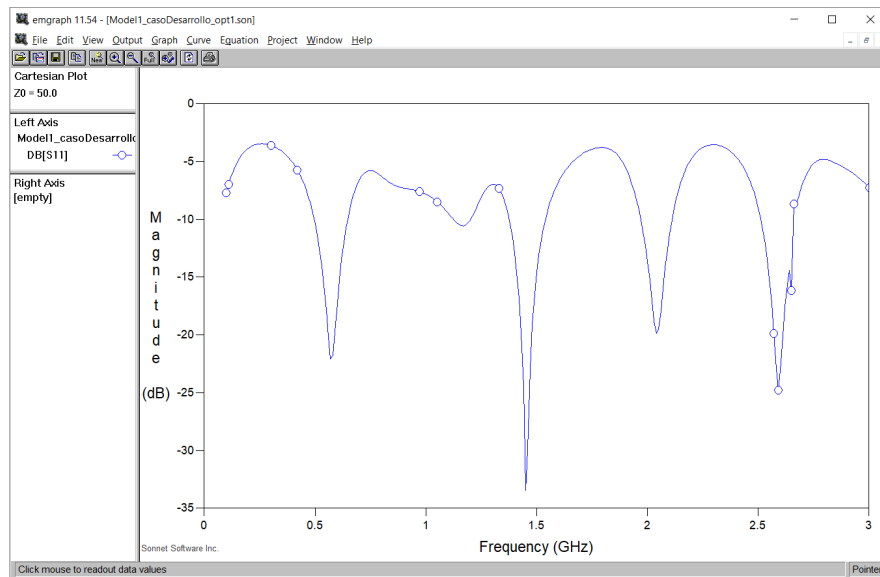


Figura C.17: Entorno de visualización

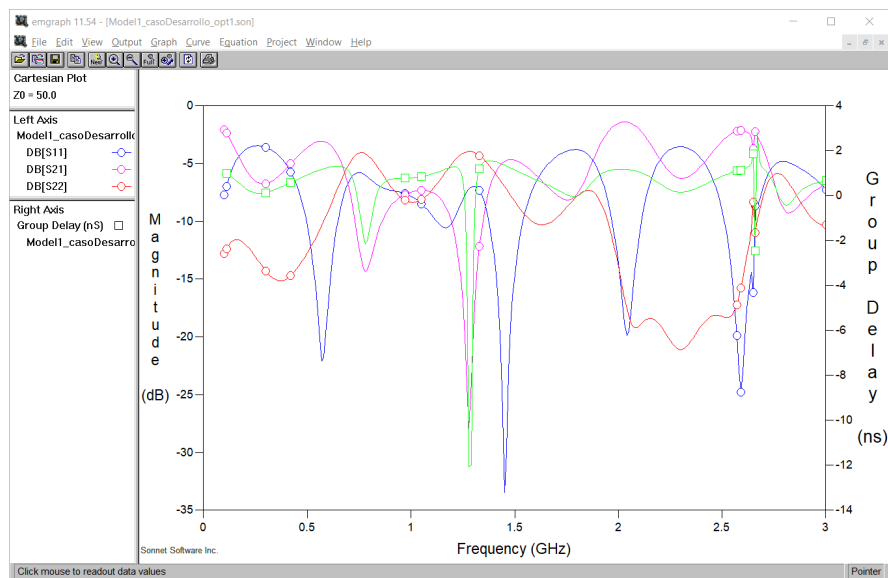


Figura C.18: Entorno de visualización con múltiples respuestas

D. Códigos Matlab

En este anexo se detallan los códigos desarrollados en Matlab para este TFM. Cabe destacar que las llamadas a la función **setfigpaper** ejecutan una función almacenada en local y de licencia GPL 3.0 [46].

Código D.1: Script de simulación del Modelo 1

```
1 %% Test Model 1
2 addpath('C:\Users\Marga\Documents\TFM\Computacion\MATLAB\funcs');
3
4 %% Data
5 allvars = {5,55,5,5,40,100};
6 r1 = allvars{1};
7 z1 = allvars{2};
8 r2 = allvars{3};
9 r3 = allvars{4};
10 z2 = allvars{5};
11 r4 = allvars{6};
12
13 z0=50;
14 f0=1e9; % 1 GHz
15 fn = 0:0.001:2; % 1 MHz step for 1 GHz
16 f=(fn.*f0).';
17
18 %% Calc
19 s = fcalcMod1(r1,z1,r2,r3,z2,r4,z0,fn);
20 s21=reshape(s(2,1,:),[],1,1);
21 s11=reshape(s(1,1,:),[],1,1);
22 s22=reshape(s(2,2,:),[],1,1);
23 group_delay = -(diff(unwrap(angle(s21),pi))./diff(f))/(2*pi);
24 fig = figure;
25 left_color = [0 0 0];
26 right_color = [0 0 0];
27 set(fig,'defaultAxesColorOrder',[left_color; right_color]);
28 title("Modelo 1: R1="+num2str(allvars{1})+" Z1="+num2str(allvars{2})+...
29      " R2="+num2str(allvars{3})+" R3="+num2str(allvars{4})+...
30      " Z2="+num2str(allvars{5})+" R4="+num2str(allvars{6}));
31 hold on
32 grid on
33 yyaxis left
34 plot(f(1:end-1).*1e-9,group_delay.*1e9,'b-');
35 ylabel('NGD (ns)')
36 yyaxis right
37 plot(f(1:end-1).*1e-9,20*log10(abs(s21(1:end-1))), 'r-');
```

```

38 plot(f(1:end-1).*1e-9,20*log10(abs(s11(1:end-1))), 'm-');
39 plot(f(1:end-1).*1e-9,20*log10(abs(s22(1:end-1))), 'k-');
40 ylabel('SP (dB)');
41 xlabel('f (GHz)');
42 legend('NGD', 'S21', 'S11', 'S22', 'Location', 'best');
43 yyaxis right
44 ylim([-35, 5])
45 yyaxis left
46 ylim([-35, 5])
47 setfigpaper;

```

Código D.2: Función para el cálculo de los parámetros S del Modelo 1

```

1 function [S] = fcalcMod1(r1,z1,r2,r3,z2,r4,z0,fn)
2 %% Initial variables
3 if (z1~=0); y1=1/z1; else; y1=0; end
4 if (z2~=0); y2=1/z2; else; y2=0; end
5
6 theta1a=pi;
7 theta2a=2*pi;
8 Y0=1/z0;
9
10 %% Create theta matrix
11 THETA1A = reshape(theta1a.*fn,1,1,[]);
12 THETA2A = reshape(theta2a.*fn,1,1,[]);
13
14 %% ABCD matrix for Resistances and Transmission Lines
15 R1 = [1 r1; 0 1];
16 R2 = [1 r2; 0 1];
17 R3 = [1 r3; 0 1];
18 R4 = [1 r4; 0 1];
19 % Adequation for matrix operations
20 R1=repmat(R1,1,1,length(fn));
21 R2=repmat(R2,1,1,length(fn));
22 R3=repmat(R3,1,1,length(fn));
23 R4=repmat(R4,1,1,length(fn));
24 % ABCD matrix for TLs
25 TL1 = [cos(THETA1A) 1i*z1*sin(THETA1A); 1i*y1*sin(THETA1A) cos(THETA1A)];
26 TL2 = [cos(THETA2A) 1i*z2*sin(THETA2A); 1i*y2*sin(THETA2A) cos(THETA2A)];
27
28 %% Calc Paths equivalent
29 PATH1 = zeros(size(TL1));
30 PATH2 = zeros(size(TL1));
31 % tic
32 for m=1:length(TL1)
33     PATH1(:,m) = R1(:,m)*TL1(:,m)*R2(:,m);
34     PATH2(:,m) = R3(:,m)*TL2(:,m)*R4(:,m);
35 end
36 S = fPaths2SP(PATH1, PATH2, Y0);
37 end

```

Código D.3: Función para el cálculo de la matriz SP equivalente de una red de dos ramas en paralelo

```

1 function [S] = fPaths2SP(PATH1, PATH2, Y0)
2 % Conversion ABCD -> Y matrix
3 A1 = PATH1(1,1,:); B1 = PATH1(1,2,:); C1 = PATH1(2,1,:); D1 = PATH1(2,2,:);
4 A2 = PATH2(1,1,:); B2 = PATH2(1,2,:); C2 = PATH2(2,1,:); D2 = PATH2(2,2,:);
5 Y_path1 = [(D1./B1),((B1.*C1-A1.*D1)./(B1));(-1./B1),(A1./B1)];
6 Y_path2 = [(D2./B2),((B2.*C2-A2.*D2)./(B2));(-1./B2),(A2./B2)];
7 % Y_path1 = abcd2y(PATH1);
8 % Y_path2 = abcd2y(PATH2);
9
10 % Calc circuit equivalent Y matrix
11 Y = Y_path1 + Y_path2;
12
13 % Conversoin Y -> S matrix
14 Y11 = Y(1,1,:); Y12 = Y(1,2,:); Y21 = Y(2,1,:); Y22 = Y(2,2,:);
15 deltaY = (Y11+Y0).*(Y22+Y0)-Y12.*Y21;
16 S11(1,1,:) = ((Y0-Y11).*(Y0+Y22)+Y12.*Y21)./(deltaY);
17 S12(1,1,:) = (-2*Y12.*Y0)./(deltaY);
18 S21(1,1,:) = (-2*Y21.*Y0)./(deltaY);
19 S22(1,1,:) = ((Y0+Y11).*(Y0-Y22)+Y12.*Y21)./(deltaY);
20 S = [S11, S12; S21, S22];
21 % S = y2s(Y,z0);
22 end

```

Código D.4: Creación del DataStore

```

1 %% MacroDS
2 % Convertir un conjunto de archivos .mat independientes en un datastore
3 % para posteriormente almacenarlo como un tallDataStore y poder modificarlo
4 inDir = "E:\TFM_DATA\Mod1";
5 varnames = load('varnamesModels.mat');
6 varnames = varnames.varnamesMod1;
7 outDir = "E:\TFM_DATA\Mod1DS";
8 % Read the data back in as a tall array. First create a datastore ...
9 ds = fileDatastore(fullfile(inDir, '*.mat'), ...
10     'ReadFcn', @(fname) [repmat(str2double(fname(24:26)),161051,1), ...
11     repmat(str2double(fname(29:31)),161051,1) ,...
12     repmat(str2double(fname(34:36)),161051,1) ,...
13     getfield(load(fname), 'data')], ...
14     'UniformRead', true);
15 % ... and then a tall array
16 ds = transform(ds, @(x) array2table(x,'VariableNames',varnames));
17 tdata = tall(ds);
18 write(outDir, tdata);

```

Código D.5: Filtrado del DataStore Modelo 1

```

1 %% Create filtered DataStores
2 % Add functions path
3 addpath('funcs');

```

```

4 % Load Datastore
5 ds = datastore('E:\TFM_DATA\Mod1DS\');
6
7 %% Double Band
8 cDoubleBand = @(x) (x.Del1<=-1e-9 & x.S211>=0.1 & isnan(x.DelC));
9 ds.reset;
10 tic
11 [newData] = parforApplyCondition(ds,cDoubleBand);
12 toc
13 tdata = tall(newData);
14 outDir = "E:\TFM_DATA\Mod1DS_DoubleBand";
15 write(outDir, tdata);
16
17 %% Triple Band
18 cTripleBand = @(x) (x.Del1<=-1e-9 & x.S211>=0.1 & x.DelC<=-1e-9 & x.S21C>=0.1);
19 ds.reset;
20 tic
21 [newData] = parforApplyCondition(ds,cTripleBand);
22 toc
23 tdata = tall(newData);
24 outDir = "E:\TFM_DATA\Mod1DS_TripleBand";
25 write(outDir, tdata);
26
27 %% Center Band
28 cCenterBand = @(x) (x.DelC<=-1e-9 & x.S21C>=0.1 & isnan(x.Del1));
29 ds.reset;
30 tic
31 [newData] = parforApplyCondition(ds,cCenterBand);
32 toc
33 tdata = tall(newData);
34 outDir = "E:\TFM_DATA\Mod1DS_CenterBand";
35 write(outDir, tdata);

```

Código D.6: Aplicación para el análisis paramétrico del Modelo 1

```

1 classdef visualizerMod1 < matlab.apps.AppBase
2
3     % Properties that correspond to app components
4     properties (Access = public)
5         UIFigure matlab.ui.Figure
6         GridLayout matlab.ui.container.GridLayout
7         LeftPanel matlab.ui.container.Panel
8         OpenButton matlab.ui.control.Button
9         ApplyConditionButton matlab.ui.control.Button
10        FolderPathEditFieldLabel matlab.ui.control.Label
11        FolderPathEditField matlab.ui.control.EditField
12        DataConditionDropDownLabel matlab.ui.control.Label
13        DataConditionDropDown matlab.ui.control.DropDown
14        PersonalizedDataConditionTextAreaLabel matlab.ui.control.Label
15        PersonalizedDataConditionTextArea matlab.ui.control.TextArea
16        TitleEditFieldLabel matlab.ui.control.Label

```

```

17 TitleEditField matlab.ui.control.EditField
18 RightPanel matlab.ui.container.Panel
19 VisualizeButton matlab.ui.control.Button
20 XAxisDropDownLabel matlab.ui.control.Label
21 XAxisDropDown matlab.ui.control.DropDown
22 PersonalizedXAxisTextAreaLabel matlab.ui.control.Label
23 PersonalizedXAxisTextArea matlab.ui.control.TextArea
24 YAxisDropDownLabel matlab.ui.control.Label
25 YAxisDropDown matlab.ui.control.DropDown
26 PersonalizedYAxisTextAreaLabel matlab.ui.control.Label
27 PersonalizedYAxisTextArea matlab.ui.control.TextArea
28 ZAxisDropDownLabel matlab.ui.control.Label
29 ZAxisDropDown matlab.ui.control.DropDown
30 PersonalizedZAxisTextAreaLabel matlab.ui.control.Label
31 PersonalizedZAxisTextArea matlab.ui.control.TextArea
32 end
33
34
35 properties (Access = private)
36     % S${21}$(f_{1}) [dB]
37     % ngd(f_{1}) [s]
38
39
40     onePanelWidth = 576;
41
42     cDoubleBand = @(x) (x.Del1<=-1e-9 & x.S211>=0.1);
43     cCenterBand = @(x) (x.DelC<=-1e-9 & x.S21C>=0.1);
44     cBothOR = @(x) (x.Del1<=-1e-9 & x.S211>=0.1) | (x.DelC<=-1e-9 & x.S21C↵
↵ >=0.1);
45     cBothAND = @(x) (x.Del1<=-1e-9 & x.S211>=0.1) & (x.DelC<=-1e-9 & x.S21C↵
↵ >=0.1);
46     cNone = @(x) 1:height(x);
47     c4Rs = @(x) (x.R1~=0 & x.R2~=0 & x.R3~=0 & x.R4~=0);
48
49     condX = @(x) x.iDel1;
50     condY = @(x) x.iDel1;
51     condZ = @(x) x.iDel1;
52     condData = @(x) (x.Del1<=-1e-9 & x.S211>=0.1);
53
54     ds
55     tData
56
57     plt3d = 0
58 end
59
60 methods (Access = private)
61
62     % Changes arrangement of the app based on UIFigure width
63     function updateAppLayout(app, event)
64         currentFigureWidth = app.UIFigure.Position(3);
65         if(currentFigureWidth <= app.onePanelWidth)

```

```

66         % Change to a 2x1 grid
67         app.GridLayout.RowHeight = {480, 480};
68         app.GridLayout.ColumnWidth = {'1x'};
69         app.RightPanel.Layout.Row = 2;
70         app.RightPanel.Layout.Column = 1;
71     else
72         % Change to a 1x2 grid
73         app.GridLayout.RowHeight = {'1x'};
74         app.GridLayout.ColumnWidth = {'1x', '1x'};
75         app.RightPanel.Layout.Row = 1;
76         app.RightPanel.Layout.Column = 2;
77     end
78 end
79
80 function [newData] = parforApplyCondition(app, ds,cond)
81     N = numpartitions(ds,gcp);
82     newData = [];
83     parfor ii = 1:N
84         subds = partition(ds,N,ii);
85         Data = [];
86         while hasdata(subds)
87             data = read(subds);
88             data = data(cond(data),:);
89             Data = [Data; data];
90         end
91         newData = [newData; Data];
92     end
93 end
94 end
95
96
97 % Callbacks that handle component events
98 methods (Access = private)
99
100 % Code that executes after component creation
101 function startupFcn(app)
102     app.UIFigure.SizeChangedFcn = createCallbackFcn(app, @updateAppLayout, ↵
103         ↵ true);
104     app.XAxisDropDown.Items = {'iDel1', 'iDelC', 'Del1' 'DelC' 'S211' 'S21C' 'BW1' ↵
105         ↵ , 'BWC' 'BW1dB1' 'BW1dBC' 'BW3dB1' 'BW3dBC' 'S111' 'S11C' 'S221' ↵
106         ↵ ' 'S22C' 'f2/f1' 'Personalized'};
107     app.YAxisDropDown.Items = {'iDel1', 'iDelC', 'Del1' 'DelC' 'S211' 'S21C' 'BW1' ↵
108         ↵ , 'BWC' 'BW1dB1' 'BW1dBC' 'BW3dB1' 'BW3dBC' 'S111' 'S11C' 'S221' ↵
109         ↵ ' 'S22C' 'f2/f1' 'Personalized'};
110     app.ZAxisDropDown.Items = {'None' 'iDel1', 'iDelC', 'Del1' 'DelC' 'S211' 'S21C' ↵
111         ↵ 'BW1', 'BWC' 'BW1dB1' 'BW1dBC' 'BW3dB1' 'BW3dBC' 'S111' ' ↵
112         ↵ S11C' 'S221' 'S22C' 'f2/f1' 'Personalized'};
113     app.DataConditionDropDown.Items = {'Double Band', 'Center Band', 'Both ( ↵
114         ↵ OR)', 'Both (AND)', '4 Resistances', 'None', 'Personalized'};
115     % app.ds = datastore('E:\TFM_DATA\Mod1DS\');
116     % app.ds.reset;

```

```

109     % addpath('C:\Users\Marga\Documents\TFM\Análisis\MATLAB\funcs');
110     app.PersonalizedXAxisTextArea.Value = func2str(app.condX);
111     app.PersonalizedYAxisTextArea.Value = func2str(app.condY);
112     app.PersonalizedDataConditionTextArea.Value = func2str(app.condData);
113 end
114
115 % Value changed function: XAxisDropDown
116 function XAxisDropDownValueChanged(app, event)
117     value = app.XAxisDropDown.Value;
118     app.PersonalizedXAxisTextArea.Editable = "off";
119     switch value
120     case 'iDel1'
121         app.condX = @(x) x.iDel1;
122     case 'iDelC'
123         app.condX = @(x) x.iDelC;
124     case 'Del1'
125         app.condX = @(x) x.Del1;
126     case 'DelC'
127         app.condX = @(x) x.DelC;
128     case 'S211'
129         app.condX = @(x) 20*log10(x.S211);
130     case 'S21C'
131         app.condX = @(x) 20*log10(x.S21C);
132     case 'S221'
133         app.condX = @(x) 20*log10(x.S221);
134     case 'S22C'
135         app.condX = @(x) 20*log10(x.S22C);
136     case 'S111'
137         app.condX = @(x) 20*log10(x.S111);
138     case 'S11C'
139         app.condX = @(x) 20*log10(x.S11C);
140     case 'BW1'
141         app.condX = @(x) x.iBW12 - x.iBW11;
142     case 'BWC'
143         app.condX = @(x) x.iBWC2 - x.iBWC1;
144     case 'BW1dB1'
145         app.condX = @(x) x.iBW1dB12 - x.iBW1dB11;
146     case 'BW1dBC'
147         app.condX = @(x) x.iBW1dBC2 - x.iBW1dBC1;
148     case 'BW3dB1'
149         app.condX = @(x) x.iBW3dB12 - x.iBW3dB11;
150     case 'BW3dBC'
151         app.condX = @(x) x.iBW3dBC2 - x.iBW3dBC1;
152     case 'f2/f1'
153         app.condX = @(x) (2000-x.iDel1)./x.iDel1;
154     case 'Personalized'
155         app.PersonalizedXAxisTextArea.Editable = "on";
156         app.PersonalizedXAxisTextArea.ValueChanged;
157     end
158     app.PersonalizedXAxisTextArea.Value = func2str(app.condX);
159 end

```

```

160
161 % Value changed function: YAxisDropDown
162 function YAxisDropDownValueChanged(app, event)
163     value = app.YAxisDropDown.Value;
164     app.PersonalizedYAxisTextArea.Editable = "off";
165     switch value
166     case 'iDel1'
167         app.condY = @(x) x.iDel1;
168     case 'iDelC'
169         app.condY = @(x) x.iDelC;
170     case 'Del1'
171         app.condY = @(x) x.Del1;
172     case 'DelC'
173         app.condY = @(x) x.DelC;
174     case 'S211'
175         app.condY = @(x) 20*log10(x.S211);
176     case 'S21C'
177         app.condY = @(x) 20*log10(x.S21C);
178     case 'S221'
179         app.condY = @(x) 20*log10(x.S221);
180     case 'S22C'
181         app.condY = @(x) 20*log10(x.S22C);
182     case 'S111'
183         app.condY = @(x) 20*log10(x.S111);
184     case 'S11C'
185         app.condY = @(x) 20*log10(x.S11C);
186     case 'BW1'
187         app.condY = @(x) x.iBW12 - x.iBW11;
188     case 'BWC'
189         app.condY = @(x) x.iBWC2 - x.iBWC1;
190     case 'BW1dB1'
191         app.condY = @(x) x.iBW1dB12 - x.iBW1dB11;
192     case 'BW1dBC'
193         app.condY = @(x) x.iBW1dBC2 - x.iBW1dBC1;
194     case 'BW3dB1'
195         app.condY = @(x) x.iBW3dB12 - x.iBW3dB11;
196     case 'BW3dBC'
197         app.condY = @(x) x.iBW3dBC2 - x.iBW3dBC1;
198     case 'f2/f1'
199         app.condY = @(x) (2000-x.iDel1)./x.iDel1;
200     case 'Personalized'
201         app.PersonalizedYAxisTextArea.Editable = "on";
202         app.PersonalizedYAxisTextArea.ValueChanged;
203     end
204     app.PersonalizedYAxisTextArea.Value = func2str(app.condY);
205 end
206
207 % Value changed function: ZAxisDropDown
208 function ZAxisDropDownValueChanged(app, event)
209     value = app.ZAxisDropDown.Value;
210     app.PersonalizedZAxisTextArea.Editable = "off";

```

```

211     app.plt3d = 1;
212     switch value
213     case 'None'
214         app.plt3d = 0;
215         app.condZ = @(x) x.iDel1;
216     case 'iDel1'
217         app.condZ = @(x) x.iDel1;
218     case 'iDelC'
219         app.condZ = @(x) x.iDelC;
220     case 'Del1'
221         app.condZ = @(x) x.Del1;
222     case 'DelC'
223         app.condZ = @(x) x.DelC;
224     case 'S211'
225         app.condZ = @(x) 20*log10(x.S211);
226     case 'S21C'
227         app.condZ = @(x) 20*log10(x.S21C);
228     case 'S221'
229         app.condZ = @(x) 20*log10(x.S221);
230     case 'S22C'
231         app.condZ = @(x) 20*log10(x.S22C);
232     case 'S111'
233         app.condZ = @(x) 20*log10(x.S111);
234     case 'S11C'
235         app.condZ = @(x) 20*log10(x.S11C);
236     case 'BW1'
237         app.condZ = @(x) x.iBW12 - x.iBW11;
238     case 'BWC'
239         app.condZ = @(x) x.iBWC2 - x.iBWC1;
240     case 'BW1dB1'
241         app.condZ = @(x) x.iBW1dB12 - x.iBW1dB11;
242     case 'BW1dBC'
243         app.condZ = @(x) x.iBW1dBC2 - x.iBW1dBC1;
244     case 'BW3dB1'
245         app.condZ = @(x) x.iBW3dB12 - x.iBW3dB11;
246     case 'BW3dBC'
247         app.condZ = @(x) x.iBW3dBC2 - x.iBW3dBC1;
248     case 'f2/f1'
249         app.condZ = @(x) (2000-x.iDel1)./x.iDel1;
250     case 'Personalized'
251         app.PersonalizedZAxisTextArea.Editable = "on";
252         app.PersonalizedZAxisTextArea.ValueChanged;
253     end
254     app.PersonalizedZAxisTextArea.Value = func2str(app.condZ);
255 end
256
257 % Value changed function: PersonalizedXAxisTextArea
258 function PersonalizedXAxisTextAreaValueChanged(app, event)
259     value = app.PersonalizedXAxisTextArea.Value;
260     try
261         app.condX = str2func(value{:});

```

```

262         catch ME
263             str = sprintf(['Something is wrong with the Personalized X Axis. \n' 'Matlab↵
↵ says: \n' ME.message]);
264             uialert(app.UIFigure, str, 'Sintax Problem');
265         end
266     end
267
268     % Value changed function: PersonalizedYAxisTextArea
269     function PersonalizedYAxisTextAreaValueChanged(app, event)
270         value = app.PersonalizedYAxisTextArea.Value;
271         try
272             app.condY = str2func(value{:});
273         catch ME
274             str = sprintf(['Something is wrong with the Personalized Y Axis. \n' 'Matlab↵
↵ says: \n' ME.message]);
275             uialert(app.UIFigure, str, 'Sintax Problem');
276         end
277     end
278
279     % Value changed function: PersonalizedZAxisTextArea
280     function PersonalizedZAxisTextAreaValueChanged(app, event)
281         value = app.PersonalizedZAxisTextArea.Value;
282         try
283             app.condZ = str2func(value{:});
284         catch ME
285             str = sprintf(['Something is wrong with the Personalized Y Axis. \n' 'Matlab↵
↵ says: \n' ME.message]);
286             uialert(app.UIFigure, str, 'Sintax Problem');
287         end
288     end
289
290     % Value changed function: DataConditionDropDown
291     function DataConditionDropDownValueChanged(app, event)
292         value = app.DataConditionDropDown.Value;
293         app.PersonalizedDataConditionTextArea.Editable = "off";
294         switch value
295             case 'Double Band'
296                 app.condData = app.cDoubleBand;
297             case 'Center Band'
298                 app.condData = app.cCenterBand;
299             case 'Both (OR)'
300                 app.condData = app.cBothOR;
301             case 'Both (AND)'
302                 app.condData = app.cBothAND;
303             case '4 Resistances'
304                 app.condData = app.c4Rs;
305             case 'None'
306                 app.condData = app.cNone;
307             case 'Personalized'
308                 app.PersonalizedDataConditionTextArea.Editable = "on";
309                 app.PersonalizedDataConditionTextAreaValueChanged;

```

```

310         end
311         app.PersonalizedDataConditionTextArea.Value = func2str(app.condData);
312     end
313
314     % Value changed function: PersonalizedDataConditionTextArea
315     function PersonalizedDataConditionTextAreaValueChanged(app, event)
316         value = app.PersonalizedDataConditionTextArea.Value;
317         try
318             app.condData = str2func(value{:});
319         catch ME
320             str = sprintf(['Something is wrong with the Personalized Data Condition. \n'↵
321                 ↵ 'Matlab says: \n' ME.message]);
322             uialert(app.UIFigure, str, 'Sintax Problem');
323         end
324     end
325
326     % Button pushed function: ApplyConditionButton
327     function ApplyConditionButtonPushed(app, event)
328         tic
329         d = uiprogessdlg(app.UIFigure, 'Title','Applying Condition', 'Indeterminate',"on↵
330             ↵ ");
331         try
332             app.ds.reset;
333             app.tData = parforApplyCondition(app, app.ds, app.condData);
334             % app.tData = tall(app.ds);
335             % app.tData = app.tData(app.condData(app.tData,:));
336             app.ds.reset;
337         catch ME
338             str = sprintf(['Something is wrong with the datastore loaded. \n'↵
339                 ↵ 'Matlab ↵
340                 ↵ says: \n' ME.message]);
341             uialert(app.UIFigure, str, 'Data Problem');
342         end
343
344         close(d);
345         toc
346     end
347
348     % Button pushed function: VisualizeButton
349     function VisualizeButtonPushed(app, event)
350         tic
351         d = uiprogessdlg(app.UIFigure, 'Title','Creating Visualization', 'Indeterminate',"↵
352             ↵ on");
353         try
354             figure,
355             app.tData.X = app.condX(app.tData);
356             app.tData.Y = app.condY(app.tData);
357             if app.plt3d
358                 app.tData.Z = app.condZ(app.tData);
359                 pt1 = scatter3(app.tData.X, app.tData.Y,app.tData.Z,5,app.tData.Z,'x');
360                 m=100;
361                 cm_inferno=inferno();

```

```

357         colormap(cm__inferno);
358         hc=colorbar;
359         title(hc,app.ZAxisDropDown.Value,'Interpreter','latex');
360         ini=3;
361         pt1.DataTipTemplate.DataTipRows(1).Label = app.XAxisDropDown.↵
            ↵ Value;
362         pt1.DataTipTemplate.DataTipRows(2).Label = app.YAxisDropDown.↵
            ↵ Value;
363         pt1.DataTipTemplate.DataTipRows(3).Label = app.ZAxisDropDown.↵
            ↵ Value;
364         xlabel(app.XAxisDropDown.Value);
365         ylabel(app.YAxisDropDown.Value);
366         zlabel(app.ZAxisDropDown.Value);
367         view(0,90)
368     else
369         pt1 = plot(app.tData.X, app.tData.Y,'kx','MarkerSize',4);
370         ini = 2;
371         pt1.DataTipTemplate.DataTipRows(1).Label = app.XAxisDropDown.↵
            ↵ Value;
372         pt1.DataTipTemplate.DataTipRows(2).Label = app.YAxisDropDown.↵
            ↵ Value;
373         xlabel(app.XAxisDropDown.Value);
374         ylabel(app.YAxisDropDown.Value);
375     end
376     grid("on")
377     pt1.DataTipTemplate.DataTipRows(ini+1) = dataTipTextRow('R1',app.↵
        ↵ tData.R1);
378     pt1.DataTipTemplate.DataTipRows(ini+2) = dataTipTextRow('Z1',app.↵
        ↵ tData.Z1);
379     pt1.DataTipTemplate.DataTipRows(ini+3) = dataTipTextRow('R2',app.↵
        ↵ tData.R2);
380     pt1.DataTipTemplate.DataTipRows(ini+4) = dataTipTextRow('R3',app.↵
        ↵ tData.R3);
381     pt1.DataTipTemplate.DataTipRows(ini+5) = dataTipTextRow('Z2',app.↵
        ↵ tData.Z2);
382     pt1.DataTipTemplate.DataTipRows(ini+6) = dataTipTextRow('R4',app.↵
        ↵ tData.R4);
383     % scatter(app.condX(app.tData), app.condY(app.tData),'*')
384     title(app.TitleEditField.Value)
385     setfigpaper('Width', 15,'Interpreter','Latex');
386     catch ME
387         str = sprintf(['Something is wrong with the datastore loaded. \n' 'Matlab ↵
            ↵ says: \n' ME.message]);
388         uialert(app.UIFigure, str, 'Data Problem');
389     end
390
391     close(d);
392     toc
393 end
394
395 % Button pushed function: OpenButton

```

```

396     function OpenButtonPushed(app, event)
397         folderpath = uigetdir;
398         d = uiprogessdlg(app.UIFigure, 'Title','Loading Data', 'Indeterminate','on");
399         try
400             app.ds = datastore(folderpath);
401             app.ds.reset;
402             app.FolderPathEditField.Value = folderpath;
403         catch ME
404             str = sprintf(['Something is wrong with the datastore loaded. \n' 'Matlab ↵
405                           ↵ says: \n' ME.message]);
406             uialert(app.UIFigure, str, 'Load Problem');
407         end
408         close(d);
409     end
410
411     % Component initialization
412     methods (Access = private)
413
414         % Create UIFigure and components
415         function createComponents(app)
416
417             % Create UIFigure and hide until all components are created
418             app.UIFigure = uifigure('Visible', 'off');
419             app.UIFigure.AutoResizeChildren = 'off';
420             app.UIFigure.Position = [100 100 640 480];
421             app.UIFigure.Name = 'UI Figure';
422
423             % Create GridLayout
424             app.GridLayout = uigridlayout(app.UIFigure);
425             app.GridLayout.RowHeight = {'1x'};
426             app.GridLayout.ColumnSpacing = 0;
427             app.GridLayout.RowSpacing = 0;
428             app.GridLayout.Padding = [0 0 0 0];
429             app.GridLayout.Scrollable = 'on';
430
431             % Create LeftPanel
432             app.LeftPanel = uipanel(app.GridLayout);
433             app.LeftPanel.AutoResizeChildren = 'off';
434             app.LeftPanel.Layout.Row = 1;
435             app.LeftPanel.Layout.Column = 1;
436             app.LeftPanel.Scrollable = 'on';
437
438             % Create OpenButton
439             app.OpenButton = uibutton(app.LeftPanel, 'push');
440             app.OpenButton.ButtonPushedFcn = createCallbackFcn(app, @↵
441                           ↵ OpenButtonPushed, true);
442             app.OpenButton.Position = [246 359 40 22];
443             app.OpenButton.Text = 'Open';
444
445             % Create ApplyConditionButton

```

```

445 app.ApplyConditionButton = uibutton(app.LeftPanel, 'push');
446 app.ApplyConditionButton.ButtonPushedFcn = createCallbackFcn(app, @↵
    ↵ ApplyConditionButtonPushed, true);
447 app.ApplyConditionButton.Position = [186 179 100 22];
448 app.ApplyConditionButton.Text = 'Apply Condition';
449
450 % Create FolderPathEditFieldLabel
451 app.FolderPathEditFieldLabel = uilabel(app.LeftPanel);
452 app.FolderPathEditFieldLabel.HorizontalAlignment = 'right';
453 app.FolderPathEditFieldLabel.Position = [56 359 67 22];
454 app.FolderPathEditFieldLabel.Text = 'Folder Path';
455
456 % Create FolderPathEditField
457 app.FolderPathEditField = uieditfield(app.LeftPanel, 'text');
458 app.FolderPathEditField.Editable = 'off';
459 app.FolderPathEditField.Position = [136 359 100 22];
460
461 % Create DataConditionDropDownLabel
462 app.DataConditionDropDownLabel = uilabel(app.LeftPanel);
463 app.DataConditionDropDownLabel.HorizontalAlignment = 'right';
464 app.DataConditionDropDownLabel.Position = [36 289 85 22];
465 app.DataConditionDropDownLabel.Text = 'Data Condition';
466
467 % Create DataConditionDropDown
468 app.DataConditionDropDown = uidropdown(app.LeftPanel);
469 app.DataConditionDropDown.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app, @↵
    ↵ DataConditionDropDownValueChanged, true);
470 app.DataConditionDropDown.Position = [136 289 150 22];
471
472 % Create PersonalizedDataConditionTextAreaLabel
473 app.PersonalizedDataConditionTextAreaLabel = uilabel(app.LeftPanel);
474 app.PersonalizedDataConditionTextAreaLabel.HorizontalAlignment = 'right';
475 app.PersonalizedDataConditionTextAreaLabel.Position = [36 246 85 27];
476 app.PersonalizedDataConditionTextAreaLabel.Text = {'Personalized'; 'Data ↵
    ↵ Condition'};
477
478 % Create PersonalizedDataConditionTextArea
479 app.PersonalizedDataConditionTextArea = uitextarea(app.LeftPanel);
480 app.PersonalizedDataConditionTextArea.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(↵
    ↵ app, @PersonalizedDataConditionTextAreaValueChanged, true);
481 app.PersonalizedDataConditionTextArea.Editable = 'off';
482 app.PersonalizedDataConditionTextArea.Position = [136 215 150 60];
483
484 % Create TitleEditFieldLabel
485 app.TitleEditFieldLabel = uilabel(app.LeftPanel);
486 app.TitleEditFieldLabel.HorizontalAlignment = 'right';
487 app.TitleEditFieldLabel.Position = [94 111 27 22];
488 app.TitleEditFieldLabel.Text = 'Title';
489
490 % Create TitleEditField
491 app.TitleEditField = uieditfield(app.LeftPanel, 'text');

```

```

492     app.TitleEditField.Position = [136 111 150 22];
493     app.TitleEditField.Value = 'Modelo 1';
494
495     % Create RightPanel
496     app.RightPanel = uipanel(app.GridLayout);
497     app.RightPanel.AutoResizeChildren = 'off';
498     app.RightPanel.Layout.Row = 1;
499     app.RightPanel.Layout.Column = 2;
500     app.RightPanel.Scrollable = 'on';
501
502     % Create VisualizeButton
503     app.VisualizeButton = uibutton(app.RightPanel, 'push');
504     app.VisualizeButton.ButtonPushedFcn = createCallbackFcn(app, @↵
        ↵ VisualizeButtonPushed, true);
505     app.VisualizeButton.Position = [180 77 100 22];
506     app.VisualizeButton.Text = 'Visualize';
507
508     % Create XAxisDropDownLabel
509     app.XAxisDropDownLabel = uilabel(app.RightPanel);
510     app.XAxisDropDownLabel.HorizontalAlignment = 'right';
511     app.XAxisDropDownLabel.Position = [77 418 39 22];
512     app.XAxisDropDownLabel.Text = 'X Axis';
513
514     % Create XAxisDropDown
515     app.XAxisDropDown = uidropdown(app.RightPanel);
516     app.XAxisDropDown.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app, @↵
        ↵ XAxisDropDownValueChanged, true);
517     app.XAxisDropDown.Position = [131 418 150 22];
518
519     % Create PersonalizedXAxisTextAreaLabel
520     app.PersonalizedXAxisTextAreaLabel = uilabel(app.RightPanel);
521     app.PersonalizedXAxisTextAreaLabel.HorizontalAlignment = 'right';
522     app.PersonalizedXAxisTextAreaLabel.Position = [41 379 75 27];
523     app.PersonalizedXAxisTextAreaLabel.Text = {'Personalized'; 'X Axis'};
524
525     % Create PersonalizedXAxisTextArea
526     app.PersonalizedXAxisTextArea = uitextarea(app.RightPanel);
527     app.PersonalizedXAxisTextArea.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app, @↵
        ↵ PersonalizedXAxisTextAreaValueChanged, true);
528     app.PersonalizedXAxisTextArea.Editable = 'off';
529     app.PersonalizedXAxisTextArea.Position = [131 348 150 60];
530
531     % Create YAxisDropDownLabel
532     app.YAxisDropDownLabel = uilabel(app.RightPanel);
533     app.YAxisDropDownLabel.HorizontalAlignment = 'right';
534     app.YAxisDropDownLabel.Position = [77 306 39 22];
535     app.YAxisDropDownLabel.Text = 'Y Axis';
536
537     % Create YAxisDropDown
538     app.YAxisDropDown = uidropdown(app.RightPanel);
539     app.YAxisDropDown.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app, @↵

```

```

540         ↪ YAxisDropDownValueChanged, true);
541     app.YAxisDropDown.Position = [131 306 150 22];
542
543     % Create PersonalizedYAxisTextAreaLabel
544     app.PersonalizedYAxisTextAreaLabel = uilabel(app.RightPanel);
545     app.PersonalizedYAxisTextAreaLabel.HorizontalAlignment = 'right';
546     app.PersonalizedYAxisTextAreaLabel.Position = [40 272 75 27];
547     app.PersonalizedYAxisTextAreaLabel.Text = {'Personalized'; 'Y Axis'};
548
549     % Create PersonalizedYAxisTextArea
550     app.PersonalizedYAxisTextArea = uitextarea(app.RightPanel);
551     app.PersonalizedYAxisTextArea.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app, @↪
552         ↪ PersonalizedYAxisTextAreaValueChanged, true);
553     app.PersonalizedYAxisTextArea.Editable = 'off';
554     app.PersonalizedYAxisTextArea.Position = [130 236 150 60];
555
556     % Create ZAxisDropDownLabel
557     app.ZAxisDropDownLabel = uilabel(app.RightPanel);
558     app.ZAxisDropDownLabel.HorizontalAlignment = 'right';
559     app.ZAxisDropDownLabel.Position = [77 194 39 22];
560     app.ZAxisDropDownLabel.Text = 'Z Axis';
561
562     % Create ZAxisDropDown
563     app.ZAxisDropDown = uidropdown(app.RightPanel);
564     app.ZAxisDropDown.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app, @↪
565         ↪ ZAxisDropDownValueChanged, true);
566     app.ZAxisDropDown.Position = [131 194 150 22];
567
568     % Create PersonalizedZAxisTextAreaLabel
569     app.PersonalizedZAxisTextAreaLabel = uilabel(app.RightPanel);
570     app.PersonalizedZAxisTextAreaLabel.HorizontalAlignment = 'right';
571     app.PersonalizedZAxisTextAreaLabel.Position = [40 155 75 27];
572     app.PersonalizedZAxisTextAreaLabel.Text = {'Personalized'; 'Z Axis'};
573
574     % Create PersonalizedZAxisTextArea
575     app.PersonalizedZAxisTextArea = uitextarea(app.RightPanel);
576     app.PersonalizedZAxisTextArea.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app, @↪
577         ↪ PersonalizedZAxisTextAreaValueChanged, true);
578     app.PersonalizedZAxisTextArea.Editable = 'off';
579     app.PersonalizedZAxisTextArea.Position = [130 124 150 60];
580
581     % Show the figure after all components are created
582     app.UIFigure.Visible = 'on';
583 end
584
585 % App creation and deletion
586 methods (Access = public)
587
588     % Construct app
589     function app = visualizerMod1

```

```

587
588     % Create UIFigure and components
589     createComponents(app)
590
591     % Register the app with App Designer
592     registerApp(app, app.UIFigure)
593
594     % Execute the startup function
595     runStartupFcn(app, @startupFcn)
596
597     if nargin == 0
598         clear app
599     end
600 end
601
602 % Code that executes before app deletion
603 function delete(app)
604
605     % Delete UIFigure when app is deleted
606     delete(app.UIFigure)
607 end
608 end
609 end

```

Código D.7: Función para calcular el histograma en paralelo

```

1 function [histo] = parforHistograma(ds,cond)
2 N = numpartitions(ds,gcp);
3 histo = zeros(21,6);
4 parfor ii = 1:N
5     % Get partition ii of the datastore.
6     subds = partition(ds,N,ii);
7     hist = zeros(21,6);
8     r1=0; z1=0; r2=0; r3=0; z2=0; r4=0;
9     R = linspace(-2.5,102.5,22);
10    Z = linspace(22.5,127.5,22);
11    while (hasdata(subds))
12        dataALL = read(subds);
13        data = dataALL(cond(dataALL),:);
14        r1 = histcounts(data.R1,R);
15        z1 = histcounts(data.Z1,Z);
16        r2 = histcounts(data.R2,R);
17        r3 = histcounts(data.R3,R);
18        z2 = histcounts(data.Z2,Z);
19        r4 = histcounts(data.R4,R);
20        hist(:,1) = hist(:,1) + r1';
21        hist(:,2) = hist(:,2) + z1';
22        hist(:,3) = hist(:,3) + r2';
23        hist(:,4) = hist(:,4) + r3';
24        hist(:,5) = hist(:,5) + z2';
25        hist(:,6) = hist(:,6) + r4';

```

```

26 end
27 histo = histo + hist;
28 end
29 end

```

Código D.8: Script de análisis (Histograma) del Modelo 1

```

1 %% Analysis Model 1
2 addpath('funcs');
3 %% Carga DataStore y Nombre de Variables
4 ds = datastore('E:\TFM_DATA\Mod1DS_DoubleBand\');
5 %% Condiciones Tabla
6 cNone = @(x) 1:height(x);
7 %% Análisis
8 ds.reset;
9 tic
10 [Histo] = parforHistograma(ds, cNone);
11 toc
12 %% Representación
13 R = linspace(0,100,21);
14 Z = linspace(25,125,21);
15 figure('Name','Double Band'),
16 subplot(2,3,1), bar(R,Histo(:,1),'b'), title('R1'), xlabel('\Omega')
17 subplot(2,3,2), bar(Z,Histo(:,2),'b'), title('Z1'), xlabel('\Omega'), xticks(linspace(25,125,6))
18 subplot(2,3,3), bar(R,Histo(:,3),'b'), title('R2'), xlabel('\Omega')
19 subplot(2,3,4), bar(R,Histo(:,4),'b'), title('R3'), xlabel('\Omega')
20 subplot(2,3,5), bar(Z,Histo(:,5),'b'), title('Z2'), xlabel('\Omega'), xticks(linspace(25,125,6))
21 subplot(2,3,6), bar(R,Histo(:,6),'b'), title('R4'), xlabel('\Omega')

```

Código D.9: Aplicación para generar curvas de diseño para el Modelo 1

```

1 classdef designChartsMod1 < matlab.apps.AppBase
2
3     % Properties that correspond to app components
4     properties (Access = public)
5         UIFigure matlab.ui.Figure
6         GridLayout matlab.ui.container.GridLayout
7         LeftPanel matlab.ui.container.Panel
8         OpenButton matlab.ui.control.Button
9         FolderPathEditFieldLabel matlab.ui.control.Label
10        FolderPathEditField matlab.ui.control.EditField
11        ApplyConditionButton matlab.ui.control.Button
12        DataConditionDropDownLabel matlab.ui.control.Label
13        DataConditionDropDown matlab.ui.control.DropDown
14        PersonalizedDataConditionTextAreaLabel matlab.ui.control.Label
15        PersonalizedDataConditionTextArea matlab.ui.control.TextArea
16        RightPanel matlab.ui.container.Panel
17        PlotButton matlab.ui.control.Button
18        R1DropDownLabel matlab.ui.control.Label
19        R1DropDown matlab.ui.control.DropDown
20        Z1DropDownLabel matlab.ui.control.Label

```

```

21 Z1DropDown matlab.ui.control.DropDown
22 R2DropDownLabel matlab.ui.control.Label
23 R2DropDown matlab.ui.control.DropDown
24 R3DropDownLabel matlab.ui.control.Label
25 R3DropDown matlab.ui.control.DropDown
26 Z2DropDownLabel matlab.ui.control.Label
27 Z2DropDown matlab.ui.control.DropDown
28 R4DropDownLabel matlab.ui.control.Label
29 R4DropDown matlab.ui.control.DropDown
30 YAxisDropDownLabel matlab.ui.control.Label
31 YAxisDropDown matlab.ui.control.DropDown
32 XAxisDropDownLabel matlab.ui.control.Label
33 XAxisDropDown matlab.ui.control.DropDown
34 LegendDropDownLabel matlab.ui.control.Label
35 LegendDropDown matlab.ui.control.DropDown
36 PersonalizedYAxisLabel matlab.ui.control.Label
37 PersonalizedYAxisTextArea matlab.ui.control.TextArea
38 PersonalizedXAxisTextAreaLabel matlab.ui.control.Label
39 PersonalizedXAxisTextArea matlab.ui.control.TextArea
40 TitleEditFieldLabel matlab.ui.control.Label
41 TitleEditField matlab.ui.control.EditField
42 end
43
44
45 properties (Access = private)
46     onePanelWidth = 576;
47     ds % Description
48     tData % Description
49     yVariable % Description
50     xVariable % Description
51     legendVariable % Description
52     r1=NaN % Description
53     z1=NaN % Description
54     r2=NaN % Description
55     r3=NaN % Description
56     z2=NaN % Description
57     r4=NaN % Description
58     plotData % Description
59
60     cDoubleBand = @(x) (x.Del1<=-1e-9 & x.S211>=0.1);
61     cCenterBand = @(x) (x.DelC<=-1e-9 & x.S21C>=0.1);
62     cBothOR = @(x) (x.Del1<=-1e-9 & x.S211>=0.1) | (x.DelC<=-1e-9 & x.S21C↵
↵ >=0.1);
63     cBothAND = @(x) (x.Del1<=-1e-9 & x.S211>=0.1) & (x.DelC<=-1e-9 & x.S21C↵
↵ >=0.1);
64     cNone = @(x) 1:height(x);
65     c4Rs = @(x) (x.R1~=0 & x.R2~=0 & x.R3~=0 & x.R4~=0);
66
67     condData = @(x) 1:height(x);
68 end
69

```

```

70 methods (Access = private)
71
72 % Changes arrangement of the app based on UIFigure width
73 function updateAppLayout(app, event)
74     currentFigureWidth = app.UIFigure.Position(3);
75     if(currentFigureWidth <= app.onePanelWidth)
76         % Change to a 2x1 grid
77         app.GridLayout.RowHeight = {480, 480};
78         app.GridLayout.ColumnWidth = {'1x'};
79         app.RightPanel.Layout.Row = 2;
80         app.RightPanel.Layout.Column = 1;
81     else
82         % Change to a 1x2 grid
83         app.GridLayout.RowHeight = {'1x'};
84         app.GridLayout.ColumnWidth = {'1x', '1x'};
85         app.RightPanel.Layout.Row = 1;
86         app.RightPanel.Layout.Column = 2;
87     end
88 end
89
90
91
92 function [newData] = parforApplyConditions(app, ds)
93     rr1 = app.r1;
94     zz1 = app.z1;
95     rr2 = app.r2;
96     rr3 = app.r3;
97     zz2 = app.z2;
98     rr4 = app.r4;
99     funstr = "@(x)";
100     if ~isnan(rr1)
101         funstr=funstr.append(sprintf("x.R1==%d&",rr1));
102     end
103     if ~isnan(zz1)
104         funstr=funstr.append(sprintf("x.Z1==%d&",zz1));
105     end
106     if ~isnan(rr2)
107         funstr=funstr.append(sprintf("x.R2==%d&",rr2));
108     end
109     if ~isnan(rr3)
110         funstr=funstr.append(sprintf("x.R3==%d&",rr3));
111     end
112     if ~isnan(zz2)
113         funstr=funstr.append(sprintf("x.Z2==%d&",zz2));
114     end
115     if ~isnan(rr4)
116         funstr=funstr.append(sprintf("x.R4==%d&",rr4));
117     end
118     funchar = char(funstr);
119     funstr = string(funchar(1:end-1));
120     cond = str2func(funstr);

```

```

121     clear funchar funstr rr1 rr2 rr3 rr4 zz1 zz2
122     N = numpartitions(ds,gcp);
123     newData = [];
124     parfor ii = 1:N
125         subds = partition(ds,N,ii);
126         Data = [];
127         while hasdata(subds)
128             data = read(subds);
129             data = data(cond(data,:),)
130             Data = [Data; data];
131         end
132         newData = [newData; Data];
133     end
134 end
135
136 function [newData] = parforApplyCondition(app, ds,cond)
137     N = numpartitions(ds,gcp);
138     newData = [];
139     parfor ii = 1:N
140         subds = partition(ds,N,ii);
141         Data = [];
142         while hasdata(subds)
143             data = read(subds);
144             data = data(cond(data,:),);
145             Data = [Data; data];
146         end
147         newData = [newData; Data];
148     end
149 end
150 end
151
152 % Callbacks that handle component events
153 methods (Access = private)
154
155 % Code that executes after component creation
156 function startupFcn(app)
157     app.UIFigure.SizeChangedFcn = createCallbackFcn(app, @updateAppLayout, ↵
158         ↵ true);
159     % app.ds = datastore('E:\TFM_DATA\Mod1DS\');
160     % app.ds.reset;
161     app.YAxisDropDown.Items = {'NGD f1', 'NGD fc', 'S21 f1', 'S21 fc', 'BW f1', '↵
162         ↵ BW fc', 'f2/f1', 'S11 f1', 'S11 fc', 'S22 f1', 'S22 fc', 'Personalized'};
163     app.XAxisDropDown.Items = {'R1', 'Z1', 'R2', 'R3', 'Z2', 'R4', 'Personalized'};
164     app.LegendDropDown.Items = {'R1', 'Z1', 'R2', 'R3', 'Z2', 'R4'};
165     app.LegendDropDown.Value = 'Z1';
166     app.DataConditionDropDown.Items = {'None', 'Double Band', 'Center Band', '↵
167         ↵ Both (OR)', 'Both (AND)', '4 Resistances', 'Personalized'};
168     app.PersonalizedDataConditionTextArea.Value = func2str(app.condData);
169     app.R1DropDown.Items = {'NaN', '0', '5', '10', '15', '20', '25', '30', '35', '40', '45'↵
170         ↵ , '50', '55', '60', '65', '70', '75', '80', '85', '90', '95', '100'};

```

```

168 app.Z1DropDown.Items = {'NaN','25','30','35','40','45','50','55','60','65','↵
    ↵ 70','75','80','85','90','95','100','105','110','115','120','125'};
169 app.R2DropDown.Items = {'NaN','0','5','10','15','20','25','30','35','40','45'↵
    ↵ , '50','55','60','65','70','75','80','85','90','95','100'};
170 app.R3DropDown.Items = {'NaN','0','5','10','15','20','25','30','35','40','45'↵
    ↵ , '50','55','60','65','70','75','80','85','90','95','100'};
171 app.Z2DropDown.Items = {'NaN','25','30','35','40','45','50','55','60','65','↵
    ↵ 70','75','80','85','90','95','100','105','110','115','120','125'};
172 app.R4DropDown.Items = {'NaN','0','5','10','15','20','25','30','35','40','45'↵
    ↵ , '50','55','60','65','70','75','80','85','90','95','100'};
173 % app.R1DropDown.Enable = 'off';
174 % app.Z1DropDown.Enable = 'off';
175 app.xVariable = app.XAxisDropDown.Value;
176 app.legendVariable = app.LegendDropDown.Value;
177 app.yVariable = @(x) x.Del1;
178 app.xVariable = "x.R1";
179 app.PersonalizedYAxisTextArea.Value = func2str(app.yVariable);
180 app.PersonalizedXAxisTextArea.Value = app.xVariable;
181 estilo = {'-+','-o','-*','-x','-s','-d','-p'};
182 es = repmat(estilo,[3,1]);
183 es = reshape(es,1,[]);
184 set(groot,'defaultAxesLineStyleOrder',es)
185
186 end
187
188 % Value changed function: XAxisDropDown
189 function XAxisDropDownValueChanged(app, event)
190     value = app.XAxisDropDown.Value;
191     app.PersonalizedXAxisTextArea.Editable = 'off';
192     switch value
193     case 'Personalized'
194         app.PersonalizedXAxisTextArea.Editable = "on";
195         app.PersonalizedXAxisTextArea.ValueChanged;
196     otherwise
197         app.xVariable = "x."+string(value);
198     end
199     app.PersonalizedXAxisTextArea.Value = app.xVariable;
200 end
201
202 % Value changed function: LegendDropDown
203 function LegendDropDownValueChanged(app, event)
204     value = app.LegendDropDown.Value;
205     switch value
206     case 'R1'
207         app.R1DropDown.Value = 'NaN';
208         app.r1 = NaN;
209         app.R1DropDown.Enable = 'off';
210     case 'Z1'
211         app.Z1DropDown.Value = 'NaN';
212         app.z1 = NaN;
213         app.Z1DropDown.Enable = 'off';

```

```

214         case 'R2'
215             app.R2DropDown.Value = 'NaN';
216             app.r2 = NaN;
217             app.R2DropDown.Enable = 'off';
218         case 'R3'
219             app.R3DropDown.Value = 'NaN';
220             app.r3 = NaN;
221             app.R3DropDown.Enable = 'off';
222         case 'Z2'
223             app.Z2DropDown.Value = 'NaN';
224             app.z2 = NaN;
225             app.Z2DropDown.Enable = 'off';
226         case 'R4'
227             app.R4DropDown.Value = 'NaN';
228             app.r4 = NaN;
229             app.R4DropDown.Enable = 'off';
230     end
231     switch app.legendVariable
232     case 'R1'
233         app.R1DropDown.Enable = 'on';
234         app.legendVariable = value;
235     case 'Z1'
236         app.Z1DropDown.Enable = 'on';
237         app.legendVariable = value;
238     case 'R2'
239         app.R2DropDown.Enable = 'on';
240         app.legendVariable = value;
241     case 'R3'
242         app.R3DropDown.Enable = 'on';
243         app.legendVariable = value;
244     case 'Z2'
245         app.Z2DropDown.Enable = 'on';
246         app.legendVariable = value;
247     case 'R4'
248         app.R4DropDown.Enable = 'on';
249         app.legendVariable = value;
250     end
251 end
252
253 % Value changed function: YAxisDropDown
254 function YAxisDropDownValueChanged(app, event)
255     value = app.YAxisDropDown.Value;
256     app.PersonalizedYAxisTextArea.Editable = 'off';
257
258     switch value
259     case 'NGD f1'
260         app.yVariable = @(x) x.Del1;
261     case 'NGD fc'
262         app.yVariable = @(x) x.DelC;
263     case 'S21 f1'
264         app.yVariable = @(x) 20*log10(x.S211);

```

```

265         case 'S21 fc'
266             app.yVariable = @(x) 20*log10(x.S21C);
267         case 'BW fl'
268             app.yVariable = @(x) x.iBW12 - x.iBW11;
269         case 'BW fc'
270             app.yVariable = @(x) x.iBW1C - x.iBW1C;
271         case 'f2/f1'
272             app.yVariable = @(x) (2000-x.iDel1)./x.iDel1;
273         case 'S11 fl'
274             app.yVariable = @(x) 20*log10(x.S111);
275         case 'S11 fc'
276             app.yVariable = @(x) 20*log10(x.S11C);
277         case 'S22 fl'
278             app.yVariable = @(x) 20*log10(x.S221);
279         case 'S22 fc'
280             app.yVariable = @(x) 20*log10(x.S22C);
281         case 'Personalized'
282             app.PersonalizedYAxisTextArea.Editable = "on";
283             app.PersonalizedYAxisTextArea.ValueChanged;
284     end
285     app.PersonalizedYAxisTextArea.Value = func2str(app.yVariable);
286 end
287
288 % Button pushed function: PlotButton
289 function PlotButtonPushed(app, event)
290     tic
291     d = uiprogresdlg(app.UIFigure, 'Title','Applying Condition', 'Indeterminate',"on"↵
↵ ");
292     try
293         app.ds.reset;
294         app.tData = parforApplyConditions(app, app.ds);
295         app.ds.reset;
296     catch ME
297         str = sprintf(['Something is wrong with the datastore loaded. \n' 'Matlab ↵
↵ says: \n' ME.message]);
298         uialert(app.UIFigure, str, 'Data Problem');
299     end
300
301     close(d);
302     toc
303     fstr = "@(x)x."+string(app.legendVariable);
304     xCond = str2func("@(x)"+string(app.xVariable));
305     condLegend = str2func(fstr);
306     uniqLegend = unique(condLegend(app.tData));
307     plt = table();
308     fig=figure,
309     hold on;
310     leyenda = {};
311
312     for ii=1:length(uniqLegend)
313         aux = fstr.append(sprintf("==%d",uniqLegend(ii)));

```

```

314         cond = str2func(aux);
315         plt.Y = app.yVariable(app.tData(cond(app.tData),:));
316         plt.X = xCond(app.tData(cond(app.tData),:));
317         pt1 = plot(plt.X,plt.Y);
318         aux = char(aux);
319         leyenda = {leyenda{:},string(aux(7:end))};
320         pt1.DataTipTemplate.DataTipRows(1).Label = app.XAxisDropDown.Value;
321         pt1.DataTipTemplate.DataTipRows(2).Label = app.YAxisDropDown.Value;
322         pt1.DataTipTemplate.DataTipRows(end+1) = dataTipTextRow(app,↵
↵         LegendDropDown.Value, repmat(uniqLegend(ii),size(plt.X)));
323         clearvars plt
324     end
325     leg=legend(leyenda,'Location','bestoutside'),
326     grid("on"),
327     xlabel(app.XAxisDropDown.Value);
328     ylabel(app.YAxisDropDown.Value);
329     title(app.TitleEditField.Value)
330     ann=annotation('textbox', [0, 0.5, 0, 0], 'string', sprintf("R1=%d\nZ1=%d\nR2↵
↵     =%d\nR3=%d\nZ2=%d\nR4=%d",app.r1,app.z1,app.r2,app.r3,app.z2,↵
↵     app.r4),'EdgeColor','k','BackgroundColor','w','Position',[leg.Position(1),↵
↵     leg.Position(2)-0.1,0,0],'FitBoxToText',1);
331     setfigpaper('Width',22,'Interpreter','Latex');
332     ann.Position = [leg.Position(1),leg.Position(2)-ann.Position(4)-0.01,ann.Position↵
↵     (3),ann.Position(4)];
333     % movegui(fig,"center")
334 end
335
336 % Value changed function: R1DropDown
337 function R1DropDownValueChanged(app, event)
338     app.r1 = str2double(app.R1DropDown.Value);
339 end
340
341 % Value changed function: Z1DropDown
342 function Z1DropDownValueChanged(app, event)
343     app.z1 = str2double(app.Z1DropDown.Value);
344 end
345
346 % Value changed function: R2DropDown
347 function R2DropDownValueChanged(app, event)
348     app.r2 = str2double(app.R2DropDown.Value);
349 end
350
351 % Value changed function: R3DropDown
352 function R3DropDownValueChanged(app, event)
353     app.r3 = str2double(app.R3DropDown.Value);
354 end
355
356 % Value changed function: Z2DropDown
357 function Z2DropDownValueChanged(app, event)
358     app.z2 = str2double(app.Z2DropDown.Value);
359 end

```

```

360
361 % Value changed function: R4DropDown
362 function R4DropDownValueChanged(app, event)
363     app.r4 = str2double(app.R4DropDown.Value);
364 end
365
366 % Value changed function: PersonalizedYAxisTextArea
367 function PersonalizedYAxisTextAreaValueChanged(app, event)
368     value = app.PersonalizedYAxisTextArea.Value;
369     try
370         app.yVariable = str2func(value{:});
371     catch ME
372         str = sprintf(['Something is wrong with the Personalized Y Axis. \n' 'Matlab'↵
↵ says: \n' ME.message]);
373         uialert(app.UIFigure, str, 'Sintax Problem');
374     end
375 end
376
377 % Value changed function: PersonalizedXAxisTextArea
378 function PersonalizedXAxisTextAreaValueChanged(app, event)
379     value = app.PersonalizedXAxisTextArea.Value;
380     try
381         app.xVariable = string(value{:});
382     catch ME
383         str = sprintf(['Something is wrong with the Personalized Y Axis. \n' 'Matlab'↵
↵ says: \n' ME.message]);
384         uialert(app.UIFigure, str, 'Sintax Problem');
385     end
386 end
387
388 % Button pushed function: OpenButton
389 function OpenButtonPushed(app, event)
390     folderpath = uigetdir;
391     d = uiprogessdlg(app.UIFigure, 'Title','Loading Data', 'Indeterminate',"on");
392     try
393         app.ds = datastore(folderpath);
394         app.ds.reset;
395         app.FolderPathEditField.Value = folderpath;
396     catch ME
397         str = sprintf(['Something is wrong with the datastore loaded. \n' 'Matlab'↵
↵ says: \n' ME.message]);
398         uialert(app.UIFigure, str, 'Load Problem');
399     end
400     close(d);
401 end
402
403 % Button pushed function: ApplyConditionButton
404 function ApplyConditionButtonPushed(app, event)
405     tic
406     d = uiprogessdlg(app.UIFigure, 'Title','Applying Condition', 'Indeterminate',"on"↵
↵ ");

```

```

407         try
408             app.ds.reset;
409             app.tData = parforApplyCondition(app, app.ds, app.condData);
410             % app.tData = tall(app.ds);
411             % app.tData = app.tData(app.condData(app.tData),:);
412             app.ds.reset;
413         catch ME
414             str = sprintf(['Something is wrong with the datastore loaded. \n' 'Matlab ↩↪
415                 ↩↪ says: \n' ME.message]);
416             uialert(app.UIFigure, str, 'Data Problem');
417         end
418     close(d);
419     toc
420 end
421 end
422
423 % Component initialization
424 methods (Access = private)
425
426     % Create UIFigure and components
427     function createComponents(app)
428
429         % Create UIFigure and hide until all components are created
430         app.UIFigure = uifigure('Visible', 'off');
431         app.UIFigure.AutoResizeChildren = 'off';
432         app.UIFigure.Position = [100 100 640 486];
433         app.UIFigure.Name = 'UI Figure';
434
435         % Create GridLayout
436         app.GridLayout = uigridlayout(app.UIFigure);
437         app.GridLayout.RowHeight = {'1x'};
438         app.GridLayout.ColumnSpacing = 0;
439         app.GridLayout.RowSpacing = 0;
440         app.GridLayout.Padding = [0 0 0 0];
441         app.GridLayout.Scrollable = 'on';
442
443         % Create LeftPanel
444         app.LeftPanel = uipanel(app.GridLayout);
445         app.LeftPanel.AutoResizeChildren = 'off';
446         app.LeftPanel.Layout.Row = 1;
447         app.LeftPanel.Layout.Column = 1;
448
449         % Create OpenButton
450         app.OpenButton = uibutton(app.LeftPanel, 'push');
451         app.OpenButton.ButtonPushedFcn = createCallbackFcn(app, @↩↪
452             ↩↪ OpenButtonPushed, true);
453         app.OpenButton.Position = [249 368 40 22];
454         app.OpenButton.Text = 'Open';
455
456         % Create FolderPathEditFieldLabel

```

```

456 app.FolderPathEditFieldLabel = uilabel(app.LeftPanel);
457 app.FolderPathEditFieldLabel.HorizontalAlignment = 'right';
458 app.FolderPathEditFieldLabel.Position = [48 368 67 22];
459 app.FolderPathEditFieldLabel.Text = 'Folder Path';
460
461 % Create FolderPathEditField
462 app.FolderPathEditField = uieditfield(app.LeftPanel, 'text');
463 app.FolderPathEditField.Editable = 'off';
464 app.FolderPathEditField.Position = [139 368 100 22];
465
466 % Create ApplyConditionButton
467 app.ApplyConditionButton = uibutton(app.LeftPanel, 'push');
468 app.ApplyConditionButton.ButtonPushedFcn = createCallbackFcn(app, @↵
    ↵ ApplyConditionButtonPushed, true);
469 app.ApplyConditionButton.Position = [189 123 100 22];
470 app.ApplyConditionButton.Text = 'Apply Condition';
471
472 % Create DataConditionDropDownLabel
473 app.DataConditionDropDownLabel = uilabel(app.LeftPanel);
474 app.DataConditionDropDownLabel.HorizontalAlignment = 'right';
475 app.DataConditionDropDownLabel.Position = [30 287 85 22];
476 app.DataConditionDropDownLabel.Text = 'Data Condition';
477
478 % Create DataConditionDropDown
479 app.DataConditionDropDown = uidropdown(app.LeftPanel);
480 app.DataConditionDropDown.Position = [139 287 150 22];
481
482 % Create PersonalizedDataConditionTextAreaLabel
483 app.PersonalizedDataConditionTextAreaLabel = uilabel(app.LeftPanel);
484 app.PersonalizedDataConditionTextAreaLabel.HorizontalAlignment = 'right';
485 app.PersonalizedDataConditionTextAreaLabel.Position = [30 244 85 27];
486 app.PersonalizedDataConditionTextAreaLabel.Text = {'Personalized'; 'Data ↵
    ↵ Condition'};
487
488 % Create PersonalizedDataConditionTextArea
489 app.PersonalizedDataConditionTextArea = uitextarea(app.LeftPanel);
490 app.PersonalizedDataConditionTextArea.Editable = 'off';
491 app.PersonalizedDataConditionTextArea.Position = [139 213 150 60];
492
493 % Create RightPanel
494 app.RightPanel = uipanel(app.GridLayout);
495 app.RightPanel.AutoResizeChildren = 'off';
496 app.RightPanel.Layout.Row = 1;
497 app.RightPanel.Layout.Column = 2;
498
499 % Create PlotButton
500 app.PlotButton = uibutton(app.RightPanel, 'push');
501 app.PlotButton.ButtonPushedFcn = createCallbackFcn(app, @PlotButtonPushed↵
    ↵ , true);
502 app.PlotButton.Position = [175 24 100 22];
503 app.PlotButton.Text = 'Plot!';

```

```

504
505 % Create R1DropDownLabel
506 app.R1DropDownLabel = uilabel(app.RightPanel);
507 app.R1DropDownLabel.HorizontalAlignment = 'right';
508 app.R1DropDownLabel.Position = [57 213 25 22];
509 app.R1DropDownLabel.Text = 'R1';
510
511 % Create R1DropDown
512 app.R1DropDown = uidropdown(app.RightPanel);
513 app.R1DropDown.Items = {'NaN'};
514 app.R1DropDown.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app, @↵
    ↵ R1DropDownValueChanged, true);
515 app.R1DropDown.Position = [97 213 65 22];
516 app.R1DropDown.Value = 'NaN';
517
518 % Create Z1DropDownLabel
519 app.Z1DropDownLabel = uilabel(app.RightPanel);
520 app.Z1DropDownLabel.HorizontalAlignment = 'right';
521 app.Z1DropDownLabel.Position = [57 129 25 22];
522 app.Z1DropDownLabel.Text = 'Z1';
523
524 % Create Z1DropDown
525 app.Z1DropDown = uidropdown(app.RightPanel);
526 app.Z1DropDown.Items = {'NaN'};
527 app.Z1DropDown.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app, @↵
    ↵ Z1DropDownValueChanged, true);
528 app.Z1DropDown.Position = [97 129 65 22];
529 app.Z1DropDown.Value = 'NaN';
530
531 % Create R2DropDownLabel
532 app.R2DropDownLabel = uilabel(app.RightPanel);
533 app.R2DropDownLabel.HorizontalAlignment = 'right';
534 app.R2DropDownLabel.Position = [57 171 25 22];
535 app.R2DropDownLabel.Text = 'R2';
536
537 % Create R2DropDown
538 app.R2DropDown = uidropdown(app.RightPanel);
539 app.R2DropDown.Items = {'NaN'};
540 app.R2DropDown.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app, @↵
    ↵ R2DropDownValueChanged, true);
541 app.R2DropDown.Position = [97 171 65 22];
542 app.R2DropDown.Value = 'NaN';
543
544 % Create R3DropDownLabel
545 app.R3DropDownLabel = uilabel(app.RightPanel);
546 app.R3DropDownLabel.HorizontalAlignment = 'right';
547 app.R3DropDownLabel.Position = [170 213 25 22];
548 app.R3DropDownLabel.Text = 'R3';
549
550 % Create R3DropDown
551 app.R3DropDown = uidropdown(app.RightPanel);

```

```

552     app.R3DropDown.Items = {'NaN'};
553     app.R3DropDown.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app, @↵
        ↵ R3DropDownValueChanged, true);
554     app.R3DropDown.Position = [210 213 65 22];
555     app.R3DropDown.Value = 'NaN';
556
557     % Create Z2DropDownLabel
558     app.Z2DropDownLabel = uilabel(app.RightPanel);
559     app.Z2DropDownLabel.HorizontalAlignment = 'right';
560     app.Z2DropDownLabel.Position = [170 171 25 22];
561     app.Z2DropDownLabel.Text = 'Z2';
562
563     % Create Z2DropDown
564     app.Z2DropDown = uidropdown(app.RightPanel);
565     app.Z2DropDown.Items = {'NaN'};
566     app.Z2DropDown.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app, @↵
        ↵ Z2DropDownValueChanged, true);
567     app.Z2DropDown.Position = [210 171 65 22];
568     app.Z2DropDown.Value = 'NaN';
569
570     % Create R4DropDownLabel
571     app.R4DropDownLabel = uilabel(app.RightPanel);
572     app.R4DropDownLabel.HorizontalAlignment = 'right';
573     app.R4DropDownLabel.Position = [170 129 25 22];
574     app.R4DropDownLabel.Text = 'R4';
575
576     % Create R4DropDown
577     app.R4DropDown = uidropdown(app.RightPanel);
578     app.R4DropDown.Items = {'NaN'};
579     app.R4DropDown.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app, @↵
        ↵ R4DropDownValueChanged, true);
580     app.R4DropDown.Position = [210 129 65 22];
581     app.R4DropDown.Value = 'NaN';
582
583     % Create YAxisDropDownLabel
584     app.YAxisDropDownLabel = uilabel(app.RightPanel);
585     app.YAxisDropDownLabel.HorizontalAlignment = 'right';
586     app.YAxisDropDownLabel.Position = [62 414 39 22];
587     app.YAxisDropDownLabel.Text = 'Y Axis';
588
589     % Create YAxisDropDown
590     app.YAxisDropDown = uidropdown(app.RightPanel);
591     app.YAxisDropDown.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app, @↵
        ↵ YAxisDropDownValueChanged, true);
592     app.YAxisDropDown.Position = [125 414 150 22];
593
594     % Create XAxisDropDownLabel
595     app.XAxisDropDownLabel = uilabel(app.RightPanel);
596     app.XAxisDropDownLabel.HorizontalAlignment = 'right';
597     app.XAxisDropDownLabel.Position = [62 336 39 22];
598     app.XAxisDropDownLabel.Text = 'X Axis';

```

```

599
600 % Create XAxisDropDown
601 app.XAxisDropDown = uidropdown(app.RightPanel);
602 app.XAxisDropDown.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app, @↵
    ↵ XAxisDropDownValueChanged, true);
603 app.XAxisDropDown.Position = [125 336 150 22];
604
605 % Create LegendDropDownLabel
606 app.LegendDropDownLabel = uilabel(app.RightPanel);
607 app.LegendDropDownLabel.HorizontalAlignment = 'right';
608 app.LegendDropDownLabel.Position = [55 260 46 22];
609 app.LegendDropDownLabel.Text = 'Legend';
610
611 % Create LegendDropDown
612 app.LegendDropDown = uidropdown(app.RightPanel);
613 app.LegendDropDown.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app, @↵
    ↵ LegendDropDownValueChanged, true);
614 app.LegendDropDown.Position = [125 260 150 22];
615
616 % Create PersonalizedYAxisLabel
617 app.PersonalizedYAxisLabel = uilabel(app.RightPanel);
618 app.PersonalizedYAxisLabel.HorizontalAlignment = 'right';
619 app.PersonalizedYAxisLabel.Position = [26 380 75 27];
620 app.PersonalizedYAxisLabel.Text = {'Personalized'; 'Y Axis'};
621
622 % Create PersonalizedYAxisTextArea
623 app.PersonalizedYAxisTextArea = uitextarea(app.RightPanel);
624 app.PersonalizedYAxisTextArea.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app, @↵
    ↵ PersonalizedYAxisTextAreaValueChanged, true);
625 app.PersonalizedYAxisTextArea.Position = [125 376 150 33];
626
627 % Create PersonalizedXAxisTextAreaLabel
628 app.PersonalizedXAxisTextAreaLabel = uilabel(app.RightPanel);
629 app.PersonalizedXAxisTextAreaLabel.HorizontalAlignment = 'right';
630 app.PersonalizedXAxisTextAreaLabel.Position = [26 298 75 27];
631 app.PersonalizedXAxisTextAreaLabel.Text = {'Personalized'; 'X Axis'};
632
633 % Create PersonalizedXAxisTextArea
634 app.PersonalizedXAxisTextArea = uitextarea(app.RightPanel);
635 app.PersonalizedXAxisTextArea.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app, @↵
    ↵ PersonalizedXAxisTextAreaValueChanged, true);
636 app.PersonalizedXAxisTextArea.Position = [125 294 150 33];
637
638 % Create TitleEditFieldLabel
639 app.TitleEditFieldLabel = uilabel(app.RightPanel);
640 app.TitleEditFieldLabel.HorizontalAlignment = 'right';
641 app.TitleEditFieldLabel.Position = [74 73 27 22];
642 app.TitleEditFieldLabel.Text = 'Title';
643
644 % Create TitleEditField
645 app.TitleEditField = uieditfield(app.RightPanel, 'text');

```

```
646         app.TitleEditField.Position = [125 73 150 22];
647         app.TitleEditField.Value = 'Modelo 1';
648
649         % Show the figure after all components are created
650         app.UIFigure.Visible = 'on';
651     end
652 end
653
654 % App creation and deletion
655 methods (Access = public)
656
657     % Construct app
658     function app = designChartsMod1
659
660         % Create UIFigure and components
661         createComponents(app)
662
663         % Register the app with App Designer
664         registerApp(app, app.UIFigure)
665
666         % Execute the startup function
667         runStartupFcn(app, @startupFcn)
668
669         if nargin == 0
670             clear app
671         end
672     end
673
674 % Code that executes before app deletion
675 function delete(app)
676
677     % Delete UIFigure when app is deleted
678     delete(app.UIFigure)
679 end
680 end
681 end
```

E. Códigos Python

Código E.1: Script para el cálculo del Modelo 1

```
1 import numpy as np
2 import myFunctions as my
3 from datetime import datetime
4 import os
5 import time
6 import itertools as it
7 import multiprocessing
8 import scipy.io as sc
9
10 foldername = "Mod1"
11 lenRZ = 21
12 nZeros = 2
13
14 R1 = np.linspace(0, 100, num=lenRZ)
15 R2 = np.linspace(0, 100, num=lenRZ)
16 R3 = np.linspace(0, 100, num=lenRZ)
17 R4 = np.linspace(0, 100, num=lenRZ)
18
19 Z1 = np.linspace(25, 125, num=lenRZ)
20 Z2 = np.linspace(25, 125, num=lenRZ)
21
22 lenfn = 2001
23 fn = np.linspace(0, 2, num=lenfn)
24 if nZeros == 1:
25     fn = fn[0:1000]
26     lenfn = fn.size
27 elif nZeros == 2:
28     fn = fn[0:1201]
29     lenfn = fn.size
30 # 0 - 999 --> 1 zero
31 # 900 - 1200 --> 2 zeros
32 # 1001 - end --> 3 zeros
33
34 z0 = 50
35 f0 = 1e9
36
37 f = f0 * fn
38
39 xRange = range(lenRZ)
40
41
42 def calcular(counter):
43     t = time.time()
44     DATA = list()
45     ERRORES = list()
46     m = np.array(counter)[0]
47     n = np.array(counter)[1]
48     # for m in x21: # R1
49     # for n in x21: # Z1
50     for o in xRange: # R2
51         for p in xRange: # R3
```

```

52     for q in xrange: # Z2
53         for r in xrange: # R4
54             SS11, SS12, SS21, SS22 = my.fCalcSPMod1(R1[m], Z1[n], R2[o], R3[p], Z2[q], R4[r], z0, fn)
55             group_delay = -(np.diff(my.unwrap(np.angle(SS21), np.pi)) / np.diff(f)) / (2 * np.pi)
56             iDel, Del, S21, S11, S22, iBW, iBW1dB, iBW3dB, err = my.getMeasures(nZeros, ↵
                    ↵ group_delay, SS21, SS11,
57                                     SS22)
58             if any(err):
59                 errores = np.concatenate(([R1[m]], [Z1[n]], [R2[o]], [R3[p]], [Z2[q]], [R4[r]], err))
60                 ERRORES.append(errores)
61
62             datos = np.concatenate(([R1[m]], [Z1[n]], [R2[o]], [R3[p]], [Z2[q]], [R4[r]],
63                                     iDel, Del, S21, S11, S22, iBW3dB, iBW1dB, iBW))
64             DATA.append(datos)
65             # end r -> R4
66             # end q -> Z2
67             # end p -> R3
68             # end o -> R2
69             # end n -> Z1
70             # end m -> R1
71             elapsed = time.time() - t
72             t2 = time.time()
73             filename = str(int(R1[m])).zfill(3) + "R1" + str(
74                 int(Z1[n]).zfill(3) + "Z1.mat"
75             )
76             sc.savemat(foldername + "/" + filename, {'data': DATA}, do_compression=True)
77             sc.savemat(foldername + "_errors" + "/" + "errors_" + filename, {'errors': ERRORES}, do_compression↵
                    ↵ =True)
78             elapsed2 = time.time() - t2
79             elapsed3 = time.time() - t
80             print("Archivo " + filename + " creado." +
81                   " [" + datetime.now().strftime('%H:%M:%S.%f')[:-4] + "]" | Bucle = " + str(elapsed) + " Guardado ↵
                    ↵ = " + str(
82                 elapsed2) + " Total = " + str(elapsed3))
83             return
84
85 if __name__ == "__main__":
86
87     print("Comienzo de ejecución. [" +
88           datetime.now().strftime('%H:%M:%S.%f')[:-4] + "]"")
89     aux = list()
90     if not os.path.exists(foldername + "_errors"):
91         os.makedirs(foldername + "_errors")
92     if not os.path.exists(foldername):
93         os.makedirs(foldername)
94     else:
95         files = os.listdir(foldername)
96         for file in files:
97             r1 = int(file[0:3])
98             z1 = int(file[5:8])
99             aux.append((int(np.where(R1 == r1)[0]), int(np.where(Z1 == z1)[0])))
100     t = time.time()
101     M = list(xrange)
102     N = list(xrange)
103     contador = list(it.product(M, N))
104     for elem in aux:
105         contador.remove(elem)
106     # end
107     print(str(np.shape(contador)[0]) + " casos a computar con " + str(multiprocessing.cpu_count()) + " nú↵
            ↵ cleos.")
108     p = multiprocessing.Pool(multiprocessing.cpu_count())
109     p.map(calcular, contador)
110     p.close()
111     p.join()

```

```

112 elapsed = time.time() - t
113 print("Proceso completo! [" +
114       datetime.now().strftime("%H:%M:%S.%f")[:-4] + "]")
115 units = " (s)"
116 if elapsed > 60:
117     elapsed = elapsed / 60
118     units = " (min)"
119 if elapsed > 60:
120     elapsed = elapsed / 60
121     units = " (horas)"
122 print("Duración total: " + str(elapsed) + units)

```

Código E.2: Función de cálculo de los parámetros S del Modelo 1

```

1 import numpy as np
2 import warnings
3 def fCalcSPMod1(r1, z1, r2, r3, z2, r4, z0, fn):
4     warnings.filterwarnings("ignore")
5     y1 = 1 / z1 if (z1 != 0) else 0
6     y2 = 1 / z2 if (z2 != 0) else 0
7
8     y0 = 1 / z0 if (z0 != 0) else 0
9     lenfn = fn.size
10
11     THETA1A = np.pi * fn
12     THETA2A = 2 * np.pi * fn
13     R1 = np.array([[1, r1], [0, 1]])
14     R2 = np.array([[1, r2], [0, 1]])
15     R3 = np.array([[1, r3], [0, 1]])
16     R4 = np.array([[1, r4], [0, 1]])
17     R1 = np.tile(R1, (lenfn, 1, 1))
18     R2 = np.tile(R2, (lenfn, 1, 1))
19     R3 = np.tile(R3, (lenfn, 1, 1))
20     R4 = np.tile(R4, (lenfn, 1, 1))
21     TL1 = np.stack([np.stack([np.cos(THETA1A), 1j * z1 * np.sin(THETA1A)], axis=-1),
22                     np.stack([1j * y1 * np.sin(THETA1A), np.cos(THETA1A)], axis=-1)], axis=1)
23     TL2 = np.stack([np.stack([np.cos(THETA2A), 1j * z2 * np.sin(THETA2A)], axis=-1),
24                     np.stack([1j * y2 * np.sin(THETA2A), np.cos(THETA2A)], axis=-1)], axis=1)
25     PATH1 = R1 @ TL1 @ R2
26     PATH2 = R3 @ TL2 @ R4
27     warnings.filterwarnings("default")
28     return fPath2SP(PATH1, PATH2, y0)

```

Código E.3: Función para el cálculo de la matriz SP equivalente de una red de dos ramas en paralelo

```

1 import numpy as np
2 import warnings
3 def fPath2SP(PATH1, PATH2, y0):
4     warnings.filterwarnings("ignore")
5     A1 = PATH1[:, 0, 0]
6     B1 = PATH1[:, 0, 1]
7     C1 = PATH1[:, 1, 0]
8     D1 = PATH1[:, 1, 1]
9     A2 = PATH2[:, 0, 0]
10    B2 = PATH2[:, 0, 1]
11    C2 = PATH2[:, 1, 0]
12    D2 = PATH2[:, 1, 1]
13    Y_path1 = np.stack(
14        [np.stack([(D1 / B1), ((B1 * C1 - A1 * D1) / (B1))], axis=-1), np.stack([(1 / B1), (A1 / B1)], axis=-1)],
15        axis=1)
16    Y_path2 = np.stack(

```

```

17     [np.stack([(D2 / B2), ((B2 * C2 - A2 * D2) / (B2))], axis=-1), np.stack([(-1 / B2), (A2 / B2)], axis=
    ↪ ↪ =-1)],
18     axis=1)
19     Y = Y_path1 + Y_path2
20     Y11 = Y[:, 0, 0]
21     Y12 = Y[:, 0, 1]
22     Y21 = Y[:, 1, 0]
23     Y22 = Y[:, 1, 1]
24     deltaY = (Y11 + y0) * (Y22 + y0) - Y12 * Y21
25     S11 = ((y0 - Y11) * (y0 + Y22) + Y12 * Y21) / (deltaY)
26     S12 = (-2 * Y12 * y0) / (deltaY)
27     S21 = (-2 * Y21 * y0) / (deltaY)
28     S22 = ((y0 + Y11) * (y0 - Y22) + Y12 * Y21) / (deltaY)
29     warnings.filterwarnings("default")
30     return S11, S12, S21, S22

```

Código E.4: Adaptación de la función unwrap de la librería numpy para valores NaN (not a number)

```

1 import numpy as np
2 def unwrap(q, phase):
3     # Find NaN's and Inf's
4     p = q
5     indf = np.isfinite(p)
6     # Unwrap finite data (skip non finite entries)
7     q[indf] = np.unwrap(p[indf], phase)
8     return q

```

Código E.5: Funciones de procesamiento de señal para caracterizar la respuesta

```

1 def getLocalZero(delay):
2     # Return the local minimum avoiding widths < 1 (maths indeterminacy) and positive delays
3     # If out is positive -> Unique or widest and minimum point
4     # If out is negative -> Minimum point but not the widest
5     # If out is NaN -> No Local Minimum found
6     localZero = np.NaN
7     peaks, prop = find_peaks(-delay, width=(None, None))
8     wdt = prop["widths"]
9     erridx = (wdt >= 2) & (delay[peaks] < 0)
10    peaks = peaks[erridx]
11    if peaks.size == 1:
12        localZero = peaks[0]
13    elif peaks.size > 1:
14        idxW = np.argmax(wdt)
15        idxP = np.argmin(delay[peaks])
16        if idxW == idxP:
17            localZero = peaks[idxP]
18        else:
19            localZero = -peaks[idxP]
20    return localZero
21
22
23 def getNZeros(nZeros, delay):
24     iDel = np.repeat(np.NaN, nZeros)
25     iDel[0] = getLocalZero(delay[0:999])
26     if nZeros >= 2:
27         idel = getLocalZero(delay[900:1200])
28         iDel[1] = idel + 900 if idel >= 0 else idel - 900
29     if nZeros == 3:
30         idel = getLocalZero(delay[1001:-1])
31         iDel[2] = idel + 1001 if idel >= 0 else idel - 1001
32     return iDel
33

```

```

34
35 def getMeasures(nZeros, delay, SS21, SS11, SS22):
36     warnings.filterwarnings("ignore", message="invalid value encountered in ")
37     warnings.filterwarnings("ignore", message="divide by zero encountered in ")
38     # Get NGD indexes
39     iDel = getNZeros(nZeros, delay)
40     # NGD array for NGD Values
41     Del = np.repeat(np.NaN, nZeros)
42     # Desired S-Parameters
43     S21 = np.repeat(np.NaN, nZeros)
44     S11 = np.repeat(np.NaN, nZeros)
45     S22 = np.repeat(np.NaN, nZeros)
46     # 3 desired bandwidths
47     iBW = np.repeat(np.NaN, 2 * nZeros)
48     iBW1dB = np.repeat(np.NaN, 2 * nZeros)
49     iBW3dB = np.repeat(np.NaN, 2 * nZeros)
50     S21dB = 20 * np.log10(abs(SS21))
51     # Auxiliar for errors
52     err = np.repeat(0, nZeros)
53     for nn, idel in enumerate(iDel):
54         if not np.isnan(idel):
55             if idel >= 0:
56                 Del[nn] = delay[int(idel)]
57                 S21[nn] = np.abs(SS21[int(idel)])
58                 S11[nn] = np.abs(SS11[int(idel)])
59                 S22[nn] = np.abs(SS22[int(idel)])
60             else:
61                 iDel[nn] = np.abs(idel)
62                 Del[nn] = delay[int(iDel[nn])]
63                 S21[nn] = np.abs(SS21[int(iDel[nn])])
64                 S11[nn] = np.abs(SS11[int(iDel[nn])])
65                 S22[nn] = np.abs(SS22[int(iDel[nn])])
66                 err[nn] = -1
67
68     # NGD BANDWIDTH -> iBW
69     # Find positive delays at the left side of NGD point
70     aux = np.nonzero(delay[0:int(iDel[nn])] >= 0)
71     if aux.size > 0:
72         # Save last positive delay
73         iBW[2 * nn] = aux[-1]
74     # Find positive delay at the right side of NGD point
75     aux = np.nonzero(delay[int(iDel[nn]):] >= 0)
76     if aux.size > 0:
77         # Save first positive delay
78         iBW[2 * nn + 1] = aux[0] + int(iDel[nn])
79
80     # 1DB BANDWIDTH -> iBW1dB
81     aux = np.nonzero(
82         (S21dB[0:int(iDel[nn])] >= S21dB[int(iDel[nn])] + 1) | (
83             S21dB[0:int(iDel[nn])] <= S21dB[int(iDel[nn])] - 1))
84     if aux.size > 0:
85         iBW1dB[2 * nn] = aux[-1]
86     aux = np.nonzero(
87         (S21dB[int(iDel[nn]):-1] >= S21dB[int(iDel[nn])] + 1) | (
88             S21dB[int(iDel[nn]):-1] <= S21dB[int(iDel[nn])] - 1))
89     if aux.size > 0:
90         iBW1dB[2 * nn + 1] = aux[0] + int(iDel[nn])
91
92     # 3DB BANDWIDTH -> iBW3dB
93     aux = np.nonzero(
94         (S21dB[0:int(iDel[nn])] >= S21dB[int(iDel[nn])] + 3) | (
95             S21dB[0:int(iDel[nn])] <= S21dB[int(iDel[nn])] - 3))
96     if aux.size > 0:
97         iBW3dB[2 * nn] = aux[-1]

```

```
98     aux, = np.nonzero(  
99         (S21dB[int(iDel[nn]):-1] >= S21dB[int(iDel[nn])] + 3) | (  
100             S21dB[int(iDel[nn]):-1] <= S21dB[int(iDel[nn])] - 3))  
101     if aux.size > 0:  
102         iBW3dB[2 * nn + 1] = aux[0] + int(iDel[nn])  
103     else:  
104         err[nn] = 1  
105 warnings.filterwarnings("default")  
106 return iDel, Del, S21, S11, S22, iBW, iBW1dB, iBW3dB, err
```
